

การออกแบบหม้อแปลงความถี่สูงแบบฟลายแบ็ค

**FLYBACK HIGH FREQUENCY TRANSFORMER DESIGN**

นายปรมินทร์ ตื้อคำ รหัส 51382303  
นายอนุรักษ์ เมืองวงศ์ รหัส 51384109



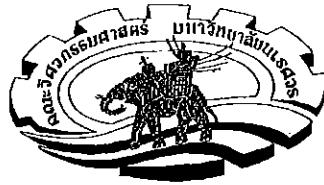
ที่เบอร์ ก.๒๖๘ ถนนกาญจนบพิมาน กรุงเทพฯ สคร.
วันที่รับ..... ๔ ส.ค. ๒๕๕๕
เลขทะเบียน..... ๑๖๐๖๗๘๘๘
เลขที่ยกหักชื่อ..... ๒๙๑
มหาวิทยาลัยนเรศวร ๕๑๖๙ ๒๕๓๔

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปีการศึกษา ๒๕๕๔



## ใบรับรองปริญญานิพนธ์

ชื่อหัวข้อโครงการ การออกแบบหน้าแปลงความถี่สูงแบบฟลายแบค  
ผู้ดำเนินโครงการ นายปริญนทร์ ตีอคำ รหัส 51382303  
นายอนุรักษ์ เมืองวงศ์ รหัส 51384109  
ที่ปรึกษาโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมพร เรืองศินขัชวนิช  
สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า  
ภาควิชา วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์  
ปีการศึกษา 2554

คณะกรรมการศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร อนุมัติให้บัณฑิตนี้เป็นส่วนหนึ่ง  
ของการศึกษาตามหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

.....ที่ปรึกษาโครงการ  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมพร เรืองศินขัชวนิช)

.....กรรมการ  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุชาติ แย้มเมือง)

.....กรรมการ  
(ดร. อัครพันธ์ วงศ์กังแท)

<b>ชื่อหัวข้อโครงการ</b>	การออกแบบหน้าจอเปลี่ยนความถี่สูงแบบฟล้ายแบค
<b>ผู้ดำเนินโครงการ</b>	นายปริมินทร์ ตื้อคำ รหัส 51382303 นายอนุรักษ์ เมืองวงศ์ รหัส 51384109
<b>ที่ปรึกษาโครงการ</b>	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมพร เรืองศินชัยวนิช
<b>สาขาวิชา</b>	วิศวกรรมไฟฟ้า
<b>ภาควิชา</b>	วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
<b>ปีการศึกษา</b>	2554

---

### บทคัดย่อ

ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้นำเสนอโครงการออกแบบ ทดสอบ และพัฒนาหน้าจอเปลี่ยนความถี่สูงสำหรับแหล่งจ่ายสวิตซิ่งแบบฟล้ายแบค ที่พิกัดความถี่ 50 กิโลเฮิรตซ์ พิกัดกำลังเอาต์พุต 45 วัตต์ พิกัดแรงดันเอาต์พุต 36 โวลต์ และพิกัดกระแส 1.25 แอมป์ ประกอบในชุดคอนเวอร์เตอร์ของวงจรอัคปะรุ่บเดอร์ที่ใช้กันแรกคันไฟสลับ 220 V ความถี่ 50 เฮิรตซ์ มีการออกแบบขั้นตอน ของหน้าจอเปลี่ยนความถี่สูงแบบฟล้ายแบคออกเป็น 3 ชุดคือ บคลวคปฐมภูมิ ( $N_p$ ) บคลวคทุติภูมิ ( $N_t$ ) และบคลวคช่วง ( $N_c$ ) จากการออกแบบ สร้าง และทดสอบเบื้องต้นเห็นได้ว่าการพัฒนาหน้าจอเปลี่ยนความถี่สูงแบบฟล้ายแบค มีประสิทธิภาพสูงขึ้นและใช้งานได้จริง

<b>Project title</b>	Fly Back High Frequency Transformer Design		
<b>Name</b>	Mr. Poramin	Trekam	ID. 51382303
	Mr. Anurak	Muangwong	ID. 51384109
<b>Project advisor</b>	Assistant Professor Somporn Ruangsinchaiwanich, Ph.D.		
<b>Major</b>	Electrical Engineering		
<b>Department</b>	Electrical and Computer Engineering		
<b>Academic year</b>	2011		

---

### Abstract

This thesis presented the design and development projects for power transformers, fly back high frequency switching and green bag. The range of frequency was 50 kHz, rated of power output 45 watts, rated of output voltage 36 V and current rating 1.25 amps. The series converter circuit charge the battery used the voltage 220 V, of frequency was 50 Hz. The winding of the transformers, fly back high frequency transformers was designed into three sets include primary coil ( $N_p$ ), coil secondary ( $N_s$ ), and the coil help ( $N_r$ ). The result showed the fly back high frequency transformers was highly effectiveness and practically.

## กิตติกรรมประกาศ

โครงการนี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาอย่างยิ่งจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมพร เรืองสินชัยวานิช ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ และให้ความกรุณาในการทำงานเปรียญฯ นิพนธ์ คณะผู้ดำเนินโครงการขอทราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงและขอระลึกถึงความกรุณาของท่านไว้ตลอดไป

ขอขอบคุณคณาจารย์ทุกท่านที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้กับคณะผู้ดำเนินงาน นอกจากนี้ยังต้องขอขอบคุณภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ที่ให้ยืมอุปกรณ์ และเครื่องมือวัสดุใช้งาน จนทำให้โครงการนี้สำเร็จลุล่วงไปได้

ขอขอบคุณ พี่พัชรธร อ้อมหวาน พี่เกรียงศักดิ์ ไกรกิจรายภูร์ และพี่บุญญฤทธิ์ วงศอน ที่ให้ความช่วยเหลือและคำแนะนำในการทำโครงการนั้นแล้วเสร็จ

เห็นอีสิ่งอื่นใด คณะผู้ดำเนินโครงการขอทราบขอบพระคุณของบิรา มาตรา ผู้นำความรักความเมตตา สติปัญญา รวมทั้งเป็นผู้ให้ทุกสิ่งทุกอย่างด้วยตัวเอง แต่วัยเยาว์จوانจังถึงปัจจุบัน คงเป็นกำลังใจทำให้ได้รับความสำเร็จอย่างตลอดมาทุกวันนี้ และขอขอบคุณทุกๆ กนในครอบครัวของ คณะผู้ดำเนินโครงการที่ไม่ได้กล่าวไว้ ณ ที่นี้ด้วย

นายปริมนทร์ ตื้อคำ  
นายอนุรักษ์ เมืองวงศ์

# สารบัญ

หน้า

ใบรับรองปริญญาบัณฑิต ..... ก
บทคัดย่อ ..... ก
Abstract ..... ก
กิตติกรรมประกาศ ..... ก
สารบัญ ..... ก
สารบัญตาราง ..... ก
สารบัญรูป ..... ก
สารบัญรูป ..... ก
บทที่ 1 บทนำ ..... 1
1.1 ที่มาและความสำคัญของโครงการ ..... 1
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ ..... 1
1.3 ขอบเขตของโครงการ ..... 1
1.4 ขั้นตอนและแผนการดำเนินงาน ..... 2
1.5 ประโยชน์ที่รับจากโครงการ ..... 2
1.6 งบประมาณ ..... 2
บทที่ 2 หลักการออกแบบหน้าจอแสดงความถี่สูงแบบฟลายเบค ..... 3
2.1 หน้าจอแสดงความถี่สูงแบบฟลายเบค ..... 3
2.1.1 ส่วนประกอบของหน้าจอแสดงความถี่สูงแบบฟลายเบค ..... 3
2.1.2 แกนเฟอร์ไรต์และการเลือกใช้ ..... 4
2.1.3 ความสัมพันธ์ระหว่างชคปฐมภูมิและชคทุติยภูมิ ..... 10
2.1.4 การพัฒนาควบคุมทองแดงและการกำหนดของขคควบคุม ..... 12
2.1.5 อุณหภูมิของหน้าจอแสดงความถี่สูงแบบฟลายเบค ..... 28
2.1.6 จากกัน RFI และ EMI ..... 29

## สารบัญ(ต่อ)

หน้า	
2.1.7 การออกแบบหน้าจอแสดงความถี่สูงให้มีความปลอดภัย .....	32
2.2 หลักการทำงานของคอนเวอร์เตอร์ .....	34
2.3 คอนเวอร์เตอร์แบบฟลายแบค.....	39
2.3.1 คุณลักษณะของคอนเวอร์เตอร์แบบฟลายแบค .....	39
2.3.2 การทำงานของคอนเวอร์เตอร์แบบฟลายแบค.....	39
2.3.3 ลักษณะกระแสและแรงดันภายในวงจร .....	40
2.3.4 การทำงานในโหมดกระแสต่อเนื่องและโหมดกระแสไม่ต่อเนื่อง .....	42
2.3.5 การออกแบบคอนเวอร์เตอร์แบบฟลายแบคที่โหมดกระแสไม่ต่อเนื่อง.....	42
2.3.6 ช่วงเวลาดำเนินกระแสสูงสุด ( $t_{on(max)}$ ) .....	43
2.3.7 กำหนดค่าความหนาแน่นของขดลวดปั๊มภูมิ $L_p$ .....	44
2.3.8 จำนวนรอบของขดลวดปั๊มภูมิ $N_p$ และจำนวนรอบของขดลวดทุติยภูมิ $N_s$ .....	45
 บทที่ 3 การออกแบบหน้าจอแสดงความถี่สูงแบบฟลายแบค.....	46
3.1 การสร้างหน้าจอแสดงความถี่สูงแบบฟลายแบค .....	46
3.1.1 ขั้นตอนการสร้างคอนเวอร์เตอร์แบบฟลายแบค .....	46
3.1.2 ตัวอย่างการออกแบบหน้าจอแสดงความถี่สูงแบบฟลายแบค .....	47
3.1.3 การเลือกใช้คุปกรณ์ในการพัฒนาหน้าจอแสดงความถี่สูงแบบฟลายแบค.....	51
 บทที่ 4 ผลการทดลองและวิเคราะห์ผล .....	54
4.1 รูปของการออกแบบการพัฒนาหน้าจอแสดงและผลการวัดค่าพารามิเตอร์ .....	54
4.1.1 รูปการออกแบบการพัฒนาหน้าจอแสดงและผลการทดสอบ.....	54
4.1.2 ผลการวัดค่าพารามิเตอร์ของหน้าจอแสดงความถี่สูง (ไม่มีช่องอากาศคั่น) .....	56
4.1.3 กราฟแสดงค่าของพารามิเตอร์ของหน้าจอแสดงความถี่สูง .....	57
4.1.4 ผลการวัดค่าพารามิเตอร์ของหน้าจอแสดงความถี่สูง (เพิ่มช่องอากาศคั่น) .....	60

## สารบัญ(ต่อ)

หน้า	
4.1.5 กราฟแสดงค่าของพารามิเตอร์ของหม้อแปลงความถี่สูง .....	61
4.1.6 วิเคราะห์ผลเพื่อทำการออกแบบหม้อแปลงตัวสมนฐาน.....	64
4.2 การทดสอบหม้อแปลงความถี่สูงแบบฟลายแบคในวงจรอัคประจุแบบเตอร์ .....	65
4.2.1 ผลการทดสอบหม้อแปลงความถี่สูงในวงจรอัคประจุ .....	66
4.2.2 การเปรียบเทียบระหว่างหม้อแปลงตัวอ้างอิงและหม้อแปลงตัวสมนฐาน .....	69
บทที่ 5 สรุปผลและข้อเสนอแนะ .....	70
5.1 สรุปผลการดำเนินงาน .....	70
5.2 ปัญหาและข้อเสนอแนะ .....	70
5.3 แนวทางในการพัฒนาโครงการต่อไป .....	70
เอกสารอ้างอิง .....	71
ภาคผนวก ก รายละเอียดของวงจรอัคประจุ .....	72
ภาคผนวก ข รายละเอียดของ ไอซี UC3844 ในวงจรอัคประจุ .....	80
ภาคผนวก ค รายละเอียดของมอสเฟต FQP7N80 ในวงจรอัคประจุ .....	85
ประวัติผู้ดำเนินโครงการ .....	88

## สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
2.1 ขนาดมาตรฐาน AWG ข้อมูลอื่นๆ ของขดลวดทองแดงตามน้ำยา .....	13
2.2 การจัดกลุ่มของเทปปอนวนตามอัตราทนอุณหภูมิ (THERMAL STRENGTH) .....	32
3.1 ตัวอย่างการคำนวณค่าน้ำมันปฐมภูมิ ( $N_1$ ).....	48
3.2 ตัวอย่างการคำนวณค่าน้ำที่ยืนคง ( $N_s$ ).....	49
3.3 ตัวอย่างการคำนวณค่าน้ำด้วย ( $N_d$ ).....	50
3.4 ผลกำลังสูญเสียและความสูงทึบหมุดของขดลวด .....	50
4.1 ค่าเฉลี่ยพารามิเตอร์ของหม้อแปลงความถี่สูง (ยังไม่มีช่องอากาศคั่น).....	56
4.2 ค่าเฉลี่ยพารามิเตอร์ของหม้อแปลงความถี่สูง (เพิ่มช่องอากาศคั่น).....	60



# สารบัญรูป

รูปที่	หน้า
2.1 ตัวอย่างลักษณะของเส้นโถงชิสเทอร์รีซิส [3]	5
2.2 กราฟค่าการสูญเสียในแกนเพอร์ไร็ต์ [3]	6
2.3 การกำหนดค่าของอากาศคัน $I_g$ ที่แกนกลาง และระหว่างคู่ที่ประกอบ	8
2.4 ความสัมพันธ์พื้นฐานของหม้อแปลง	11
2.5 ลักษณะการเกิดกระแสไฟลุกภายในลวดทองแดง	12
2.6 ระยะที่ถือว่าเป็นพื้นผิวนำกระแสไฟลุก	13
2.7 ค่าอัตราส่วนความต้านทานที่สลับต่อความต้านทานที่กระแสตรง ( $F_R$ )	16
2.8 ลักษณะของการเกิดพลักช์ร่วงภายในหม้อแปลงความถี่สูงฟลายแบค	17
2.9 ลักษณะของพลักช์ร่วงและค่าความหนาแน่นของพลักช์ร่วง $B_x$	18
2.10 ลักษณะของพลักช์ร่วงทำให้มีกระแสไฟลุกนิกิตชั้นที่ผิว	18
2.11 การปรับเปลี่ยนลวดทองแดงที่พันเรียงกันแต่ละชั้น	19
2.12 การกำหนดจำนวนชั้นในพอร์ชั่น	20
2.13 การลดลงความหนาแน่นพลักช์สูงสุดของพลักช์ร่วง	20
2.14 การลดจำนวนชั้นจากกรุปที่ 2.12 ลงไปอีก โดยแบ่งครึ่งพันคงทุติภูมิ	21
2.15 ลักษณะของพอร์ชั่นที่มีจำนวนชั้นเท่ากันกับครึ่งชั้น	22
2.16 การจัดคลอดทองแดงสำหรับฟอร์เวอร์คคอนเวอร์เตอร์ที่เหมาะสม	22
2.17 ลักษณะของค่าความหนาแน่นพลักช์ร่วง	23
2.18 ลักษณะความหนาแน่นของพลักช์ร่วงในหม้อแปลงที่มีคงทุติภูมิหลากหลาย	23
2.19 ตามกำหนดค่าต่างๆ ในการพันหม้อแปลงความถี่สูงตามวิธี JONGSMA	24
2.20 การพันคลอดโดยขดลวดทองแดงนานกัน	27
2.21 (ก) หม้อแปลงที่ไม่มีจากกัน RFI จะเกิดตัวเกินประจุไฟฟ้าระหว่างขบวนภูมิและ	30
2.22 จากกัน EMI รอบหม้อแปลงความถี่สูง	31
2.23 การพันคลอดบนบันไดลักษณะแยกผังคลอดที่ขานบนบันได	33
2.24 การแยกส่วนของคลอดคัวบทเทปปอนวนบนบันได	33
2.25 บล็อกໄ/doze แกรมของแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงแบบสวิตชิ้ง [3]	34
2.26 ฟลายแบคค่อนเวอร์เตอร์	35
2.27 ฟอร์เวอร์คคอนเวอร์เตอร์	36
2.28 พุช - พุกดอนเวอร์เตอร์	37

## สารบัญรูป(ต่อ)

รูปที่	หน้า
2.29 ชาล์ฟ-บริคจ์คอนเวอร์เตอร์	37
2.30 ฟล-บริคจ์คอนเวอร์เตอร์	38
2.31 วงจรพื้นฐานของคอนเวอร์เตอร์แบบฟลายแบค [3]	39
2.32 กราฟลักษณะกระแสและแรงดันในวงจร [3]	41
3.1 ลักษณะแกนเฟอร์ไรต์ขนาด EI 40	51
3.2 ลักษณะของบีนหรือแบบรองพื้นขนาด EI 40	52
3.3 ลักษณะของคลอกทองแดงอาน้ำยา	52
3.4 ลักษณะเทปปอนวัน	53
3.5 ลักษณะหม้อแปลง	53
4.1 วัดหาค่าความเหนี่ยวแน่น (L) ค่าความต้านทาน (R) ของบัดคลอดหม้อแปลง	54
4.2 การออกแบบหม้อแปลงความถี่สูงลักษณะต่างๆ	56
4.3 กราฟแสดงการเปรียบเทียบค่าความเหนี่ยวแน่นของหม้อแปลง	57
4.4 กราฟแสดงการเปรียบเทียบค่าความต้านทานของหม้อแปลง	58
4.5 กราฟแสดงการเปรียบเทียบค่ารีแอคเคนซ์ของหม้อแปลง	59
4.6 กราฟแสดงการเปรียบเทียบค่าความเหนี่ยวแน่นของหม้อแปลง	61
4.7 เปรียบเทียบค่าความต้านทานของหม้อแปลง	62
4.8 เปรียบเทียบค่าความรีแอคเคนซ์ของหม้อแปลง	63
4.9 หม้อแปลงตัวสมบูรณ์	64
4.10 วงจรอัคประจุแบบเตอร์	65
4.11 สัญญาณควบคุมสวิตช์ของไอซี UC3844	65
4.12 ลักษณะของสัญญาณเอาต์พุตก่อนเข้าหม้อแปลง	66
4.13 ทดสอบหาค่าพารามิเตอร์หม้อแปลงตัวอ้างอิง	66
4.14 ลักษณะแรงดันด้านปฐมภูมิตัวอ้างอิงและลักษณะแรงดันด้านปฐมภูมิตัวที่ออกแบบ	67
4.15 ลักษณะแรงดันด้านของคลอกช่วยด้านปฐมภูมิตัวอ้างอิงและตัวออกแบบ	67
4.16 ลักษณะแรงดันด้านทุติภูมิตัวอ้างอิงและลักษณะแรงดันด้านทุติภูมิตัวสมบูรณ์	68
4.17 ลักษณะแรงดันขาออกของวงจรอัคประจุของตัวอ้างอิงและตัวสมบูรณ์	68
4.18 เปรียบเทียบค่าระห่ำว่างหม้อแปลงอ้างอิงกับหม้อแปลงตัวสมบูรณ์	69

## บทที่ 1

### บทนำ

#### 1.1 ที่มาและความสำคัญของโครงงาน

ปัจจุบันหน้ามือแปลงความถี่สูงเป็นอุปกรณ์แม่เหล็กฟีนรูรานที่ใช้ในวงจรแปรผันกำลังไฟฟ้า เช่น คอนเวอร์เตอร์ และแหล่งจ่ายกำลังสวิตซิ่ง เป็นต้น สำหรับโครงงานนี้จะกล่าวถึงการออกแบบ หน้ามือแปลงไฟฟ้าความถี่สูงโดยเฉพาะสำหรับแหล่งจ่ายสวิตซิ่งแบบฟลายแบค (Fly-back Converter)

หน้ามือแปลงไฟฟ้าของวงจรฟลายแบคค่อนเวอร์เตอร์ จะทำหน้าที่เหมือนตัวเหนี่ยวนำ นอกเหนือจากหน้าที่หลักคือหน้ามือแปลง สำหรับโครงสร้างของแปลงไฟฟ้าของวงจรฟลายแบค พลังงาน จะถูกถ่ายเทไปยังโหลดในขนาดที่ไม่นำกระแทก คือช่วงเวลา ( $1-D$ )T เมื่อจากหน้ามือแปลงไฟฟ้าของ วงจรฟลายแบคจะทำหน้าเหมือนตัวเหนี่ยวนำทำให้สามารถแบ่งโภมคการทำงานได้เป็น 2 รูปแบบ คือโภมคกระแสต่อเนื่อง (Continuous Conduction Mode : CCM) และ โภมคกระแสไม่ต่อเนื่อง (Discontinuous Conduction Mode : DCM )

#### 1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน

เพื่อศึกษาหลักการ วิธีการ การออกแบบหน้ามือแปลงความถี่สูงสำหรับแหล่งจ่ายสวิตซิ่ง แบบฟลาย หรือที่เรียกว่าคือ หน้ามือแปลงความถี่สูงแบบฟลายแบค รวมทั้งทำการออกแบบ ทดสอบ หน้ามือแปลงความถี่สูง และพัฒนาหน้ามือแปลงความถี่สูงแบบฟลายแบคให้มีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อ เป็นประโยชน์ในนำไปใช้งานต่อไปในวงจรยัคประจุแบบพกพา ยึดตัวขึ้น

#### 1.3 ขอบเขตของโครงงาน

- ศึกษาหลักการวิธีการออกแบบหน้ามือแปลงไฟฟ้าความถี่สูง
- ออกแบบหน้ามือแปลงไฟฟ้าความถี่สูงแบบฟลายแบค
- สร้างหน้ามือแปลงไฟฟ้าความถี่สูงแบบฟลายแบค
- ทดสอบหน้ามือแปลงไฟฟ้าความถี่สูงแบบฟลายแบค

## 1.4 ขั้นตอนและแผนการดำเนินงาน

รายละเอียด	ปี 2554							ปี 2555			
	ม.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	
1) ศึกษาหลักการถ้าออกแบบ หน้อแปลงไฟฟ้าและหน้อ <sup>เปลี่ยนความถี่สูง</sup>											
2) ศึกษาวางแผนอัดประจุและ วางแผนโครงงาน											
3) ออกแบบและคำนวณหน้อ <sup>เปลี่ยนและตัวหนี่ยวนำ</sup>											
4) ทดสอบการทำงานและ ปรับปรุง											
5) สรุปผลการดำเนินงาน และนำเสนอโครงงาน											
6) จัดทำรูปเล่มบริษุษญา นพันธ์											

## 1.5 ประโยชน์ที่รับจากโครงงาน

เพื่อพัฒนาหน้อแปลงความถี่สูงสำหรับแหล่งจ่ายแบบฟลาร์บคให้มีประสิทธิภาพสูงสุดนำไปสู่การประหยัดและการสูญเสียพลังงาน โดยเป็นประโยชน์ได้จริง ทั้งนี้หวังว่าการศึกษาค้นควารุณไปถึงผลการทดสอบเบื้องต้นจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่มีความสนใจและต้องการศึกษาเรื่องหน้อแปลงความถี่สูงสำหรับแหล่งจ่ายสวิตชิ่งได้เป็นอย่างดี

## 1.6 งบประมาณ

1) วงจรอัดประจุ	3,000 บาท
2) หน้อแปลง	1,500 บาท
3) ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่นบริษุษญาณพันธ์	1,500 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (หกพันบาทถ้วน)	<u>6,000 บาท</u>
หมายเหตุ: ถ้ามีลี่ยุกรายการ	

## บทที่ 2

### หลักการออกแบบหน้าจอแสดงความถี่สูงแบบฟลายแบค

ส่วนประกอบหลักที่ศึกษาในโครงการนี้คือการออกแบบหน้าจอแสดงความถี่สูงแบบฟลายแบคและ คอนเวอร์เตอร์ (Converter) ในบทนี้จึงได้อธิบายทฤษฎีการออกแบบหน้าจอแสดงและ หลักการทำงานพื้นฐานของอุปกรณ์หลักดังกล่าว

#### 2.1 หน้าจอแสดงความถี่สูงแบบฟลายแบค

หน้าจอแสดงความถี่สูงแบบฟลายแบค เป็นหน้าจอแสดงที่ใช้ในแหล่งจ่ายไฟแบบสวิตชิ่ง และ การออกแบบแหล่งจ่ายไฟแบบฟลายแบคนี้ควรคำนึงถึงความเหมาะสมในด้านการใช้งานเป็นหลัก โดยการคำนวณขนาดแกนเฟอร์ไรต์และขนาดลวดทองแดง รวมทั้งการกำหนดความปลดภัยทางไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยและลดกำลังงานสูญเสียในหน้าจอแสดงขณะทำงาน

##### 2.1.1 ส่วนประกอบของหน้าจอแสดงความถี่สูงแบบฟลายแบค

หน้าจอแสดงความถี่สูงแบบฟลายแบคมีหน้าที่ในการลดความแรงดันไฟตรงที่อินพุตของ คอนเวอร์เตอร์ และทำให้เกิดการแยกกันทางไฟฟ้าระหว่างแรงดันอินพุตและแรงดันเอาต์พุตที่ได้

ส่วนประกอบของหน้าจอแสดงความถี่สูงแบบฟลายแบค

###### ▪ บอนบีน (Bobbin)

บอนบีนหรือแบบร่องพื้น ปกติจะทำการผลิตโดยใช้กระบวนการพิมพ์แม่พิมพ์ ไม่ติดไฟ มีหน้าที่ช่วยให้การพันขดลวดบนแกนเฟอร์ไรต์สะดวกขึ้น และป้องกันปัญหาการลัดวงจรระหว่าง ขดลวดกันแกนเฟอร์ไรต์ได้ โดยบอนบีนจะมีขนาดตามมาตรฐานของแกนเฟอร์ไรต์ ส่วนใหญ่จะ ออกแบบให้มีขาพักลวดทองแดง เพื่อความสะดวกในการพันขดลวดและการบัดกรีติดกับแผ่น PCB

###### ▪ ลวดทองแดงชาน้ำยา (Enameled Copper Wire)

การพันขดลวดทองแดงทั้งปูนภูมิและทุติยภูมิของหน้าจอแสดงความถี่สูงที่กำลังไม่สูง มากนักปกติมักจะใช้ลวดทองแดงชาน้ำยาพันบนบอนบีนเพื่อให้ได้จำนวนรอบตามต้องการ และขนาดของขดลวดทองแดงที่ใช้พันนั้น ขึ้นอยู่กับค่ากระแสสูงสุดที่ผ่านขดลวด ความถี่ และ พลังงานเดียวอันๆ

### ■ เทปปอนวน (Insulation Tape)

เทปปอนวนใช้พันสำหรับเป็นตัวรองระหว่างชั้นของขดลวดในหม้อแปลงความถี่สูงและมีหน้าที่สำคัญในการแยกกันทางไฟฟาระหว่างขดลวดปฐมภูมิและขดลวดทุติยภูมิ วัสดุที่ใช้ทำเทปปอนวนอาจมาจากไมโครหรือโพลีอีสเตอร์ ที่มีความหนาอยู่ในช่วง 0.05 - 0.1 มิลลิเมตร การเลือกใช้ขึ้นอยู่กับการออกแบบและค่าความปลดปล่อยที่ต้องการจากหม้อแปลงความถี่สูงเป็นหลัก

### ■ แกนเฟอร์ไรต์ (Ferrite Core)

เฟอร์ไรต์เป็นวัสดุประเภทสารเฟอร์โรแมกเนติก การเหนี่ยวนำแม่เหล็กบนแกนเฟอร์ไรต์จะมีผลทำให้เกิดความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็กสูงสุดกว่าการเหนี่ยวนำแม่เหล็กที่เกิดขึ้นบนแกนจากศูนย์ เฟอร์ไรต์มีค่าทุคคื่นตัวฟลักซ์แม่เหล็กค่อนข้างสูง ประมาณในช่วง 3,000 - 4,000 เก่าต์ และเกิดการสูญเสียในแกนเฟอร์ไรต์ต่ำที่ความถี่สูง ๆ ดังนั้นหม้อแปลงความถี่สูงจึงนิยมใช้แกนเฟอร์ไรต์มากที่สุด เฟอร์ไรต์ที่นำมาทำแกนของหม้อแปลงความถี่สูงจะมีรูปร่างแตกต่างกันออกไม้ขีนอยู่กับการใช้งานและมาตรฐานในการออกแบบ

#### 2.1.2 แกนเฟอร์ไรต์และการเลือกใช้

##### 1) ลักษณะและขนาดมาตรฐานของแกนเฟอร์ไรต์

แกนเฟอร์ไรต์สำหรับหม้อแปลงความถี่สูงโดยทั่วไป จะถูกผลิต成มาที่ขนาดและรูปร่างแตกต่างกันออกไปตามมาตรฐานเดียวกัน เช่น แกนแบบ EB, EI, ETD เป็นต้น โดยปกติแกนจะถูกผลิต成มาในลักษณะคู่ประกน เพื่อความสมมาตรในการประกอบเข้ากันของบีน การประกนแกนเฟอร์ไรต์บนบอบีนจะทำให้ทางเดินฟลักซ์แม่เหล็กที่เกิดขึ้นในแกนเฟอร์ไรต์มีลักษณะเป็นวงบรรจบได้

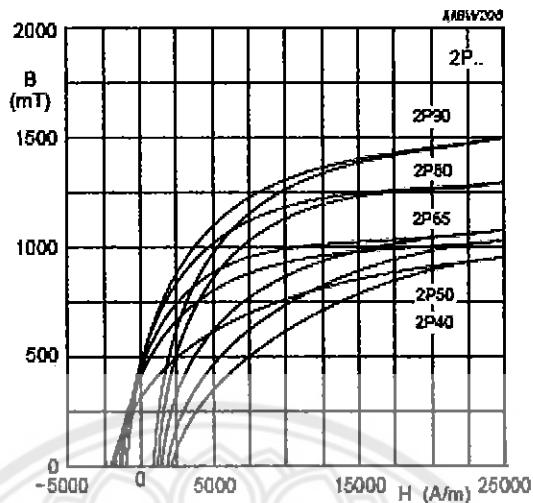
##### 2) ลักษณะสมบัติของเนื้อสารที่ใช้ทำแกนเฟอร์ไรต์

ชนิดของเนื้อสารที่แตกต่างกัน จะทำให้คุณสมบัติทางแม่เหล็กของแกนเฟอร์ไรต์แตกต่างกันไปด้วยถึงแม้ว่าจะมีขนาดเท่ากัน ในแผ่นข้อมูลเนื้อสารที่นำมา กับแกนเฟอร์ไรต์นั้น จะต้องมีรายละเอียดคุณสมบัตินี้ของการแสดง ไว้เสมอ ข้อมูลที่สำคัญคือ เส้นโค้งฮิสเตอร์เรซิส (Hysteresis Curve) และค่าการสูญเสียในแกนเฟอร์ไรต์ (Core Loss)

#### เส้นโค้งฮิสเตอร์เรซิส (Hysteresis Curve)

เส้นโค้งฮิสเตอร์เรซิสจะแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง ค่าความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก (B) ที่เกิดขึ้นในแกนเฟอร์ไรต์ กับความเข้มของสนามแม่เหล็ก (H) ที่เกิดจากการเหนี่ยวนำของขดลวดที่พันบนแกนจากรูปที่ 2.1 แสดงการเปลี่ยนแปลงค่าความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก (B)

ต่อความเข้มของสนามแม่เหล็ก ( $H$ ) กล่าวคือเมื่อความเข้มของสนามแม่เหล็ก ( $H$ ) มีค่าเพิ่มขึ้น ค่าความหนาแน่น พลักซ์แม่เหล็กก็จะมีค่าเพิ่มขึ้น จนกระทั่งถึงจุดอิ่มตัว (Saturated Point)



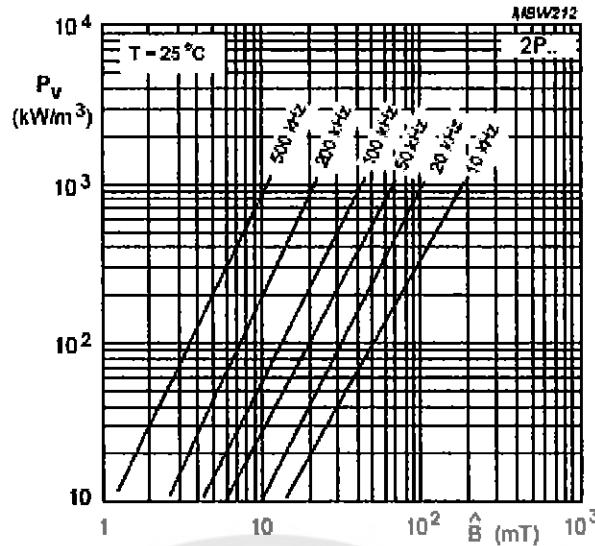
รูปที่ 2.1 ตัวอย่างถักขยะของเต้น โถงชิสเตอร์ริชิต [3]

โดยปกติผู้ผลิตจะแสดงกราฟของเต้น โถงชิสเตอร์ริชิตเพียงครึ่งเดียว เนื่องจากอีกครึ่งหนึ่งของเต้น โถงชิสเตอร์ริชิตจะมีลักษณะเหมือนกันทุกประการเพียงแต่มีลักษณะกลับกันเท่านั้น การใช้งานแกนเฟอร์ไรต์ในหม้อแปลงความถี่สูงต้องระวังไม่ทำให้แกนเฟอร์ไรต์เกิดการอิ่มตัวขึ้น ได้ ดังนั้น โดยทั่วไปในการออกแบบหม้อแปลงความถี่สูง จึงควรกำหนดค่าความหนาแน่นพลักซ์แม่เหล็ก ( $B$ ) ที่ยอมให้เกิดขึ้นได้ในแกนขณะทำงาน มีค่าไม่เกินครึ่งหนึ่งของค่าความหนาแน่น พลักซ์แม่เหล็กสูงสุดก่อนอิ่มตัวของแกนเฟอร์ไรต์ เพื่อความปลอดภัย

### ค่าการสูญเสียในแกนเฟอร์ไรต์ (Core Loss)

การสูญเสียที่เกิดขึ้นในแกนเฟอร์ไรต์จะทำให้แกนเฟอร์ไรต์ร้อน โดยมีสาเหตุหลัก 2 ประการคือ การสูญเสียที่เกิดจากการถับตัวของสนามแม่เหล็ก (Hysteresis Loss) และการสูญเสียจากการเกิดกระแสไฟลุวนภายในแกน (Eddy Current Loss)

ขณะที่ความถี่ต่ำกว่า 100 กิโล赫ertz การสูญเสียจากการเกิดกระแสไฟลุวนภายในแกนจะมีค่าน้อยสำหรับแกนที่มีขนาดไม่ใหญ่มากนัก ดังนั้นการสูญเสียที่ก่อให้เกิดความร้อนในแกนอาจพิจารณาได้จากการสูญเสียทางอิสเตอร์ริชิตเพียงอย่างเดียว ตัวอย่างกราฟแสดงค่าการสูญเสียที่เกิดขึ้นในแกนเฟอร์ไรต์แสดงไว้ในรูปที่ 2.2 ปกติค่ากำลังสูญเสียจะถูกระบุไว้เป็นกิโลวัตต์ต่อหนึ่งถูกบาทเมตร และมีค่าขึ้นกับความหนาแน่นพลักซ์แม่เหล็ก ความถี่การใช้งาน รวมถึงอุณหภูมิขณะใช้งานของแกนเฟอร์ไรต์



รูปที่ 2.2 กราฟค่าการสูญเสียในแกนเพอร์ไรต์ [3]

3.) การคำนวณค่าความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็กสูงสุดในแกนหม้อแปลง

ค่าความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็กในแกนเหล็กในหม้อแปลง จะขึ้นอยู่กับจำนวนรอบของปฐมภูมิและขนาดของแกน หากกฎของฟาราเดียจะได้ว่า

$$\Delta B = \frac{V \cdot t}{N_p \cdot A_e} \times 10^3 \quad (2.1)$$

โดยที่  $\Delta B$  คือ ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็กที่เกิดขึ้นในแกน เป็น gauss  
 $V$  คือ แรงดันที่ต่อกรร่องบดปฐมภูมิ เป็นโวลต์  
 $N_p$  คือ ค่าจำนวนรอบของปฐมภูมิเป็นรอบ  
 $A_e$  คือ ขนาดพื้นที่หน้าตัดของแกน เป็นตารางเซนติเมตร  
 $t$  คือ ช่วงเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงฟลักซ์แม่เหล็กที่เกิดขึ้น เป็นวินาที

จะเห็นได้ว่าขึ้นจำนวนรอบของบดปฐมภูมิมีค่าน้อยลง ค่าความหนาแน่นฟลักซ์ที่เกิดขึ้นจะยิ่งน้อยลง ซึ่งการลดจำนวนของบดปฐมภูมิลงจะทำให้สามารถใช้ลวดทองแดงขนาดที่ใหญ่ขึ้นได้ และสามารถทนกระแสไฟฟ้าให้หม้อแปลงให้กำลังได้สูงขึ้น

อย่างไรก็ตาม หากค่าความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็กมีค่าเพิ่มขึ้นจนถึงจุดอิ่มตัว จะทำให้แรงดันตอกคร่อมขดปฐมภูมิค่าลดลงอย่างรวดเร็ว แรงดันอินพุตจะไปตกคร่อมที่เพาเวอร์ทรานซิสเตอร์ขณะที่กำลังนำกระแสสูงๆแทน ทำให้เพาเวอร์ทรานซิสเตอร์พังเสียหายได้และความหนาแน่น ฟลักซ์แม่เหล็กที่มีค่าสูงจะทำให้เกิดการสูญเสียภายในแกนสูงอีกด้วย ดังนั้นการกำหนดค่าความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็กสูงสุดที่ยอมทำให้เกิดขึ้นในแกนเฟอร์ไรต์ของหม้อแปลงขณะทำงานจึงมีข้อที่ควรคำนึงถึง 2 ประการคือ

1. แกนเฟอร์ไรต์ไม่เกิดการอิ่มตัวขณะทำงาน
2. ที่ค่าความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็กสูงสุดที่เกิดขึ้นในแกนขณะทำงานจะต้องเกิดการสูญเสียในแกนเฟอร์ไรต์ต่ำที่สุด

#### 4) การเลือกขนาดแกนเฟอร์ไรต์ที่เหมาะสม

การใช้แกนเฟอร์ไรต์ที่มีขนาดใหญ่เกินไปสำหรับหม้อแปลงความถี่สูง จะเป็นการสูญเปลืองค่าใช้จ่าย โดยไม่จำเป็น ด้านการใช้แกนเฟอร์ไรต์ที่มีขนาดเล็กเกินไป ขาด漉ดและแกนเฟอร์ไรต์จะร้อน กำลังงานสูงสุดที่เหมาะสมสำหรับขนาดต่างๆ พิจารณาได้จากขนาดหน้าตัดของแกน ( $A_e$ ) และขนาดช่องสำหรับพันบคคลวคของบอบน ( $A_w$ ) โดยอาจคำนวณได้จากสมการต่างๆ ดังต่อไปนี้

สำหรับแกนที่ใช้กับหม้อแปลงของเวอร์ค่อนเวอร์เตอร์

$$P = \frac{0.5\Delta B_{(\max)} \cdot f \cdot A_e \cdot A_w}{D} \times 10^{-3} \quad (2.2)$$

สำหรับแกนที่ใช้กับหม้อแปลงของพูช – พูลค่อนเวอร์เตอร์

$$P = \frac{\Delta B_{(\max)} \cdot f \cdot A_e \pm A_w}{D} \times 10^{-3} \quad (2.3)$$

สำหรับแกนที่ใช้กับหม้อแปลง萨德ฟบริคจ์และฟูคบริคบ์ค่อนเวอร์เตอร์

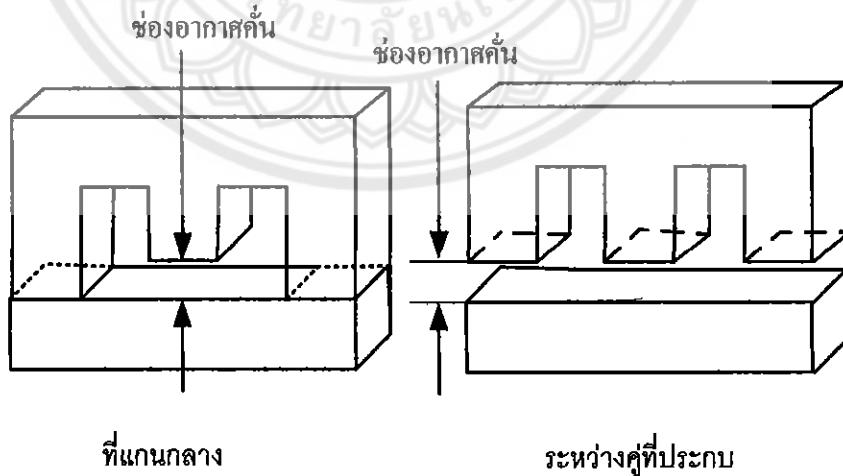
$$P = \frac{1.4 \Delta B_{(\max)} \cdot f \cdot A_e \cdot A_w}{D} \times 10^{-3} \quad (2.4)$$

- โดยที่  $\Delta B_{(\max)}$  คือ ค่าความหนาแน่นฟลักซ์สูงสุด ในแกนเฟอร์ไรต์ เป็นเกาส์  
 $f$  คือ ค่าความถี่การทำงานของแกนเฟอร์ไรต์ เป็นเฮرتซ์  
 $A_e$  คือ พื้นที่หน้าตัดของแกนเฟอร์ไรต์ เป็นตารางเซนติเมตร  
 $A_w$  คือ พื้นที่ช่องสำหรับพันขดลวดของบอร์บิน เป็นตารางเซนติเมตร  
 $D$  คือ ค่าหนาแน่นกระแสในขดปฐมภูมิ เป็นเซอร์คูลาร์มิลตอแอมป์  
 $P$  คือ กำลังสูงสุดที่ได้รับจากแกนเฟอร์ไรต์ เป็นวัตต์

### 5) ช่องอากาศคั่นทางเดินแม่เหล็กในแกนเหล็กในแกนเฟอร์ไรต์ (Air Gap)

การกำหนดช่องอากาศคั่นทางเดินแม่เหล็ก (Air Gap) ในแกนเฟอร์ไรต์ เป็นวิธีการอย่างหนึ่งที่ใช้ป้องกันการอิมตัวของแกนเฟอร์ไรต์ และช่วยให้การสะแม่เหล็กงานของขดลวดหม้อแปลงความถี่สูง ค้างจะมากขึ้น ได้ด้วย อย่างไรก็ตาม ช่องอากาศคั่นในแกนเฟอร์ไรต์จะทำให้เกิดการแพร่กระจายสัญญาณรบกวน EMI ออกมานะจะอาจรบกวนอุปกรณ์ภายนอกได้เช่นกัน

สำหรับแกนเฟอร์ไรต์แบบ EE, EI, ETD หรือแบบ POT สามารถกำหนดลักษณะของช่องอากาศคั่นในแกน ได้ ดังรูปที่ 2.3 คือการกำหนดช่องอากาศคั่นที่แกนกลางอย่างเดียว และระหว่างคู่ที่ประกอบ



รูปที่ 2.3 การกำหนดช่องอากาศคั่น  $I_g$  ที่แกนกลาง และระหว่างคู่ที่ประกอบ

การคั่นแคนด้วยช่องอากาศระหว่างถุที่ประกบสามารถทำได้การคั่นช่องอากาศที่แคนกล่องซึ่งทำได้โดยการใช้แผงวนที่มีความหนาแน่นเป็นครึ่งหนึ่งของช่องอากาศคั่นแคนที่ต้องการ นำมาคั่นแคนนอกของถุประกบ ส่วนการกำหนดช่องอากาศคั่นที่แคนกล่อง ต้องสั่งโดยตรงจากผู้ผลิตแคนเฟอร์ไรต์หรือขัคแคนกล่องออกแบบเพื่อให้ได้ระบบช่องอากาศคั่นตามต้องการ

มีข้อสังเกตคือ การคั่นช่องอากาศระหว่างถุประกบความหนาแน่นวนคั่นที่ใช้มีค่าเพียงครึ่งหนึ่งของระบบช่องอากาศคั่นที่ต้องการเท่านั้น เมื่อจากช่องอากาศที่เกิดขึ้นจะคั่นทางเดินฟลักซ์แม่เหล็กถึงสองครั้งในแคน ดังนั้นระบบอากาศคั่นที่ได้จะเป็นผลรวมของช่องอากาศที่เกิดขึ้นทั้งหมด

การกำหนดให้มีช่องอากาศคั่นแคนเฟอร์ไรต์นั้น มีความจำเป็นมากสำหรับหน้าแปลงความถี่สูงแบบฟลายแบคค่อนเวอร์เตอร์และเอาต์พุตโซล์ฟต์ที่ใช้แคนเฟอร์ไรต์ ดังจะได้กล่าวในหัวข้อต่อไป

#### 6) แคนเฟอร์ไรต์สำหรับหน้าแปลงความถี่สูงแบบฟลายแบคและเอาต์พุตโซล์ฟต์

สำหรับฟลายแบคค่อนเวอร์เตอร์และตัวเอาต์พุตโซล์ฟต์ จะทำงานในลักษณะที่ต้องเก็บสะสมพลังงานไว้ก่อน แล้วจึงถ่ายเทพลังงานออกไป จึงอาจกล่าวได้ว่า กำลังที่ได้จากหน้าแปลงจะมาจากคลาพลังงานที่หน้าแปลงสามารถสะสมไว้ได้นั่นเอง ในช่วงที่มีการสะสมพลังงานของหน้าแปลงหรือเอาต์พุตโซล์ฟต์ พลังงานที่ถูกสะสมมีค่าเท่ากับ  $\frac{1}{2} LI^2$  ความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานสะสมกับขนาดของแคนเฟอร์ไรต์สามารถหาได้จาก

$$LI_{p(pk)}^2 = \frac{\Delta B_{(\max)}^2 \cdot l_g \cdot A_e}{0.4\pi} \times 10^{-8} \quad (2.5)$$

โดยที่  $l_g$  คือ ระยะห่างช่องอากาศคั่นแคนเฟอร์ไรต์ เป็นเซนติเมตร

$A_e$  คือ ขนาดพื้นที่หน้าตัดแคนเฟอร์ เป็นตารางเซนติเมตร

$\Delta B_{(\max)}$  คือ ค่าความหนาแน่นฟลักซ์สูงสุดในแคน เก้าส์

$L$  คือ ค่าความหนี้บานนำขดปฐมนิเทศของหน้าแปลงหรือค่าความหนี้บานของเอาต์พุตโซล์ฟต์ เป็นเซนติเมตร

$I_{p(pk)}$  คือ ค่ากระแสสูงสุดที่ผ่าน L เป็นแอมป์

ค่าของ  $\Delta B_{(\max)}$  โดยทั่วไปจะกำหนดไว้เป็นครึ่งของค่าแกนเฟอร์ไรต์  $\left(\frac{B_{(sat)}}{2}\right)$  ดังรูปสมการที่ข้างบน จะเห็นได้ว่า จะสามารถเพิ่มค่าพลังงานสะสม (หรือเพิ่มกำลังของแม่เหล็ก) ได้โดยการเพิ่มระยะห่างอากาศกัน ( $I_g$ ) หรือโดยการเพิ่มขนาดของแกนเฟอร์ไรต์ให้ขนาดใหญ่ขึ้น ( $A_e$  เพิ่มขึ้น) ในทางปฏิบัติการเพิ่มระยะห่างอากาศกันจะไม่นิยมใช้มากกว่า เพราะต้องการให้มีแม่เหล็กความถี่สูงแบบฟลายแบนคและเอาต์พุต ให้มีขนาดเล็ก

อย่างไรก็ตาม แกนเฟอร์ไรต์ที่มีขนาดหนึ่งๆ ระยะห่างอากาศกันสูงสุดจะถูกจำกัดด้วยค่าการสูญเสียที่เกิดขึ้นในDUCT เพราะจำนวนรอบมีค่าเพิ่มขึ้น โดยจำนวนรอบจะมีค่าเพิ่มขึ้นตามระยะอากาศที่เพิ่มมากขึ้น ดังสมการ

$$N = \frac{\Delta B_{(\max)} I_g}{0.4 I_{p(pk)}} \quad (2.6)$$

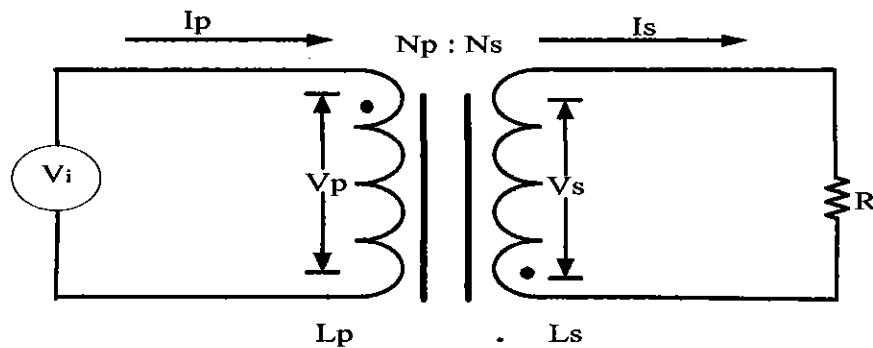
เมื่อ  $N$  คือ จำนวนรอบของDUCT ปัจจุบันของแม่เหล็ก หรือเอาต์พุต ให้ค

เนื่องจากระยะพัฒนาของบินนี้มีค่าจำกัด และอาจมีเนื้อที่ไม่พอสำหรับจำนวนรอบที่เพิ่มขึ้น รวมถึงการสูญเสียที่เกิดขึ้นในDUCT ของแกนเฟอร์ไรต์ ซึ่งจะทำให้มีแม่เหล็ก หรือเอาต์พุต ให้คุ้มค่า ผู้ออกแบบจึงต้องพิจารณาจุดที่เหมาะสมระหว่างการเพิ่มระยะห่างอากาศกันหรือการเพิ่มขนาดของแกนเฟอร์ไรต์

### 2.1.3 ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดปัจจุบันและขนาดที่ต้องการ

ขนาดปัจจุบันของDUCT ที่มีความสัมพันธ์ของDUCT ปัจจุบันเป็นไปตามทฤษฎีที่ระบุไว้ในตารางที่ 2.4 จะเป็นดังนี้

$$\frac{V_p}{V_s} = \frac{N_p}{N_s} = \frac{I_s}{I_p} \quad (2.7)$$



รูปที่ 2.4 ความสัมพันธ์พื้นฐานของหม้อแปลง

$$\text{และ} \quad \frac{N_p}{N_s} = \sqrt{\frac{L_p}{L_s}} \quad (2.8)$$

- เมื่อ  $N_p$  กือ จำนวนรอบของชดปฐมภูมิ
- $N_s$  กือ จำนวนรอบของชดปฐมภูมิ
- $V_p$  กือ ค่าแรงดันต่อกำรร่องของชดปฐมภูมิ
- $V_s$  กือ ค่าแรงดันต่อกำรร่องของชดทุติภูมิ
- $I_p$  กือ ค่ากระแสแท้ที่ไหลผ่านชดปฐมภูมิ
- $I_s$  กือ ค่ากระแสแท้ที่ไหลผ่านชดทุติภูมิ
- $L_p$  กือ ค่าความหนาของชดปฐมภูมิ
- $L_s$  กือ ค่าความหนาของชดทุติภูมิ

เมื่อสังเกต แรงดัน  $V_p$  เป็นค่าแรงดันที่ต่อกำรร่องของชดปฐมภูมิซึ่งเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของฟลักซ์แม่เหล็กภายในแกนของหม้อแปลงเนื่องจากมีกระแสไหลผ่านของปฐมภูมิไม่ใช่ค่าแรงอินพุต  $V_i$  โดย  $V_p$  จะมีค่าเป็นไปตามสมการ

$$V_p = N_p \cdot A_e \left( \frac{dB}{dt} \right) \times 10^{-8} \quad (2.9)$$

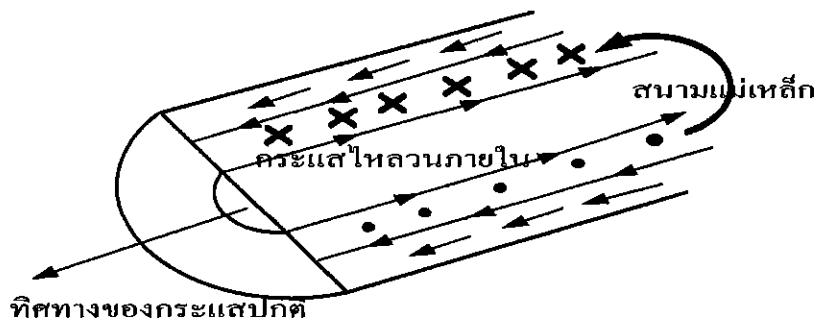
และ  $V_p$  ที่เกิดจะมีค่าไกล์เคียงกับค่า  $V_i$  แต่ถ้าแกนเฟอร์ไรต์เกิดการอินตัว อัตราการเปลี่ยนแปลงของฟลักซ์แม่เหล็ก  $\left( \frac{dB}{dt} \right)$  จะมีค่าน้อยมากหรือมีค่าเป็นศูนย์ แรงคันตอกรอม  $V_p$  จะมีค่าลดลงอย่างรวดเร็วเหมือนเกิดการลัดวงจร และจะมีผลต่อการทำงานของหม้อแปลงและวงจรที่เกี่ยวข้องด้วย

#### 2.1.4 การพันขดลวดทองแดงและการกำหนดของขดลวด

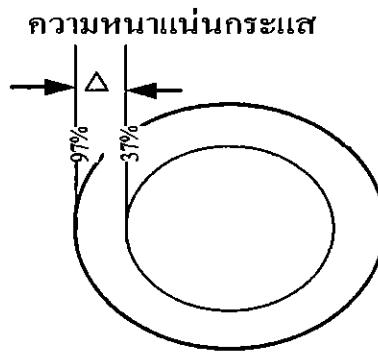
ปกติการพันขดลวดในหม้อแปลงความถี่สูงจะใช้ลวดทองแดงงานน้ำยา (Enamelled Copper Wire) เป็นตัวพัน (จากตาราง 2.1) จะแสดงขนาดและข้อมูลอื่นของเส้นลวดทองแดงงานน้ำยาตามมาตรฐาน AWG ที่มีการจำแนก ( ในขณะที่มีหม้อแปลงกำลังทำงาน สำหรับหม้อแปลงความถี่สูงแบบฟลายแบนกระแสลับที่ให้ผลผ่านขดลวดนั้นมีความถี่สูง ลวดทองแดงจะนำกระแสได้เพียงที่ผิว ซึ่งมีผลทำให้พื้นที่หน้าตัดในการนำกระแสของขดลวดทองแดงลดลง การสูญเสียในขดลวดจะมีมากขึ้น รวมทั้งการเรียงชั้นกันของขดลวดก็มีผลทำให้เกิดการสูญเสียขึ้นในขดลวด ได้เช่นเดียวกับการทำลักษณะที่สูญเสียเหล่านี้จะทำให้ขดลวดร้อน ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ต้องการให้เกิดขึ้นในขณะที่หม้อแปลงทำงาน การกำหนดขนาดและวิธีการพันขดลวดทองแดงจึงต้องทำอย่างเหมาะสม เพื่อลดการสูญเสียในขดลวดทองแดงให้มีค่าน้อยที่สุด )

##### 1) ผลกระทบการนำกระแสแค่เพียงที่ผิวของขดลวดทองแดง (Skin Effect)

ลวดทองแดงเมื่อมีกระแสลับ ให้ผลผ่านจะเกิดสนามแม่เหล็กให้วนที่ภายในและรอบๆ ตัวมันสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นจะเหนี่ยวนำให้เกิดกระแสในลวด (Eddy Current) ขึ้นมาภายในตัวลวดทองแดงอีกหนึ่ง การให้ผลของกระแสในลวดนี้ จะทำให้กระแสปูกติให้ลดได้เฉพาะที่ผิวของลวดทองแดง ดังแสดงในรูปที่ 2.5



รูปที่ 2.5 ลักษณะการเกิดกระแสในลวดภายในลวดทองแดง



รูปที่ 2.6 ระยะที่ดีอ้วเป็นพื้นผิวนำกระแสไฟล

△ คือระยะที่มีความหนาแน่นกระแส มีค่าลดลงเหลือเพียงแค่ 37 เปอร์เซ็นต์ของค่าความหนาแน่นกระแสที่ผิวนอกสุด

ตารางที่ 2.1 ขนาดมาตรฐาน AWG ข้อมูลอื่นๆ ของขดลวดทองแดงอาจอาบนำไปใช้

เบอร์ AWG (B.& S.)	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ( $d$ ) inch	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเมื่อรวมจำนวน ( $d_0$ ) mm	พื้นที่หน้าตัดปกติ $\text{mm}^2$	ค่าความต้านทานที่ $100^\circ \text{C}$ ( $R_{dc}$ ) $\Omega/\text{m}$	ระยะเริ่งชิดต่ำสุด ( $T_{min}$ ) mm	
44	0.00198	0.0503	0.06604	0.00199	11.180	0.071
43	0.00222	0.0564	0.07366	0.00250	8.899	0.079
42	0.00249	0.0633	0.08128	0.00314	7.073	0.087
41	0.00280	0.0711	0.09144	0.00397	5.594	0.098
40	0.00314	0.0798	0.1041	0.00500	4.448	0.111
39	0.00353	0.0897	0.1143	0.00631	3.519	0.122
38	0.00397	0.1008	0.1295	0.00799	2.783	0.138
37	0.00445	0.1130	0.1448	0.01003	2.215	0.154
36	0.00500	0.1270	0.1626	0.0127	1.754	0.172
35	0.00560	0.1422	0.1778	0.0159	1.398	0.188
34	0.00630	0.1600	0.1981	0.0201	1.105	0.209
33	0.00710	0.1803	0.2235	0.0255	0.870	0.236
32	0.00800	0.2032	0.2489	0.0324	0.6853	0.261
31	0.00890	0.2261	0.2743	0.0401	0.5537	0.287

30	0.01000	0.2540	0.3048	0.0507	0.4386	0.319
29	0.0113	0.2870	0.3404	0.0647	0.3435	0.356
28	0.0126	0.3200	0.3759	0.0804	0.2762	0.393
27	0.0142	0.3607	0.4191	0.1022	0.2175	0.438
26	0.0159	0.4039	0.4699	0.128	0.1735	0.491
25	0.0179	0.4547	0.5232	0.162	0.1369	0.547
24	0.0201	0.5105	0.5817	0.205	0.1086	0.608
23	0.0226	0.5740	0.6502	0.259	0.08586	0.679
22	0.0253	0.6426	0.7214	0.324	0.06852	0.754
21	0.0285	0.7239	0.8052	0.412	0.05399	0.841
20	0.0320	0.8128	0.8966	0.519	0.04283	0.937
19	0.0359	0.9119	1.003	0.653	0.03403	1.048
18	0.0403	1.024	1.118	0.823	0.02700	1.168
17	0.0453	1.151	1.247	1.040	0.02137	1.303
16	0.0508	1.290	1.389	1.308	0.01699	1.452
15	0.0571	1.450	1.557	1.652	0.01345	1.627
14	0.0641	1.628	1.737	2.082	0.01067	1.815
13	0.0720	1.829	1.943	2.627	0.008460	2.030
12	0.0808	2.052	2.172	3.308	0.006717	2.270
11	0.0907	2.304	2.413	4.168	0.00533	2.540
10	0.1019	2.588	2.720	5.261	0.004224	2.842

ปริมาณของกระแสปกติจะบังคับเท่าเดิมแต่ความหนาแน่นของกระแสใน漉คทองแดงที่ไกส์ผิวจะมีค่าสูงกว่าเพราระกระแสส่วนใหญ่ในไอล์ไฟฟ้าที่ผิวเท่านั้น การไอล์ของกระแสใน漉วนจะเป็นการจำกัดพื้นที่นำกระแสของ漉คทองแดง และมีผลเหมือนพื้นที่นำกระแสของ漉ค漉ทองแดงลดลงจากพื้นที่หน้าตัดเดิมของมัน

หากผิวของ漉คทองแดงถูกลงมาในเนื้อ漉คทองแดง จนถึงจุดที่ค่าความหนาแน่นของกระแสไม่ลดค่าลงมาเหลือเพียง 37 เปอร์เซ็นของค่าความหนาแน่นกระแสที่ผิวนั้นเราเรียกระยะนี้ว่า เป็นความหนาผิวนำกระแสของ漉ค漉ทองแดง (Skin Depth) ดังที่แสดงไว้ในรูปที่ 2.6 ความหนาของผิวนำกระแสนี้ขึ้นอยู่กับความถี่ และสำหรับ漉คทองแดงที่ 100 องศาเซลเซียสความหนาแน่นของผิวนำกระแสจะมีค่า

$$\Delta = \sqrt{\frac{5.62}{f}} \quad (2.10)$$

เมื่อ  $\Delta$  คือ ความหนาของผิวตัวนำ เป็นมิลลิเมตร  
 $f$  คือ ความถี่ของกระแส เป็นกิโลเฮิริตซ์

2) อัตราส่วนระหว่างความต้านทานที่กระแสลับต่อความต้านทานที่กระแสตรงของลวดทองแดง ( $F_R$ )

เนื่องจากความต้านทานของคลื่นนี้จะขึ้นอยู่กับค่าพื้นที่หน้าตัดนำของกระแสของมัน และที่กระแสลับพื้นที่หน้าตัดตัวนำกระแสของคลื่นทองแดงจะลดลง เพราะกระแสไฟล์ได้เฉพาะที่ผิวนำกระแส ดังนั้นความต้านทานที่กระแสลับของลวดทองแดงจึงมีค่ามากกว่าความต้านทานเมื่อนับนำมาระยะตรง

อัตราส่วนระหว่างความต้านทานของคลื่นทองแดงที่กระแสลับต่อความต้านทานของมันที่กระแสตรง หรือ  $F_R$  (Resistance Factor) อาจหาได้จาก

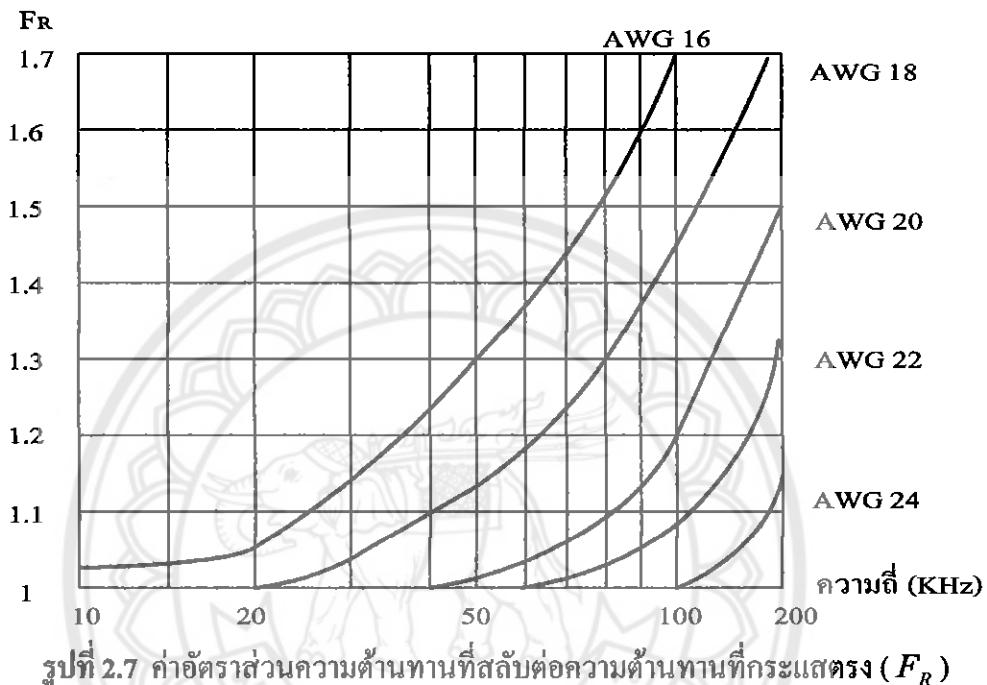
$$F_R = \frac{R_{ac}}{R_{dc}} = \frac{(d/2\Delta)^2}{(d/2\Delta)^2 - (d/2\Delta - 1)^2} \quad (2.11)$$

เมื่อ  $R_{ac}$  คือ ค่าต้านทานของคลื่นทองแดงที่กระแสลับ เป็นโอม  
 $R_{dc}$  คือ ค่าต้านทานของคลื่นทองแดงที่กระแสตรง เป็นโอม  
 $d$  คือ เส้นผ่านศูนย์กลางของคลื่นทองแดง เป็นมิลลิเมตร  
 $\Delta$  คือ ความหนาผิวนำกระแส เป็นมิลลิเมตร

ในทางปฏิบัติ ค่า  $F_R$  อาจหาได้จากการประมาณค่า โดย

$$F_R = \frac{1}{4} \left( \frac{d}{\Delta} + 1 \right) \quad \text{ถ้า } \frac{d}{\Delta} \geq 5 \quad (2.12)$$

เมื่อเปรียบเทียบค่า  $F_R$  ของ漉漉ดทองแดงเบอร์ AWG 22 กับ漉ดทองแดงเบอร์ AWG 18 ที่มีความถี่ 100 กิโลเฮิรตซ์ตามรูปที่ 2.7 จะได้ว่า ที่ 100 กิโลเฮิรตซ์ ค่าความต้านทานที่กระแสสลับ ( $R_{ac}$ ) ของ漉ดทองแดงเบอร์ AWG 18 เมื่อเทียบกับค่าด้านท่านที่กระแสตรง ( $R_{dc}$ ) จะมีค่ามากกว่า漉ดทองแดงเบอร์ AWG 22 ขณะเดียวกันที่มีความถี่กับ 20 กิโลเฮิรตซ์จะไม่มีผลต่อความต้านทานของ漉ดทองแดง



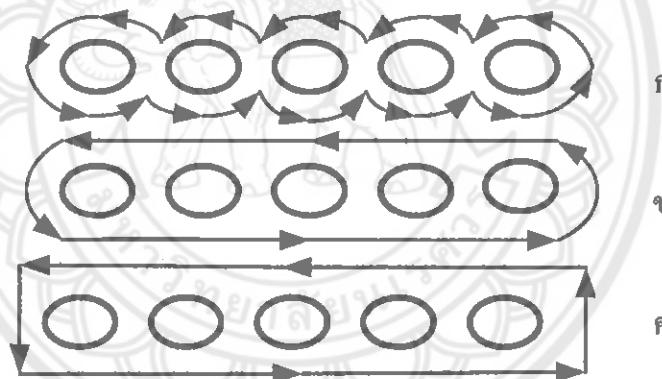
จากรูปที่ 2.7 นับเป็นค่าอัตราส่วนความต้านทานที่กระแสสลับต่อความต้านทานที่กระแสตรง ( $F_R$ ) ของ漉ดทองแดงต่อความถี่ที่漉ดทองแดงขนาดต่างๆ ความหมายของค่าอัตราส่วน ( $F_R$ ) ไม่ได้แสดงว่าค่าความต้านทานของ漉ดทองแดง ที่กระแสสลับจะมีค่ามากขึ้นเมื่อขนาดของ漉ดทองแดงมากขึ้น โดยที่ความเป็นจริงแล้วค่าความต้านทานของ漉ดทองแดงที่กระแสสลับจะมีค่าคล่องเมื่อขนาดของ漉ดทองแดงใหญ่ขึ้น แต่เนื่องจากค่าความต้านทานที่กระแสตรงมีค่าคล่องมากกว่าเมื่อขนาดของ漉ดทองแดงใหญ่ขึ้น ดังนั้นค่าอัตราส่วน  $F_R$  จึงมีค่ามากขึ้น การใช้漉ดทองแดงขนาดใหญ่จึงไม่เกิดประโยชน์ใดๆ ที่มีความถี่สูงๆ เพราะเกิดการสูญเสียมากกว่าเนื่องจากค่าความต้านทานที่กระแสสลับของมันจะลดลงที่มีกระแสไฟลัด

ค่าอัตราส่วน  $F_R$  จึงมีประโยชน์มากในการเลือกขนาดของ漉ดทองแดง การกำหนดขนาดของ漉ดทองแดงและวิธีการพันคลอดที่ให้ค่า  $F_R$  น้อยที่สุด จะทำให้สูญเสียที่เกิดขึ้นใน漉ดทองแดงนี้ค่าน้อยที่สุดด้วยเช่นกัน

### 3) ผลจากการเรียงช้อนกันของขดลวด (Proximity Effect)

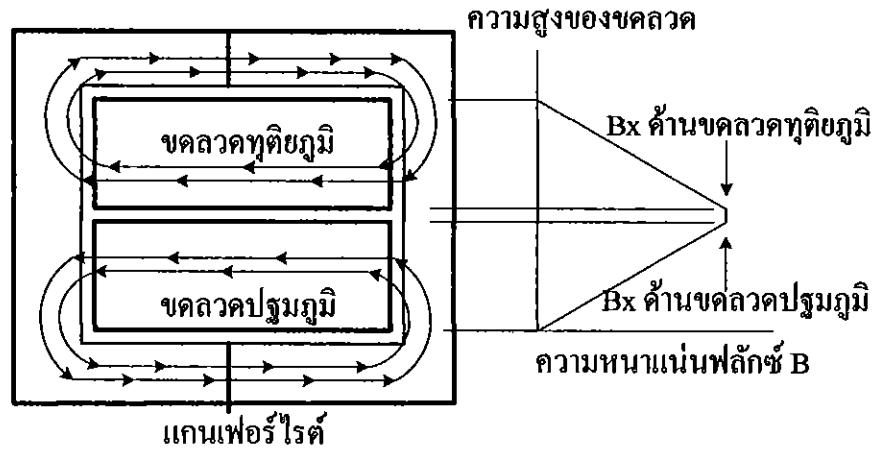
ปกติค่าความซึมซาบแม่เหล็ก ( $\mu$  (มิว)) ของแกนเฟอร์ไรต์จะมีค่าสูงมาก แกนจะจับฟลักซ์แม่เหล็กที่เกิดขึ้นจากการเหนี่ยวนำของขดลวดในหม้อแปลงให้วิ่งอยู่ภายในแกน เฟอร์ไรต์เท่านั้นแต่โดยความจริงแล้ว บังมีฟลักซ์แม่เหล็กบางส่วนสามารถวิ่งออกจากแกนแม่เหล็กตัดผ่านขดลวดได้ ฟลักซ์เหล่านี้เรียกว่า ฟลักซ์รั่ว (Leakage Flux) ฟลักซ์รั่วไม่ได้เกิดจากคุณภาพที่ไม่ดีของวัสดุที่ใช้ทำแกนเฟอร์ไรต์ แต่ผลเกิดจากการพันขดลวดโดยตรงจะได้ก่อตัวต่อไป

รูปที่ 2.8 แสดงภาพตัดขวางชั้นของขดลวดในทองแดงในหม้อแปลง และเส้นวงฟลักซ์แม่เหล็กบางส่วนที่เกิดขึ้นขณะกระแสไฟผ่านขดลวด การหักล้างกันของฟลักซ์แม่เหล็กระหว่างลวดจะทำให้เกิดเส้นฟลักซ์บนนาไปทั้งหมดของขดลวดดังรูปที่ 2.8 (ๆ) เมื่อเส้นฟลักซ์ตัดแกนเฟอร์ไรต์ แกนจะบังกับให้ฟลักซ์วิ่งอยู่ในแกนเนื่องจากมีค่าซึมซาบของแม่เหล็ก  $\mu$  ของแกนที่มีค่าสูงมาก ดังรูปที่ 2.8 (ก) และเส้นแรงฟลักซ์ที่เกิดจากชั้นของลวดทองแดงหลายชั้นก็จะเป็นดังรูปที่ 2.10 ซึ่งเป็น ฟลักซ์รั่วนั่นเอง



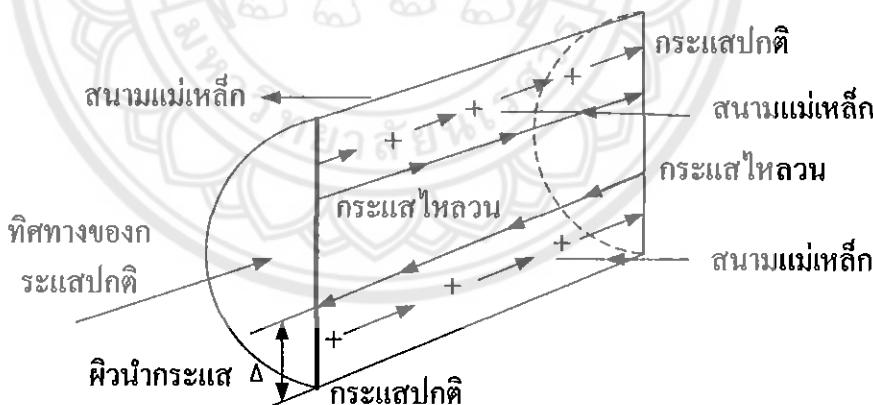
รูปที่ 2.8 ลักษณะของการเกิดฟลักซ์รั่วภายในหม้อแปลงความถี่สูงหลาย匝

ค่าความหนาแน่นของฟลักซ์รั่ว ( $B_x$ ) จะเพิ่มขึ้น เมื่อจำนวนชั้นของลวดทองแดง เพิ่มขึ้น จากรูปที่ 2.9 จะเห็นได้ว่า  $B_x$  มีค่าสูงสุดที่ระยะชั้นสูงสุดของลวดทองแดงจากแกนและมีค่าลดลงตามลำดับฟลักซ์รั่วจะตัวบนกับชั้นของลวดทองแดงโดยตัดผ่านและตั้งฉากกับเส้นลวดทองแดงในชั้น ซึ่งทำให้เกิดกระแสไหลวนขึ้นในลวดทองแดง



รูปที่ 2.9 ลักษณะของฟลักซ์ร้าและค่าความหนาแน่นของฟลักซ์ร้า  $B_x$

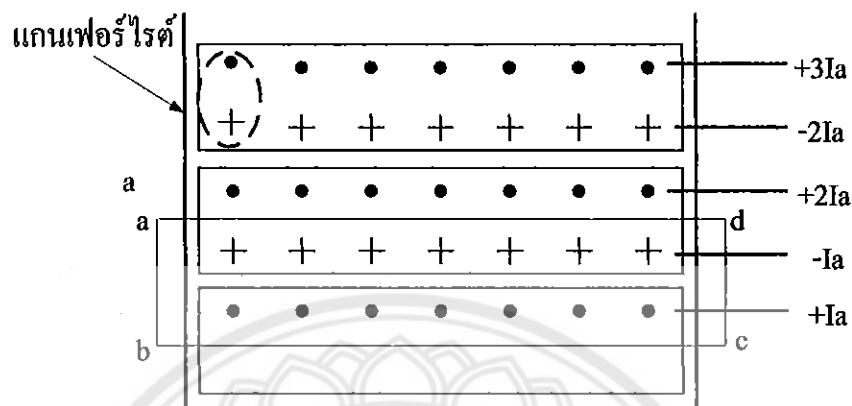
เนื่องจากมีฟลักซ์ร้าที่เกิดขึ้น ขดลวดทองแดงในห้องเปล่งจิงอยู่ในลักษณะเช่นเดียวกับ การนำขดลวดไปวางในสนามแม่เหล็ก และเกิดกระแสไฟลุวนที่บริเวณผิวนำกระแสของขดลวด ที่สัมผัสกับสนามแม่เหล็ก ผลของขดลวดทองแดงที่วางอยู่ในฟลักซ์ร้าทำให้มีกระแสไฟลุวน เกิดขึ้นที่ผิวค้านบนและค้านล่างของขดลวดทองแดงและทำให้ความหนาแน่นกระแสที่ผิวค้านบน มีค่ามากกว่าผิวค้านล่างดังรูปที่ 2.10



รูปที่ 2.10 ลักษณะของฟลักซ์ร้าทำให้มีกระแสไหลวนเกิดขึ้นที่ผิว

ถึงการซ้อนกันของขดลวดมีจำนวนชั้นมากขึ้น จะยิ่งมีผลทำให้ความหนาแน่นของ กระแสไหลวนมีค่ามากขึ้นด้วย ซึ่งจะพิจารณาได้ดังต่อไปนี้ จากรูปที่ 2.11 เพื่อให้ง่ายจึงกำหนด ให้ขดลวดทองแดงที่เรียบเรียงกันอยู่ในแต่ละชั้นเปรียบเทียบหนึ่งกับอีกหนึ่ง หนึ่งชั้นของขดลวด แผ่นทองแดงนี้จึงวางอยู่ในฟลักซ์ร้า

พิจารณาแผ่นทองแดงที่ชั้นแรกที่ติดอยู่กับแกนฟลักซ์ร์จะตัดผ่านพิวค้านบนและทำให้เกิดกระแสไฟลุนไหลดที่ผิวนำกระแสของแผ่นทองแดง สำหรับผิวด้านล่างที่ติดกับแกนจะไม่มีฟลักซ์แม่เหล็กตัดผ่านผิวนเนื่องจากอยู่ติดกับแกน ดังนั้นกระแสจะไฟลุนเฉพาะที่ผิวด้านบนเท่านั้น

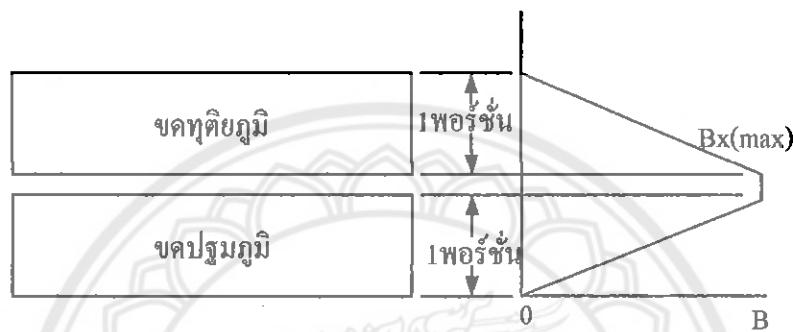


รูปที่ 2.11 การเปรียบเทียบความคงดองคงที่พันเรียงกันแต่ละชั้น

ถ้าสมมติให้ค่ากระแสที่ผิวด้านบนของแผ่นทองแดงในชั้นแรกนี้มีค่าเท่ากับ  $+I_a$  และเมื่อพิจารณาแผ่นทองแดงในชั้นที่สอง ผลของฟลักซ์ร์จะทำให้กระแสไฟลุนเกิดขึ้นที่ผิวนำกระแสทั้งค้านบนและค้านล่าง สำหรับที่เนื้อกลางของแผ่นทองแดงจะไม่มีกระแสไฟลุนเนื่องจากสนามแม่เหล็กมีค่าเท่ากับศูนย์(สนามแม่เหล็กสามารถทะลุผ่านตัวนำเข้ามาได้เพียงระยะผิวนำกระแสเท่านั้น) ดังนั้นผลรวมของสนามแม่เหล็กตามทาง ( $\oint H dl$ ) รอบวง abcd จึงมีค่าเท่ากับศูนย์ และผลรวมของกระแสภายในวงรอบ abcd จะต้องมีค่าเท่ากับศูนย์ด้วย ตามกฎของแอล์เบร็ต เมื่อจากค่ากระแสที่ผิวนบนของแผ่นทองแดงชั้นแรกมีค่าเท่ากับ  $+I_a$  ดังนั้นค่ากระแสที่ผิวล่างของแผ่นทองแดงในชั้นที่สองจะต้องมีค่าเท่ากับ  $-I_a$  และหากในทิศทางกันข้ามผลรวมของกระแสจึงจะมีค่าเท่ากับศูนย์ แต่กระแสที่ไฟลุนring ในทองแดงแต่ละชั้นมีค่าเท่ากัน (แผ่นทองแดงในแต่ละชั้นเกิดจากแผ่นทองแดงชิ้นเดียวกันพันรอบแกน) ค่ากระแสที่ไฟลุนในแผ่นทองแดงชั้นที่สองจึงต้องมีค่าเท่ากับ  $+2I_a$  ในทำนองเดียวกัน ค่ากระแสที่ไฟลุนของทองแดงในชั้นที่สามก็จะมีค่าเท่ากับ  $+3I_a$  และกระแสที่ผิวนในแต่ละชั้นจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามจำนวนชั้น

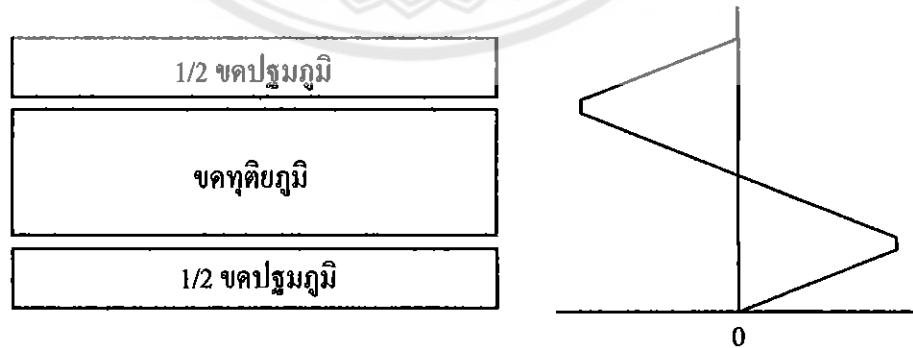
#### 4) เทคนิคการพันขดลวดทองแดงสำหรับหม้อแปลงความถี่สูง (Wind Topology)

การจัดรูปแบบการพันของลวดตัวทวนนำทางแดง คำว่า “พอร์ชั่น (Portion)” ใน การพันขดลวดทองแดงจะมีความหมายคือ หนึ่งพอร์ชั่นกำหนดจากชั้นของขดลวดทองแดงชุดหนึ่งๆ ที่มี ค่าความหนาแน่นฟลักซ์ร่วงน้อยที่สุด ไปจนถึงชั้นที่มีค่าความหนาแน่นฟลักซ์ร่วงสูงสุด และจำนวน ชั้นในหนึ่งพอร์ชั่น (Layer) จะหมายถึง จำนวนชั้นของขดลวดทองแดงที่ซ้อนกันอยู่ภายในพอร์ชั่น นั้นๆ จากรูปที่ 2.12 จะเห็นได้ว่า จำนวนชั้นทั้งหมดของขดลวดปูนภูมิพันอยู่ในหนึ่งพอร์ชั่น และ จำนวนชั้นทั้งหมดของอุตติภูมิก็พันอยู่ในหนึ่งพอร์ชั่นเช่นเดียวกัน

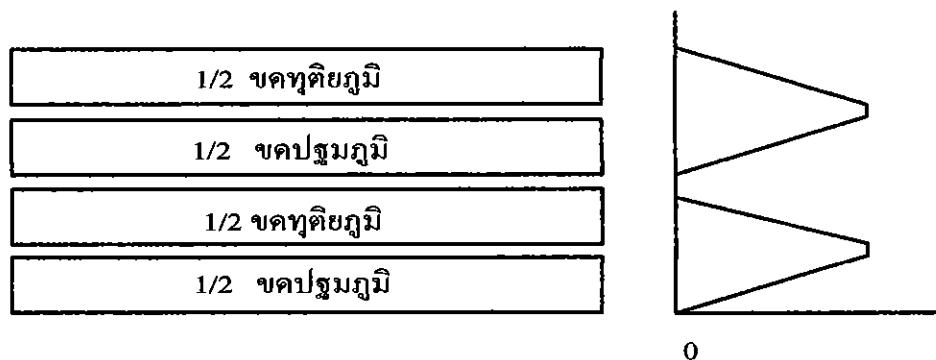


รูปที่ 2.12 การกำหนดจำนวนชั้นในพอร์ชั่น

ถ้าแยกขดปูนภูมิออกมาเป็นสองส่วนดังรูปที่ 2.13 ทำให้ความหนาแน่นของฟลักซ์ร่วง และจำนวนชั้นต่อหนึ่งพอร์ชั่นลดลงครึ่งหนึ่งด้วย (เนื่องจากความหนาแน่นของฟลักซ์ร่วงจะขึ้นกับ จำนวนชั้นของขดลวด) ไม่ว่าจะเป็นที่ขดปูนภูมิหรืออุตติภูมิก็ตาม ดังนั้นหากมีการจัดรูปแบบใน การพันขดลวดทองแดงที่เหมาะสม จะทำให้ช่วยลดการสูญเสียที่เกิดขึ้นในของขดลวดทองแดงได้



รูปที่ 2.13 การลดลงความหนาแน่นฟลักซ์ร่วงสูงสุดของฟลักซ์ร่วง



รูปที่ 2.14 การลดจำนวนชั้นจากรูปที่ 2.12 ลงไปอีก โดยแบ่งครึ่งพันของทุติยภูมิ

### การจัดขดลวดแบบธรรมด้า (Simple Winding)

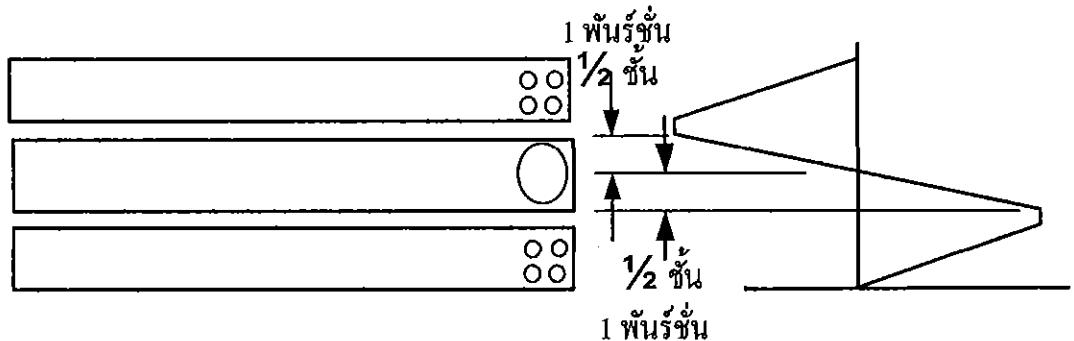
การจัดขดลวดในหม้อแปลงแบบธรรมด้าคือ การพันขดลวดทองแดงให้ครบรอบที่ต้องการทับซ้อนกันไปทีละชุดไปเรื่อยๆ ตัวอย่างเช่น ถ้าขดปฐมภูมิมีจำนวนรอบเท่ากันห้าสิบรอบ และขดทุติยภูมิมีจำนวนรอบเท่ากันสิบรอบ การจัดขดลวดแบบธรรมด้าจะทำได้โดยการพันขดลวดทองแดงรอบแกนให้ครบห้าสิบรอบเพื่อให้เป็นขดปฐมภูมิ จากนั้นจึงพันขดทุติยภูมิทับไปบนปฐมภูมิให้ครบจำนวนรอบ การจัดขดลวดแบบธรรมด้าจึงเป็นลักษณะดังรูปที่ 2.11

### การจัดขดลวดแบบแบ่งครึ่งพัน (Split Winding)

การจัดขดลวดทองแดงในหม้อแปลงแบบแบ่งครึ่งพันคือ การพันขดลวดทองแดงให้ได้ครบจำนวนรอบที่ต้องการ โดยแบ่งขดลวดออกเป็นสองส่วน และนำขดลวดชุดอื่นมาแทรกกันระหว่างกลาง การจัดขดลวดแบบนี้จะเป็นการจัดขดปฐมภูมิคั่งในรูปที่ 2.12 ถ้าแบ่งครึ่งที่ถูกแบ่งแล้วออกไปอีกด้วย ก็จะได้ลักษณะดังที่ในรูปที่ 2.13 การแบ่งส่วนพันจะเป็นการลดค่าความหนาแน่นของฟลักซ์ร่วงและจำนวนชั้นในแต่ละพอร์ชั่นลงได้ หลักการสำคัญของการจัดขดลวดแบบแบ่งครึ่งพันคือจำนวนรอบของขดลวดที่ต้องการแบ่งพันจะต้องเป็นคู่ และจำนวนชั้นทั้งหมดก่อนแบ่งพันจะต้องเป็นจำนวนคู่ด้วย เพื่อความสมมาตรหลังจากการพันแล้ว

### การจัดขดลวดแบบพันแทรกกลาง (Sandwiched Winding)

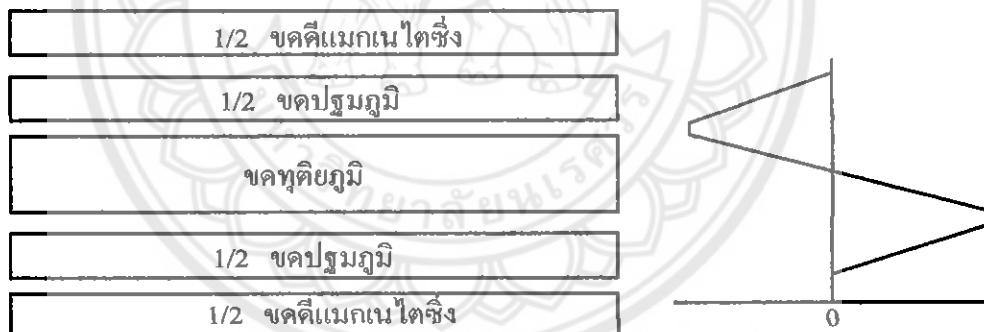
คือการจัดขดพันให้ครบตามจำนวนรอบที่ต้องการ โดยการพันแทรกเข้าไประหว่างกลางของขดลวดที่พันแบบแบ่งครึ่งพัน การพันขดลวดแบบแทรกกลางนี้ถึงแม้จะมีขดลวดทองแดงเพียงแค่ชั้นเดียว ก็อาจจะเกิดพอร์ชั่นได้ถึงสองพอร์ชั่นดังรูปที่ 2.14 โดยจำนวนชั้นต่อหนึ่งพอร์ชั่นจะมีค่าเท่ากัน “ครึ่งชั้น” ซึ่งกล่าวไว้ว่าเป็นชั้นที่มีความสูงเป็นครึ่งหนึ่งของชั้นปกตินั่นเอง ในทำนองเดียวกัน หนึ่งพอร์ชั่นที่ได้จากการพันแทรกกลางนี้อาจมีจำนวนรอบจำนวนครึ่งรอบได้ถ้าในครึ่งชั้นของพอร์ชั่นนั้นมีจำนวนเป็นเลขคี่



รูปที่ 2.15 ลักษณะของพอร์ชั้นที่มีจำนวนชั้นเท่ากันกับครึ่งชั้น

#### หม้อแปลงสำหรับฟอร์เวิร์คคอนเวอร์เตอร์

หม้อแปลงในฟอร์เวิร์คคอนเวอร์เตอร์จะมีคลาดที่สำคัญอยู่ 3 ส่วน คือ ขดปฐมภูมิ ขดทุติยภูมิ และขดคีเมนกน์ トイซิ่ง การจัดคลาดอาจทำได้ดังรูปที่ 2.15 โดยแยกส่วนของขดปฐมภูมิ และแทรกกลางด้วยทุติยภูมิ และเพื่อไม่ให้เกิดการสูญเสียในขดคีเมนกน์ トイซิ่งจะต้องมีส่วนที่มันไม่ได้นำกระแส จึงควรจัดคลาดแมกนีต์ให้อยู่นอกสุด เพื่อให้เกิดการสูญเสียในขดคีเมนกน์ トイซิ่ง ขณะมันนำกระแสเท่านั้น

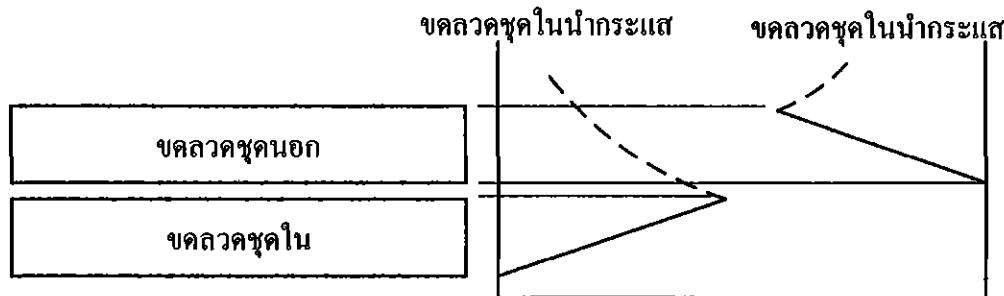


รูปที่ 2.16 การจัดคลาดทองแดงสำหรับฟอร์เวิร์คคอนเวอร์เตอร์ที่เหมาะสม

#### 5) หม้อแปลงสำหรับฟลักแบบคอนเวอร์เตอร์

สำหรับหม้อแปลงสำหรับฟลักแบบคอนเวอร์เตอร์จะมีคลาดที่สำคัญเพียงขดปฐมภูมิ และขดทุติยภูมิซึ่งจะสับกันนำกระแสคือ เมื่อขดปฐมภูมินำกระแส ขดคลาดทุติยภูมิจะไม่นำกระแสในทางกลับกัน เมื่อขดทุติยภูมินำกระแสแล้วคลาดปฐมภูมิจะไม่นำกระแส ลักษณะค่าความหนาแน่นฟลักซ์จะเป็นดังรูปที่ 2.17

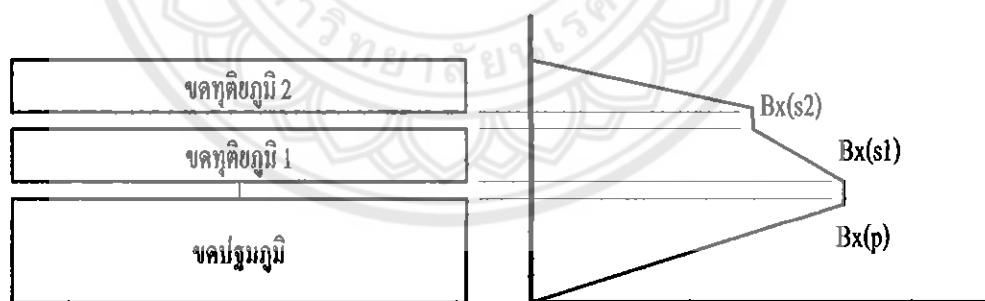
เนื่องจากฟลักซ์ร่วงจากคลาดชันในจะทำให้เกิดการสูญเสียที่คลาดชันนอกได้ แม้ว่า คลาดชันนอกจะไม่ได้นำกระแส ดังนั้นการวางแผนของปูนภูมิหรือคลุติภูมิควรพิจารณาให้คลาดชันนี้ขาดเด็กกว่าอยู่ด้านบนเสมอ



รูปที่ 2.17 ลักษณะของค่าความหนาแน่นฟลักซ์ร่วง

#### หน้มอแปลงที่มีค่าแรงดันเอาต์พุตหลายค่า

กรณีที่ต้องการให้หน้มอแปลงมีแรงดันเอาต์พุตหลายค่า ขอ漉วคลุติภูมิจะมีหลายชุด ด้วยกันลักษณะความหนาแน่นฟลักซ์ร่วงที่เกิดขึ้นในหน้มอแปลงที่มีแรงดันเอาต์พุตหลายค่าอาจ เป็นได้ดังในรูปที่ 2.18 ในกรณีนี้จะเห็นได้ว่า ความหนาแน่นของฟลักซ์ร่วงในตำแหน่งของคลุติภูมิ ที่ 1 ไม่ได้เริ่มจากศูนย์และจะมีการสูญเสียเกิดขึ้นได้สูง การวางแผนของคลาดทางดึงในตำแหน่งเช่นนี้ จึงควรเลือกคลาดชุดที่มีขนาดของคลาดเด็กที่สูด (กระแสค่าต่ำสุด) จากคลาดในหน้มอแปลง



รูปที่ 2.18 ลักษณะความหนาแน่นของฟลักซ์ร่วงในหน้มอแปลงที่มีคลุติภูมิหลายชุด

6) การเลือกขนาดคลาดท้องแดงและการพันหม้อแปลงความถี่สูงตามวิธีของ J.Jongsma

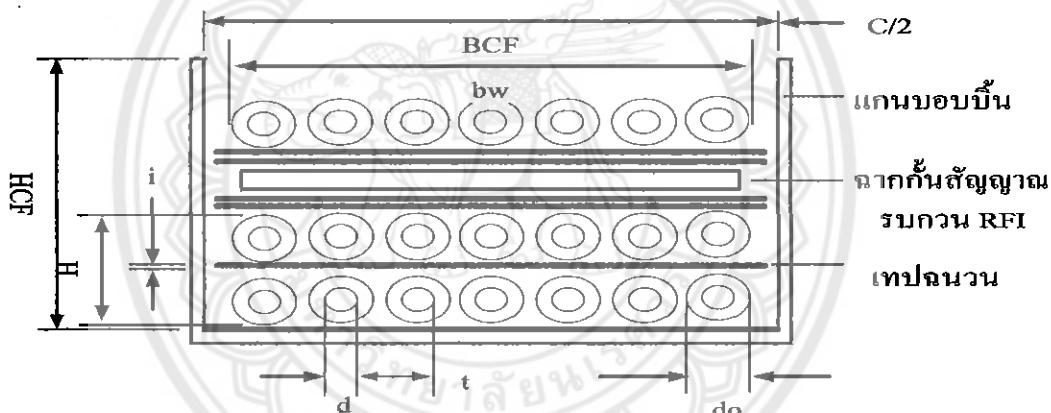
Jongsma ได้ข้อสรุปในการพันหม้อแปลงความถี่สูงด้วยคลาดท้องแดง เพื่อให้เกิดการสูญเสียในขดลวดน้อยที่สุด ไว้ดังนี้คือ

เมื่อต้องการพันหม้อแปลงความถี่สูงด้วยคลาดท้องดังรูปที่ 2.18 โดยกำหนดให้

$$T = \frac{b_w}{N} \quad (2.13)$$

ที่ 100 องศาเซลเซียส  $\Delta = \sqrt{\frac{5.62}{f}}$  (2.14)

เมื่อ  $N$  ก็คือ จำนวนรอบของขดลวดท้องแดง



รูปที่ 2.19 ตามกำหนดค่าต่างๆในการพันหม้อแปลงความถี่สูงตามวิธี Jongsma

- โดยที่  $b_w$  = ระยะที่สามารถใช้คลาดท้องแดงได้ (mm)  
 $B_{CF}$  = ความกว้างของบอนบีน (mm)  
 $C$  = ระยะห่างจำเป็น (Creepage) (mm)  
 $d$  = ขนาดผ่านศูนย์กลางของขดลวดท้องแดง (mm)  
 $d_0$  = ขนาดผ่านศูนย์กลางเมื่อร่วมกันเคลื่อน (mm)  
 $H$  = ความสูงของขดลวดท้องแดง (mm)  
 $H_{CF}$  = ความสูงของขดลวดท้องแดงทึ่งหมุดที่บอนบีนจะได้รับ (mm)  
 $i$  = ความหนาของเทปปันวน (mm)  
 $t$  = ระยะห่างระหว่างคลาดท้องแดง (mm)

ตามกำหนดค่าต่างๆ ในการพันหม้อแปลงความถี่สูงตามวิธี Jongsma จะได้ว่า

1. ถ้าค่าของอัตราส่วน  $T/\Delta > 2$  การพันขดลวดทองแดงให้ครบจำนวนรอบภายในชั้นเดียว (Single Layer) จะเกิดการสูญเสียในขดลวดทองแดงน้อยที่สุด แต่ในการพันแทรกกลาง เมื่อค่า  $T/\Delta > 2$  การพันขดลวดให้ได้ครบรอบจำนวนรอบภายในครึ่งชั้น (Half Layer) จะเกิดการสูญเสียในขดลวดทองแดงน้อยที่สุด

2. ถ้าค่าของอัตราส่วน  $T/\Delta > 2$  การพันขดลวดทองแดงให้ได้ครบจำนวนรอบสามารถพันได้มากกว่าหนึ่งชั้น แต่จำนวนชั้นยังน้อยกว่าจำนวนรอบตามไปด้วย

3. กรณีที่การพันขดลวดทองแดงให้ได้ครบตามจำนวนรอบมีจำนวนชั้นมากกว่าหนึ่งชั้น การพันขดลวดทองแดงแบบเว้นระยะเท่าๆ กัน (Spced Winding) ค่าความต้านทานที่กระแสสัลบของขดลวดจะน้อยกว่าการพันทองแดงแบบให้เรียงซึ่ดติดกัน แต่กรณีที่การพันขดลวดทองแดงให้ได้ครบจำนวนรอบมีจำนวนชั้น ได้เพียงชั้นเดียวหรือน้อยกว่า ต้องพันขดลวดทองแดงให้เรียงซึ่ดติดกันเท่านั้น

### การเลือกขนาดของลวดทองแดง

(1) ให้คำนวณค่าประมาณของเส้นผ่านศูนย์กลางของขดลวดทองแดงจาก

$$d_{id} = \left( \frac{17.1b_w}{N \cdot f} \right)^{\frac{1}{3}} \quad (2.15)$$

เมื่อ  $d_{id}$  คือ ค่าจำนวนของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางขดลวดทองแดง เป็นมิลลิเมตร

$b_w$  คือ ค่าระยะสำหรับพันขดลวดบนบันนี่ เป็นมิลลิเมตร

$N$  คือ จำนวนรอบของขดลวด เป็นรอบ

$f$  คือ ความถี่การทำงานของหม้อแปลง เป็นกิโล赫ertz

(2) ขนาดของลวดทองแดงที่มีผลิตจริงจากตารางที่ 2.1 ที่ใกล้เคียงกับค่าที่คำนวณ  $d_{id}$  มากที่สุด บันทึก  $d$ ,  $d_0$ ,  $t_{min}$ , และ  $R_{dc}$  เอาไว้

(3) คำนวณจำนวนชั้นของขดลวดทองแดงที่จะได้เมื่อพันครบจำนวนรอบจากค่า  $t_{min}$  ในข้อที่ 2 ดังนี้

$$P_{id} = \frac{N}{\left( \frac{b_w}{t_{min}} - 1 \right)} \quad (2.16)$$

3.2 ถ้าค่าจำนวนชั้น  $P_{id} \leq 1$  ขนาดของขดลวดทองแดงที่เลือกมาใช้ไม่ได้ ให้เลือกขนาดของลวดทองแดงใหม่ โดยเปลี่ยนไปใช้วิธีคำนวณในกรณีที่จำนวนชั้นเดียวหรือครึ่งชั้น

3.3 ปิดเศษของจำนวนชั้น  $P_{id}$  ที่คำนวณได้ (ถ้ามี) ให้เป็นจำนวนเต็ม โดยปัดเศษเพื่อให้เป็นจำนวนเต็ม  $P$

(4) คำนวณระยะห่างขดลวดในชั้น (Wingding) จาก

$$t = \frac{pb_w}{(N + p)} \quad (2.17)$$

ในการพันขดลวดระยะห่างของขดลวดระหว่างรอบจะกำหนดให้จากค่า  $t$  ที่คำนวณได้

(5) เลือกค่าความหนาเทาปุณวนเพื่อรองรับขดลวดในแต่ละชั้น ความสูงของขดลวดบนบอนนี้เมื่อพันครบรอบจะมีค่าเท่ากับ

$$H_{id} = p(d_0 + i) \quad (2.18)$$

เมื่อ  $i$  คือ ความหนาของเทาปุณวนที่ใช้ เป็นมิลลิเมตร

(6) คำนวณค่าอัตราส่วน  $F_R$  จาก

$$F_R = 1 + \frac{1}{2} \left( d / d_{id} \right)^6 \quad (2.19)$$

(7) คำนวณค่าความต้านทานที่กระแสสัมบ่อหนึ่งหน่วยความยาว ( $R_{ac}$ ) จาก

$$R_{ac} = F_R R_{dc} \quad (2.20)$$

เมื่อ  $R_{dc}$  คือ ค่าความต้านทานที่กระแสตรงต่อหนึ่งหน่วยความยาวของลวดทองแดง (ดูได้จากตารางที่ 2.1)

(8) ดังนั้นกำลังสูญเสียที่เกิดขึ้นในขดลวด  $P_w$  จะมีค่า

$$P_w = CI_{RMS}^2 \cdot N \cdot l_{av} \cdot R_{ac} \quad (2.21)$$

เมื่อ  $l_{av}$  คือ ค่าเฉลี่ยของขดลวดต่อหนึ่งรอบ เป็นเมตร

$C$  คือ ค่าตัวคูณเท่ากับ 1 (กรณีการพันขดลวดแบบธรรมชาติ) และ เท่ากับ 2  
(กรณีเป็นการพันแบบแยกส่วนพัน)

$I_{RMS}$  คือ ค่ากระแส RMS ที่ขดลวด เป็นแอมป์

## กรณีจำนวนชั้นมีขั้นเดียวหรือไม่เพียงครึ่งชั้น

(1) กำหนดจำนวนชั้น  $p$  ให้มีค่าเท่ากับ 1

$$(2) \text{ คำนวณระยะห่างของคลื่นที่หวัดระหว่างรอบ } t = p \frac{b_w}{(N + p)}$$

(3) เลือกขนาดของขดลวดจากตารางที่ 2.1 ให้มีค่า  $t_{\min} \leq t \leq t_{\max}$  ค่ามากที่สุดในตารางที่น้อยที่กว่าหรือเท่ากับ  $t$  ) บันทึกค่า  $d$ ,  $d_0$ , และ  $R_{ac}$  และให้กำหนดค่าความหนาของเทปปอนนวน  $i$  เอาไว้ด้วย

(4) คำนวณค่าความสูงของขดลวดเมื่อพันครบจำนวนรอบจาก

$$H = d_0 + i \quad (2.22)$$

(5) คำนวณค่า  $\varphi$  จาก โดย ( $f$  เป็น (KHz)  $d$  และ  $t$  เป็น mm )

$$\varphi = \sqrt{\frac{0.124 f d^3}{t}} \quad (2.23)$$

(6) หาค่าอัตราส่วน  $F_R$  ได้ โดยใช้ค่า  $\varphi$  ที่คำนวณได้จากข้อ 5 กรณีที่ค่า  $F_R$  เกินจากที่แสดงไว้ในกราฟ ให้กำหนดค่า  $F_R = p\varphi$

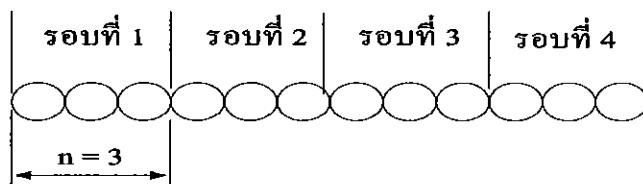
(7) คำนวณค่า  $R_{ac}$  จาก  $R_{ac} = F_R R_{dc}$

(8) คำนวณค่ากำลังสูญเสียที่เกิดขึ้นในขดลวดได้จาก

$$P_w = C I_{RMS}^2 \cdot N \cdot l_{av} \cdot R_{ac} \quad (2.24)$$

## การพันขดลวดโดยใช้ลวดทองแดงขนาดกัน

เพื่อลดค่าความต้านทานของขดลวดทองแดงลงไปอีก โดยการใช้ลวดทองแดงมาขนาดกันแล้วพันให้ครบตามจำนวนรอบนั้น สามารถทำได้ดังแสดงในรูปที่ 2.20



รูปที่ 2.20 การพันขดลวดโดยขดลวดทองแดงขนาดกัน

การใช้ขดลวดทองแดงขนาดก้นน้ำนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับการใช้ลวดทองแดงเพียงเส้นเดียว จะทำให้ค่าความต้านทานที่กระแสสัมบูรณ์ของขดลวดและขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของลวดทองแดงลดลงประมาณ  $n^{-\frac{1}{3}}$  แต่ความสูงจะเพิ่มขึ้นประมาณ  $n^{-\frac{1}{3}}$  เมื่อ  $n$  คือ จำนวนเส้นของขดลวดทองแดงขนาดกัน

โดยทั่วไปการขนาดลวดทองแดง 2 เส้นจะลดค่าความต้านทานที่กระแสสัมบูรณ์ของขดลวดลงได้ประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ แต่ความสูงของขดลวดจะมีค่าเพิ่มขึ้นที่ประมาณ 25 เปอร์เซ็นต์ การขนาดลวดทองแดง 3 เส้นจะลดค่าความต้านทานที่กระแสสัมบูรณ์ของขดลวดลงประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์ แต่ความสูงของขดลวดจะมีค่าเพิ่มขึ้นประมาณ 45 เปอร์เซ็นต์ เช่นกัน การขนาดลวดทองแดงมากกว่า 3 เส้นมักไม่นิยมทำกัน เพราะจะพื้นที่ของขดลวด ได้จำกัดมาก หรืออาจทำให้ขดลวดสูงเกินกว่าที่จะพัฒนาแกนบนนี้ ให้การพัฒนาขดลวดทองแดงขนาดกันทำได้ดังนี้

(1) เลือกจำนวนลวดทองแดงแต่ละขนาด  $= n$  เส้น (ปกติจะใช้ 2 หรือ 3 เส้นเท่านั้น)

(2) ตามขั้นตอนที่ได้กล่าวในข้อการเลือกขนาดของลวดทองแดง โดยคิดจำนวนรอบ  $N'$  มีค่า  $N' = nN$  รอบ ถ้าจำนวนชั้น  $P_{id} = 1$  ให้ใช้วิธีเลือกขนาดจากกรณีที่จำนวนชั้นมีชั้นเดียว หรือครึ่งชั้นแทน โดยคิดให้จำนวนรอบ  $N' = nN$  รอบเช่นกัน

(3) ค่า  $R_{ac}$  ที่คำนวณได้ให้หารด้วย  $n$  เพื่อให้ค่า  $R_{ac}$  ของขดลวดทองแดงขนาด

(4) คำนวณค่าสูญเสียในขดลวดจากค่า  $R_{n_{ac}}$  ของขดลวดทองแดงขนาด

$$P_w = CI_{RMS}^2 N' I_{av} R_{n_{ac}} / n \quad (2.25)$$

### 2.1.5 อุณหภูมิของหม้อแปลงความถี่สูงแบบฟลายแบค

การออกแบบหม้อแปลงความถี่สูงแบบฟลายแบค จะต้องได้ว่าประสนความสำเร็จ ถ้าในขณะที่คอนเวอร์เตอร์จ่ายกำลังไฟด้วยสูตรสูดแล้วหม้อแปลงไม่ร้อน (อุณหภูมิของหม้อแปลงความถี่สูงจะทำงานคราวไม่เกิน 80 องศาเซลเซียส) ปกติแล้วหม้อแปลงจะร้อนเองเนื่องจากมีกำลังสูญเสียในหม้อแปลงสูง ซึ่งเกิดจากกำลังงานสูญเสียภายในขดลวดทองแดง และการสูญเสียในเฟอร์ไรต์ด้วย อุณหภูมิหม้อแปลงที่เพิ่มขึ้นจะทำงานเนื่องจากการสูญเสียในหม้อแปลงอาจคำนวณได้จากสมการ

$$\Delta T = \frac{23.5(P_w + P_c)}{\sqrt{A_e \cdot A_w}} \quad (2.26)$$

เมื่อ $\Delta T$	คือ อุณหภูมิหม้อแปลงที่เพิ่มขึ้นจากอุณหภูมิห้อง เป็นองศาเซลเซียส
$P_w$	คือ กำลังศูนย์สี่แยกภายในขดลวดทองแดง เป็นวัตต์
$P_c$	คือ กำลังศูนย์สูญเสียในแกนเฟอร์ไรต์ เป็นวัตต์
$A_e$	คือ พื้นที่หน้าตัดของแกนเฟอร์ไรต์ เป็นตารางเซนติเมตร
$A_w$	คือ ขนาดช่องพันขดลวดของอบบิน เป็นตารางเซนติเมตร

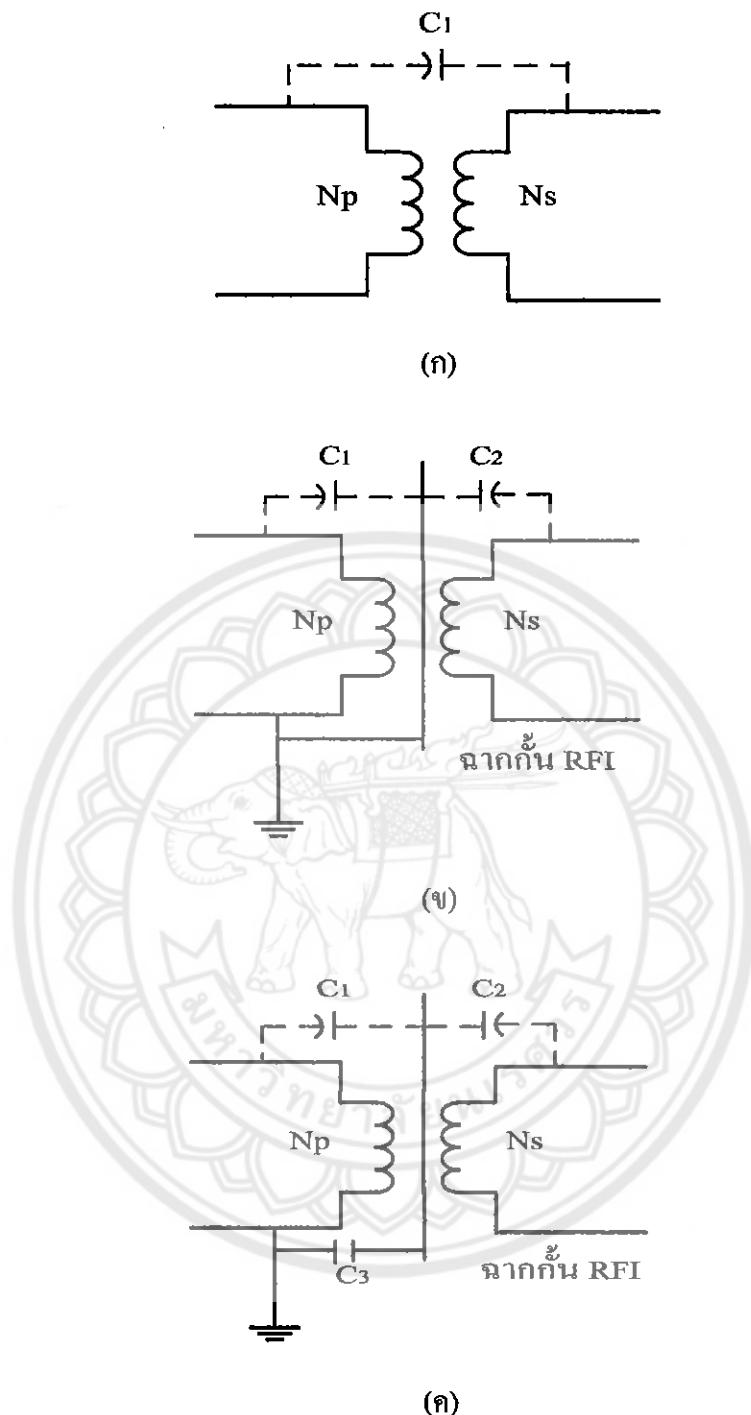
(ค่า  $\Delta T$  ได้จากสมการที่ 2.26 เป็นค่าโดยประมาณ ซึ่งจะให้ค่าใกล้เคียงกับค่าอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น ถ้า  $\Delta T$  มีค่าอยู่ในช่วง 20 ถึง 50 องศาเซลเซียส)

เพื่อไม่ให้อุณหภูมิของหม้อแปลงมีค่าสูงเกินไป และเพื่อเป็นข้อพิจารณาในการเลือกขนาดของแกนเฟอร์ไรต์กับการเลือกขนาดขดลวดและวิธีการพันขดลวดทองแดงที่เหมาะสมการกำหนดค่าพลังงานสูญเสียสูงสุดในหม้อแปลงซึ่งควรทำเป็นอันดับแรกในการออกแบบหม้อแปลงความถี่สูง

#### 2.1.6 ฉากรักษา RFI และ EMI

ฉากรักษา RFI หรือ Fraraday Screen เพิ่มเข้ามาในหม้อแปลงความถี่สูง เพื่อป้องกันการเกิดกระแส RF ไหลผ่านระหว่างขดปฐมภูมิและทุติยภูมิในหม้อแปลง เมื่อออกจากสนามไฟฟ้าระหว่างขดลวดอาจทำให้เกิดตัวเก็บประจุแห่งคร่องระหว่างขดปฐมภูมิและทุติยภูมิคังรูปที่ 2.21 (ก) ฉากรักษา RFI จะเป็นตัวผ่านทางให้กระแส RF ที่เกิดขึ้นไหลลงกราวด์ โดยฉากรักษาจะแบ่งตัวแห่งที่เกิดขึ้นออกเป็นสองส่วนเดียวต่อกราวด์ดังรูปที่ 2.21 (ข)

ฉากรักษา RFI สามารถทำให้ได้โดยใช้แผ่นตัวนำบางๆ และมีขนาดความกว้างเท่ากับระยะพันขดลวดบนอบบินเพื่อให้คลุมขดลวด ได้ทั้งหมด พันรอบแกนเพื่อแยกสนามไฟฟ้าระหว่างขดลวดเพื่อแยกสนามไฟฟ้าระหว่างขดปฐมภูมิและทุติยภูมิออกจากกันพันให้ครบรอบโดยที่ปลายของฉากรักษา RFI ต้องใหม่การเหลื่อมกันให้น้อยที่สุด เพื่อลดค่าตัวเก็บประจุในฉากรักษาซึ่งเกิดจาก การเหลื่อมกันที่ปลายรอบ และให้ใช้วนวนรองระหว่างจุดเริ่มต้นและจุดปลายเอาไว้ป้องกันเพื่อ การเชื่อมถึงกันทางไฟฟ้าที่จุดเริ่มต้นและจุดปลายของฉากรักษาด้วย



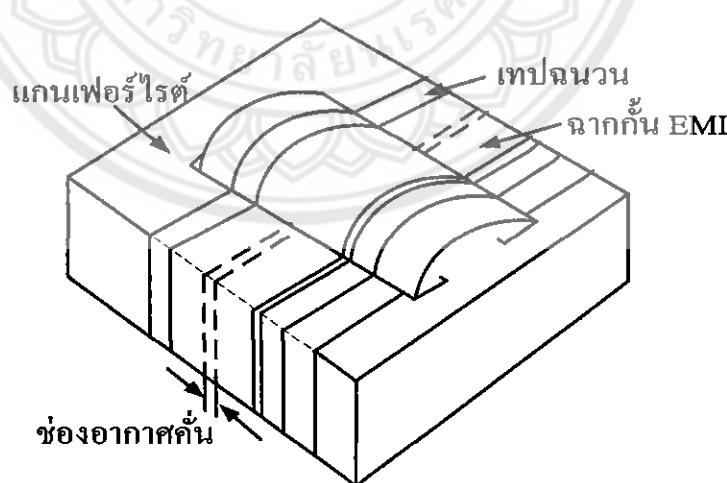
รูปที่ 2.21 (ก) หม้อแปลงที่ไม่มีภาคกัน RFI จะเกิดตัวเก็บประจุแห้งระหว่างขดปฐมภูมิและขดทุติยภูมิ และเป็นทางผ่านของกระแส RF ได้ (ง) ภาคกัน RFI จะเป็นตัวผ่านทางกระแส RF ให้ลดลงกว่าครึ่งโดยแบ่งครึ่งตัวเก็บประจุออกเป็นสองส่วนและต่อลงกราวด์ (ค) ตัวเก็บประจุ  $C_3$  ที่เพิ่มเข้ามาจะทำให้เกิดการแยกจากกันทางไฟฟ้าระหว่างภาคกัน RFI กับกราวด์ได้

จากกัน RFI จะต้องต่อลงกราวด์ เพื่อไม่ให้กระแส RF ไหลผ่านระหว่างขดลวด ให้เป็นการลดการแพร่กระจายของสัญญาณรบกวน RFI การแยกส่วนทางไฟฟ้าระหว่างจากกัน RFI และกราวด์เพื่อป้องกันอันตรายทางไฟฟ้า อาจทำได้ด้วยการต่อตัวเก็บประจุค่าต่ำๆ ประมาณ  $0.01 \mu F$  2 kV คั่นไว้ระหว่างกัน RFI กับกราวดังรูปที่ 2.21 (ก)

เนื่องจากกัน RFI เป็นตัวนำและเกิดการสูญเสียขึ้นจากการแสวงหาความหนื้นแปลงทำงานได้ชั่นกัน ดังนั้นจากกัน RFI เป็นควรทำการแผ่นตัวนำที่มีค่าความต้านทานสูงๆ เช่น Phosphor bronze (CUSn 8) หรือ Manganin และควรมีความหนาให้น้อยที่สุด (แต่มาตรฐาน UL-1244 กำหนดความหนาต่ำสุดไว้ที่ 0.15 มิลลิเมตร ซึ่งจะต้องพิจารณาประกอบกันด้วย)

จากกัน EMI (Electromagnetic Screen) จะทำไว้เพื่อลดการแพร่กระจายของสัญญาณรบกวน EMI ซึ่งจุดที่จะก่อให้เกิดการแพร่กระจายของสัญญาณรบกวน EMI ได้มากที่สุด ของ หม้อแปลงความถี่สูงก็คือช่องอากาศคั่นในแกนเฟอร์ไรต์ การลดสัญญาณรบกวน EMI จะทำโดยใช้แผ่นทองแดงที่มีความกว้างประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์ของความกว้างของบีนพันรอบแกนเฟอร์ไรต์ เพื่อทำจากกัน EMI กลุ่มรอบช่องอากาศคั่นเอาไว้ดังรูปที่ 2.22 และบักกรีเชื่อมจุดเริ่มต้นและเชื่อมจุดปลายเข้าด้วยกัน วิธีนี้จะช่วยสามารถลดการแพร่กระจายของสัญญาณรบกวน EMI ลงได้ถึง 12 dB

ในการตั้งกันขึ้นกับจากกัน RFI และ EMI ควรมีค่าความต้านทานไฟฟ้าน้อยที่สุด ดังนั้นการใช้แผ่นทองแดงจึงค่อนข้างเหมาะสมและความหนาไม่ต่ำกว่า 0.25 มิลลิเมตร



รูปที่ 2.22 จากกัน EMI รอบหม้อแปลงความถี่สูง

จากกัน EMI รอบหม้อแปลงความถี่สูง เพื่อลดการแพร่กระจายของสัญญาณรบกวน EMI เทปปันวนพันรอบแผ่นทองแดงเพื่อป้องกันการสัมผัสระหว่างจากกันกับแกนเฟอร์ไรต์

### 2.1.7 การออกแบบหน้าแปลงความถี่สูงให้มีความปลอดภัย

หน้าแปลงความถี่สูงต้องออกแบบให้มีความปลอดภัยสูงขณะใช้งาน โดยปลอดภัยจากไฟไหม้และปลอดภัยจากไฟฟ้า

#### 1) การเลือกใช้วัสดุเพื่อความปลอดภัยจากไฟไหม้

หน้าแปลงความถี่สูงแบบฝาลายเบคมีส่วนประกอบที่ติดไฟคือ เทปปันวนและบอบบิน การเลือกใช้ตามมาตรฐานความปลอดภัย

เทปปันวนสามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มได้ตามอัตราทนอุณหภูมิขั้นตอน ดังตารางที่ 2.2 การเลือกใช้ต้องเดือดใช้ที่ทนอุณหภูมิมากกว่าอุณหภูมิค่าความทำงานของหน้าแปลง

ตารางที่ 2.2 การจัดกลุ่มของเทปปันวนตามอัตราทนอุณหภูมิ (Thermal Strength)

ประเภทของชนวน	อุณหภูมิเฉลี่ยขณะทำงาน	อุณหภูมิสูงสุดขณะทำงาน
0	40	90
A	40	105
B	75	130
F	75	155
H	85	180

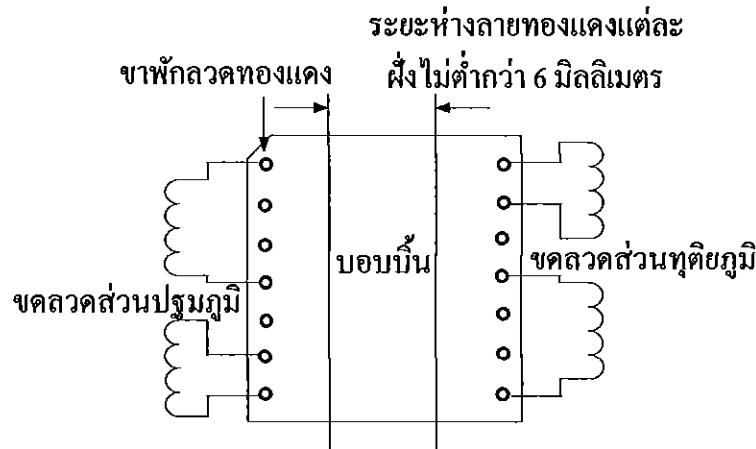
บอบบินทำมาจากเม็ดพลาสติกที่ไม่ติดไฟ โดยทั่วไปบอบบินมักใช้วัสดุที่ผ่านมาตรฐานทดสอบของ UL 94 เช่นวัสดุกลุ่ม 94V-0, 94V-1 และ 94V-2 เป็นต้น

#### 2) การออกแบบเพื่อความปลอดภัยจากไฟฟ้า

เนื่องจากหน้าแปลงจะพับด้วยขดลวดบนบอบบินหากมีข้อบกพร่องเกิดขึ้นที่ขดลวดผู้ใช้งานเกิดอันตรายจากไฟฟ้าดูดได้ผู้ออกแบบควรพิจารณาให้เกิดความปลอดภัยไฟดังนี้

- แยกส่วนระหว่างขดลวดปฐมภูมิและขดลวดทุติยภูมิที่ขาของบอบบิน

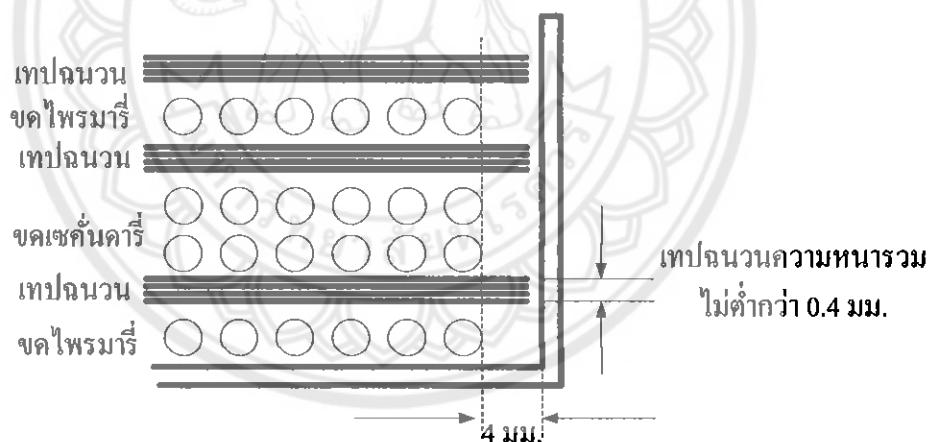
โดยทั่วไปแล้วบอบบินจะมีการเรียงขาพักขดลวดเช่นเดียวกับขาไอซ์ โดยแบ่งออกเป็นสองแควรแยกส่วนขาปฐมภูมิและทุติยภูมิให้อยู่คนละแควร ดังรูปที่ 2.23



รูปที่ 2.23 การพันขดลวดบนบีนลักษณะแยกผู้ของขดลวดที่ขานบีน

- ให้แยกส่วนระหว่างปฐมภูมิและทุติยภูมิด้วยเทปปนวน

โดยให้การแยกระหว่างส่วนระหว่างปฐมภูมิและทุติยภูมิด้วยเทปปนวน ความหนาของเทปปนวนที่กั้นระหว่างขดต้องมีค่าไม่ต่ำกว่า 0.4 มิลลิเมตรเทปต้องมีความกว้างเท่ากับขนาดความกว้างของบอนบีน ดังแสดงในรูปที่ 2.24



รูปที่ 2.24 การแยกส่วนของขดลวดด้วยเทปปนวนบีน

ในการปฏิการพันขดลวดแบบแยกพัน ต้องใช้เทปพันกั้นระหว่างขดลวดทุกตำแหน่งที่มีการทับซ้อนกัน และเพื่อเพิ่มความปลอดภัย ควรพันเทปปนวนทับขดลวดชั้นบนสุดให้มีความหนาของเทปปนวนไม่ต่ำกว่า 0.4 มิลลิเมตรเอาไว้ด้วย

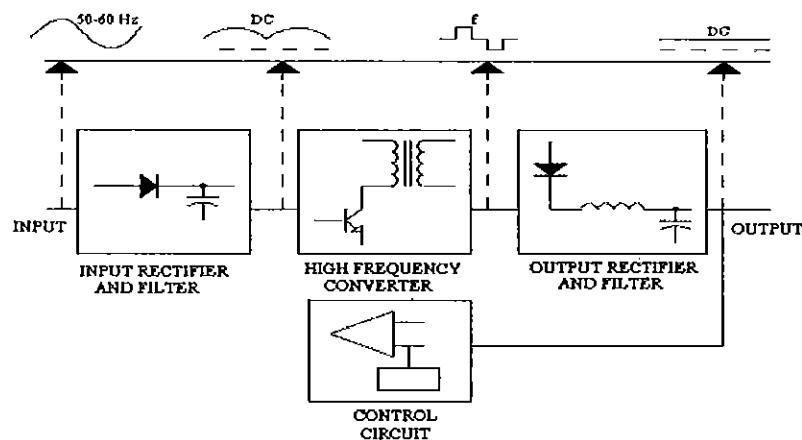
## 2.2 หลักการทำงานของคอนเวอร์เตอร์

คอนเวอร์เตอร์นี้ นับว่าเป็นส่วนสำคัญที่สุดในแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงแบบสวิตชิ้ง มีหน้าที่ลดทอนแรงดันไฟตรงค่าสูงลงมาเป็นแรงดันไฟตรงค่าต่ำ และสามารถรักษาแรงดันได้ คอนเวอร์เตอร์มีหลายแบบ ขึ้นอยู่กับลักษณะการจัดวงจรภายใน โดยคอนเวอร์เตอร์แต่ละแบบ จะมีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันออกไป การจะเลือกใช้คอนเวอร์เตอร์แบบใดสำหรับสวิตชิ้งเพาเวอร์ ซัพพลายนั้น นีมีข้อควรพิจารณาจากลักษณะพื้นฐานของคอนเวอร์เตอร์แต่ละแบบดังนี้คือ

- ลักษณะการแยกกันทางไฟฟ้าระหว่างอินพุตกับเอาต์พุตของคอนเวอร์เตอร์
- ค่าแรงดันอินพุตที่จะนำมาใช้กับคอนเวอร์เตอร์
- ค่ากระแสสูงสุดที่ไม่ผ่านทรานซิสเตอร์กำลังในคอนเวอร์เตอร์ขณะทำงาน
- ค่าแรงดันสูงสุดที่ต้องรับแรงดันอินพุตที่ต้องรับแรงดัน
- การรักษาแรงดันแรงดันในกรณีที่คอนเวอร์เตอร์มีเอาต์พุตหลากหลายค่าแรงดัน
- การกำเนิดสัญญาณรบกวน RFI/EMI ของคอนเวอร์เตอร์

โครงสร้างโดยรวมของแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงแบบสวิตชิ้ง ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ

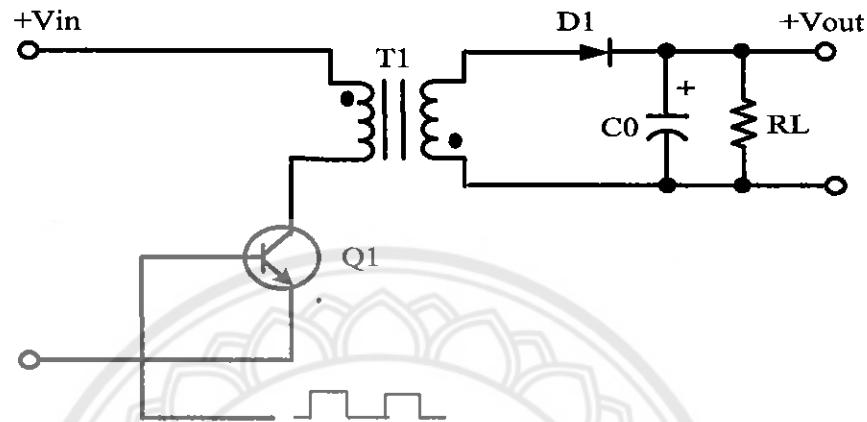
- 1) Input Rectifier and Filter
- 2) High Frequency Converter
- 3) Output Rectifier and Filter
- 4) Control Circuit



รูปที่ 2.25 บล็อกไซโคะแกรมของแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงแบบสวิตชิ้ง [3]

การออกแบบแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงแบบสวิตชิ้นจะมีคุณวีเออร์เตอร์ให้เลือกใช้หลายแบบทำให้การออกแบบสามารถเลือกคุณวีเออร์เตอร์ตามความต้องการ และในปัจจุบัน คุณวีเออร์เตอร์ที่นิยมใช้เป็นหลักในงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์มีด้วยกัน 5 ชนิด คือ

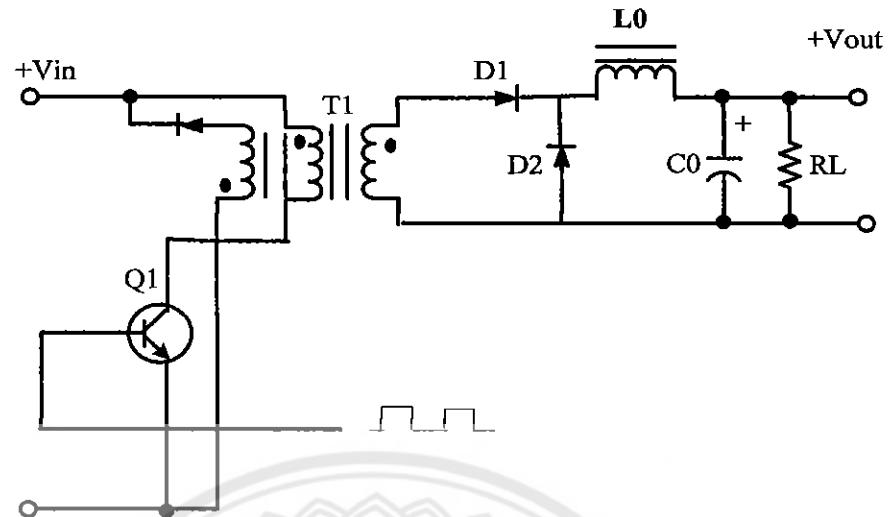
### 1.) คุณวีเออร์เตอร์แบบฟลายแบค (Fly-Back Converter)



รูปที่ 2.26 ฟลายแบคคุณวีเออร์เตอร์

จากรูปที่ 2.26 เพาเวอร์ทรานซิสเตอร์  $Q_1$  ในฟลายแบคคุณวีเออร์เตอร์จะทำงานในลักษณะเป็นสวิตช์ และนำกระแสตามคำสั่งของพัลส์สี่เหลี่ยมที่ป้อนให้กับขาเบสของมอเตอร์ เนื่องจากหม้อแปลง  $T_1$  จะกำหนดค่าปัจจุบันภายนอกและทุติยภูมิให้มีลักษณะกลับเพลิงกันอยู่ ดังนั้นเมื่อ  $Q_1$  นำกระแส ไดโอด  $D_1$  จึงอยู่ในลักษณะถูกไนแออสกันและไม่นำกระแส จึงมีการสะท้อนพลังงานที่ปัจจุบันภายนอกหม้อแปลง  $T_1$  แทน เมื่อ  $Q_1$  หยุดนำกระแส สนามแม่เหล็ก  $T_1$  ยุบตัวทำให้เกิดการกลับขั้วแรงดันที่บคปัจจุบันภัยและทุติยภูมิ  $D_1$  ก็อยู่ในลักษณะถูกไนแออสต่อง พลังงานที่สะท้อนในคลื่นปัจจุบันภัยของหม้อแปลงที่จะถูกถ่ายเทออกไปยังขาทุติยภูมิ และมีกระแสไหลผ่านไดโอด  $D_1$  ไปยังตัวเก็บประจุอาดัท  $C_0$  และโหลด ให้ค่าของแรงดันที่อาดัทพุตของคุณวีเออร์เตอร์ จะเข้ากัน ค่าความต้องการทำงานของ  $Q_1$  ช่วงเวลานำกระแสของ  $Q_1$  อัตราส่วนจำนวนรอบของหม้อแปลง และค่าของแรงดันที่อินพุต ฟลายแบคคุณวีเออร์เตอร์เป็นคุณวีเออร์เตอร์ที่ทำให้กำลังงานได้ไม่สูงนัก โดยอยู่ในช่วงไม่เกิน 150 วัตต์ และค่าสัญญาณรบกวน RFI/EMI ก่อนข้างสูง แต่ใช้อุปกรณ์ จำนวนน้อยและมีราคาถูก

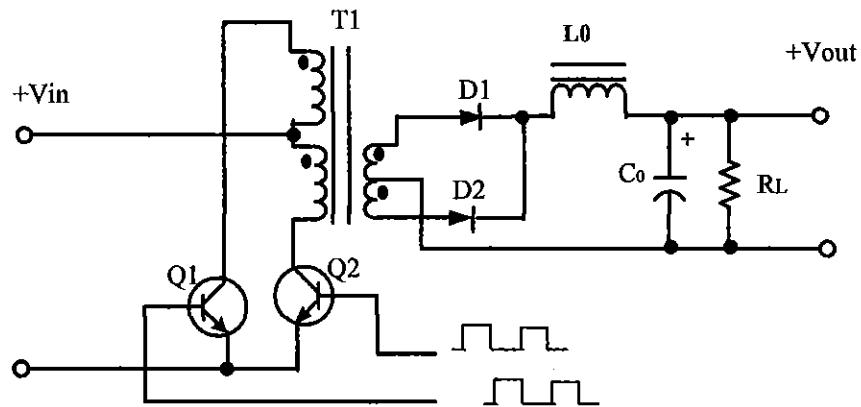
## 2.) ค่อนเวอร์เตอร์แบบฟอร์เวิร์ด (Forward Converter)



รูปที่ 2.27 ฟอร์เวิร์ดค่อนเวอร์เตอร์

ในรูปที่ 2.27 จะเห็นได้ว่าฟอร์เวิร์ดค่อนเวอร์เตอร์มีลักษณะใกล้เคียงกับฟลายแบคค่อนเวอร์เตอร์ แต่หน้าแปลง  $T_1$  ในฟอร์เวิร์ดค่อนเวอร์เตอร์จะกำหนดคุณภาพปัจจุบันและทุติยภูมิให้มีให้มีเฟสตรงกันดังนี้เมื่อ  $Q_1$  นำกระแส ไคโอด  $D_1$  จึงอยู่ในลักษณะถูกใบแออสตรอง แต่  $D_2$  จะอยู่ในลักษณะถูกใบแออสกลับและไม่นำกระแส กระแสจึงไหลผ่านไคโอด  $D_1$  และตัวเหนี่ยววนั่ง  $L_0$  ไปยังตัวเก็บประจุเอาต์พุต  $C_0$  และโหลด ไคโอด  $D_1$  จะอยู่ในลักษณะถูกใบแออสกลับ จึงไม่มีกระแสไหลจากขดทุติยภูมิ สถานะแม่เหล็กใน  $L_0$  จะบูนตัวทำให้มีการกลับขั้วแรงดันทกรรค้อมตัวบูนอยู่ ไคโอด  $D_2$  ก็จะอยู่ในลักษณะถูกใบแออสตรอง  $L_0$  จะถ่ายเทพลังงานออกมากทำให้กระแสไหลผ่านตัวบูนและ  $D_2$  ออกไปยังโหลด ได้จะเห็นได้ว่าจะมีกระแสไหลผ่านโหลดได้อย่างต่อเนื่องทั้งในช่วงที่  $Q_1$  นำกระแสและหยุดนำกระแส ทำให้มีการกระแสเพื่อนของแรงดันที่เอาต์พุตต่ำกว่าฟลายแบคค่อนเวอร์เตอร์ ฟอร์เวิร์ดค่อนเวอร์เตอร์ให้กำลังงานได้ในช่วงเดียวกันกับฟลายแบคค่อนเวอร์เตอร์ แต่กระแสที่ได้จะมีการกระแสเพื่อนต่ำกว่า อายุ ไรก์ตาน ตัวอุปกรณ์ที่เพิ่มเข้ามาให้ฟอร์เวิร์ดค่อนเวอร์เตอร์นั้นมีราคาสูงกว่า

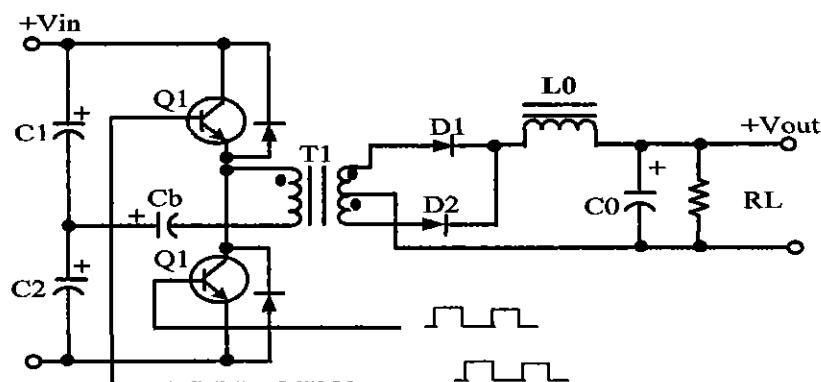
### 3.) คอนเวอร์เตอร์แบบพุช - พุล (Push Pull Converter)



รูปที่ 2.28 พุช - พุลคอนเวอร์เตอร์

พุช - พุลคอนเวอร์เตอร์เป็นคอนเวอร์เตอร์ที่สามารถจ่ายกำลังงานได้สูงตั้งแต่ 500 วัตต์ขึ้นไปแต่มีข้อเสียคือ มักเกิดการไม่สมมาตรฟลักซ์เม่เดลกของแกนหม้อแปลงซึ่งจะมีผลต่อการพัฒนาข่ายของเพาเวอร์ทรานซิสเตอร์ได้ง่าย อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันเทคนิคการควบคุมกระแสจะทำให้ลดปัญหางงได้ ดังนั้นพุช - พุลคอนเวอร์เตอร์จึงเป็นคอนเวอร์เตอร์ที่น่าสนใจสำหรับสวิตชิ่งเพาเวอร์ซัพพลายที่ต้องการกำลังสูงๆ จากรูปที่ 2.28 Q<sub>1</sub> และ Q<sub>2</sub> จะสลับกันไปกระแสในแต่ละครึ่ง ตามเวลาการทำงานเมื่อ Q<sub>1</sub> นำกระแส D<sub>1</sub> จะอยู่ในลักษณะถูกไปแอกลับ แต่ D<sub>1</sub> จะอยู่ในลักษณะไปแอกตรง และนำกระแสผ่าน L<sub>0</sub> ไปยังโหลดได้ เมื่อ Q<sub>1</sub> หยุดนำกระแส Q<sub>2</sub> จะเริ่มนำกระแส D<sub>2</sub> จะอยู่ในลักษณะถูกไปแอก และ D<sub>1</sub> จะอยู่ในลักษณะถูกไปแอกตรง และนำกระแสผ่าน L<sub>0</sub> ไปยังโหลดเช่นเดียวกัน ดังนั้นโหลดจึงมีกระแสต่อเนื่องได้ตลอดเวลา กระแสที่ได้ทางเอาด้วยจึงค่อนข้างเรียบอย่างรักก์ตาม เพาเวอร์ทรานซิสเตอร์ที่เพิ่มเข้ามาจะมีผลต่อค่าใช้จ่ายในการสร้างพุช - พุลคอนเวอร์เตอร์เช่นกัน

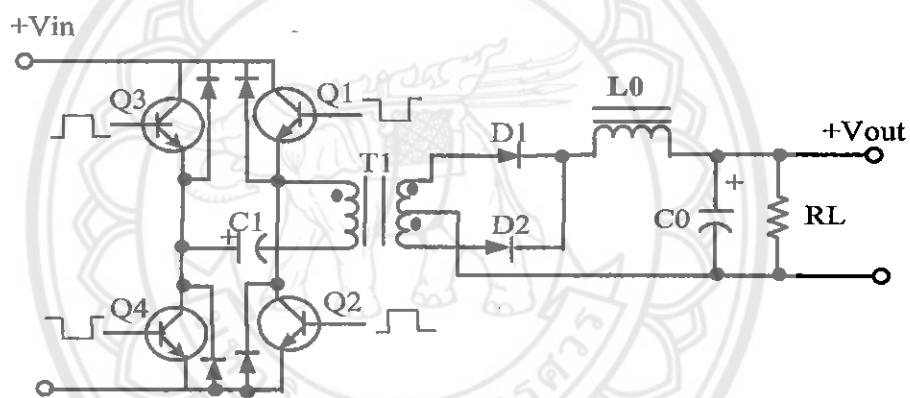
### 4.) คอนเวอร์เตอร์แบบชาล์ฟ - บริดจ์ (Half Bridge Converter)



รูปที่ 2.29 ชาล์ฟ - บริดจ์คอนเวอร์เตอร์

ชาล์ฟ - บริคจ์ค่อนเวอร์เตอร์จัดเป็นค่อนเวอร์เตอร์ในตระกูลเดียวกับพูช - พูดค่อนเวอร์เตอร์ และให้กำลังงานได้ค่อนข้างสูง ข้อดีของชาล์ฟ - บริคจ์ค่อนเวอร์เตอร์ก็คือ เพาเวอร์ทรานซิสเตอร์ในวงที่มีค่าแรงดันต่ำกว่าค่าแรงดันต่ำของบานช์ไม่แรงดันต่ำกว่าค่าแรงดันต่ำของบานช์ไม่นำกระแสเนื่องจากว่าค่อนเวอร์เตอร์ทั้ง 3 แบบที่ได้กล่าวมาแล้ว และเกิดไม่สมมาตรฟลักซ์ได้ จากรูปที่ 2.29 จะเห็นได้ว่า หากเพาเวอร์ทรานซิสเตอร์ตัวใดตัวหนึ่งนำกระแส ค่าแรงดันต่ำกว่าค่าแรงดันต่ำของเพาเวอร์ทรานซิสเตอร์ตัวที่เหลือจะมีเพียงแรงอันอินพุตเท่านั้น เมื่อ  $Q_1$  และ  $Q_2$  ลับกันนำกระแส ผลที่ได้จะมีลักษณะเดียวกับการทำงานของพูช - พูดค่อนเวอร์เตอร์ ยกเว้นค่าแรงดันต่ำกว่าค่าแรงดันต่ำของเพาเวอร์ทรานซิสเตอร์ที่ต้องทำงานของคปปุนภูมิจะมีค่าแรงดันต่ำกว่าค่าแรงดันต่ำของเพาเวอร์ทรานซิสเตอร์ที่ต้องทำงานของคปปุนภูมิเพื่อแบ่งครึ่งแรงดัน กระแสที่ไหลผ่านคปปุนภูมิจึงมีค่าสูง ซึ่งเป็นการจัดกำลังสูงสุดของค่อนเวอร์เตอร์ โดยกำลังงานสูงสุดที่ชาล์ฟ - บริคจ์ค่อนเวอร์เตอร์สามารถทำได้อยู่ในช่วงไม่เกิน 500 วัตต์

### 5.) ค่อนเวอร์เตอร์แบบฟูล - บริคจ์ (Full Bridge Converter)



รูปที่ 2.30 ฟูล - บริคจ์ค่อนเวอร์เตอร์

จากรูปที่ 2.30 จะเห็นได้ว่ามีเพาเวอร์ทรานซิสเตอร์ในวงจรห้าหมุด 4 ตัว แต่จะทำงานลับกันเป็นคู่ๆ โดย  $Q_1$  จะนำกระแสพร้อมกับ  $Q_4$  และ  $Q_2$  จะนำกระแสพร้อมกับ  $Q_3$  กระแสที่ไหลผ่านคปปุนภูมิของหม้อแปลงจะมีลักษณะเช่นเดียวกับชาล์ฟ - บริคจ์ค่อนเวอร์เตอร์ แต่ข้อได้เปรียบเสียเปรียบฟูล - บริคจ์ค่อนเวอร์เตอร์ ขณะที่ทำงานที่คปปุนภูมิจะมีแรงดันต่ำกว่าค่าแรงดันต่ำของเพาเวอร์ทรานซิสเตอร์ที่ต้องการกำลังสูงๆ ตั้งแต่ 500 วัตต์ ถึง 1000 วัตต์ จึงมักนิยมใช้ค่อนเวอร์เตอร์แบบฟูล - บริคจ์เป็นหลัก

ค่อนเวอร์เตอร์ที่เลือกใช้ในการสร้างตัวอัคประจุแบบเตอร์แบบพกพาคือ ค่อนเวอร์เตอร์แบบฟลายแบค

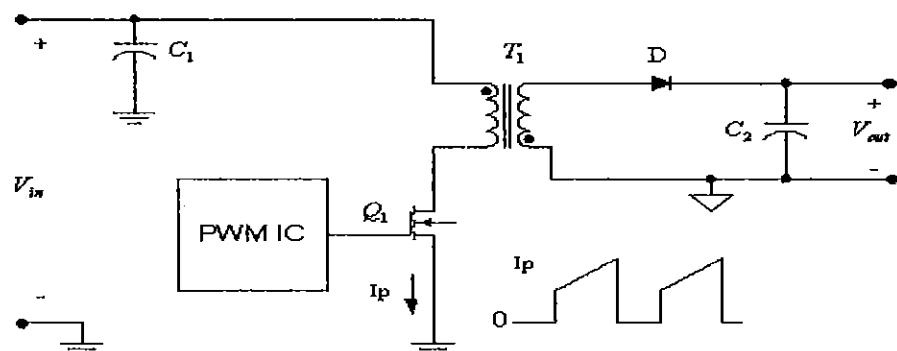
## 2.3 คอนเวอร์เตอร์แบบฟลายแบค

### 2.3.1 คุณลักษณะของคอนเวอร์เตอร์แบบฟลายแบค

คอนเวอร์เตอร์แบบฟลายแบค ทำหน้าที่ตัดตอนระดับแรงดันที่รับเข้ามาทางค้านอินพุต และจ่ายแรงดันที่ถูกตัดตอนออกมาทางค้านเอาต์พุต ส่วนประกอบที่สำคัญของคอนเวอร์เตอร์แบบฟลายแบค คือ หม้อแปลงความถี่สูงซึ่งมีลักษณะที่กลับเฟสกันของขั้วแรงดันทางค้านอินพุต และเอาต์พุต หม้อแปลงความถี่สูง ในคอนเวอร์เตอร์แบบฟลายแบค จะไม่เหมือนกับหม้อแปลงทั่วไปตรงที่หม้อแปลงทั่วไปจะทำงานในลักษณะของการส่งผ่านพลังงาน แต่หม้อแปลงความถี่สูง ในคอนเวอร์เตอร์แบบฟลายแบค จะทำหน้าที่เก็บสะสมพลังงานแล้วกับการจ่ายพลังงาน คอนเวอร์เตอร์แบบฟลายแบค จะทำงานใน 2 ช่วง คือ ช่วงการเก็บสะสมพลังงาน และช่วงการจ่ายพลังงาน การทำงานแต่ละช่วงขึ้นอยู่กับสัญญาณพัลส์ที่ได้รับจากวงจรควบคุม

### 2.3.2 การทำงานของคอนเวอร์เตอร์แบบฟลายแบค

จากรูปวงจร ทรานซิสเตอร์กำลัง  $Q_1$  จะทำหน้าที่เป็นสวิตช์ค่อย เปิด/ปิด การทำงานของคอนเวอร์เตอร์แบบฟลายแบค โดยรับสัญญาณควบคุมเป็นพัลส์สีเหลืองจากวงจรควบคุมอีกที่ เมื่อ  $Q_1$  นำกระแส ໄคโอด  $D$  จะอยู่ในลักษณะถูกไบแอสก์บีส (Reverse Bias) เนื่องจากหม้อแปลงมีการกลับขั้วแรงดันกันอยู่ จะทำให้มีกระแส  $I_p$  ไหลผ่านชุด漉คด้านปฐมภูมิทำให้เกิดการสะสมพลังงานที่ชุด漉คปฐมภูมิ และเมื่อ  $Q_1$  หยุดนำกระแส สามารถแม่เหล็กที่หม้อแปลงจะเกิดการยุบตัว ทำให้เกิดการกลับขั้วแรงดันที่ชุด漉คปฐมภูมิและชุด漉คทុទិយូមิ ทำให้ໄคโอด  $D$  อยู่ในลักษณะไบแอสตริง (Forward Bias) พลังงานที่สะสมในชุด漉คปฐมภูมิของหม้อแปลงก็จะถูกถ่ายเทไปยังชุด漉คทុទិយូមิ และมีกระแสไหลผ่านໄคโอด  $D$  ไปยังตัวเก็บประจุ  $C_2$  และໂឡດ ค่าของแรงดันที่เอาต์พุตของคอนเวอร์เตอร์ จะขึ้นอยู่กับความถี่การทำงานและช่วงเวลาการนำกระแสของ  $Q_1$



รูปที่ 2.31 วงจรพื้นฐานของคอนเวอร์เตอร์แบบฟลายแบค [3]

เมื่อวงจรทำงานอยู่ในสภาวะคงที่ สามารถหาค่าแรงดันเอาต์พุตได้ดังนี้

$$V_{out} = \frac{\left[ t_{on} \times \left( \frac{Ns}{Np} \right) \times (V_{in} - V_{ce(sat)}) \right]}{(T - t_{on})} - V_D \quad (2.27)$$

โดยที่ $T$	คือ ความเวลาการทำงานของทรานซิสเตอร์กำลัง (วินาที)
$t_{on}$	คือ ช่วงเวลาของสัญญาณพัลส์ในช่วงสถานะ ON (วินาที)
$N_p$	คือ จำนวนรอบของขดลวดปฐมภูมิ (รอบ)
$N_s$	คือ จำนวนรอบของขดลวดทุติยภูมิ (รอบ)
$V_{out}$	คือ แรงดันที่เอาต์พุตของคอนเวอร์เตอร์ (โวลต์)
$V_{in}$	คือ แรงดันที่อินพุตของคอนเวอร์เตอร์ (โวลต์)
$V_{ce(sat)}$	คือ แรงดันที่ตกครั่อมทรานซิสเตอร์กำลังขณะนำกระแสอยู่ตัว (โวลต์)
$V_D$	คือ แรงดันที่ตกครั่อมไคลโอดัมนำกระแส (โวลต์)

จะเห็นได้ว่า วงจรสามารถรักษาระดับไฟกงที่ตัวการเพิ่มหรือลดช่วงเวลานำกระแส  $t_{on}$  ของทรานซิสเตอร์กำลัง  $Q_1$  เท่านั้น ไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงของแรงดันอินพุตหรือแรงดันเอาต์พุต (โหลดมีการเปลี่ยนแปลง) ก็ตาม

### 2.3.3 ลักษณะกระแสและแรงดันภายในวงจร

กระแสที่โหลดผ่าน  $Q_1$  และขดลวดปฐมภูมิ ขณะที่  $Q_1$  นำกระแสนั้น จะเป็นลักษณะของกระแสที่โหลดผ่านตัวเหนี่ยวนำ ซึ่งจะเป็นไปตามสมการ

$$\frac{di}{dt} = \frac{V}{L} \quad (2.28)$$

ดังนั้น กระแส  $I_p$  จะมีค่าเพิ่มขึ้นตามเวลาและมีค่าสูงสุดเมื่อ  $Q_1$  เริ่มหยุดนำกระแส ที่เวลา  $t = t_{on}$  ดังนั้นกระแสสูงสุดจะมีค่าเท่ากับ

$$I_{p(PK)} = \frac{(V_{in} - V_{ce(sat)})}{L_p} \times t_{on} \quad (2.29)$$

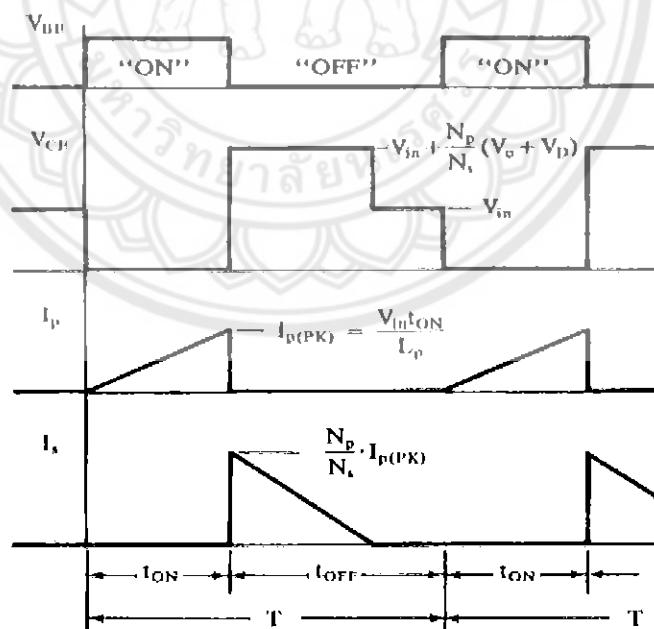
โดยที่  $I_{p(PK)}$  คือ ค่ากระแสสูงสุดที่ผ่านขดลวดปฐมภูมิ (แอมป์)

$L_p$  คือ ค่าความหนาแน่นของขดลวดปฐมภูมิ (เอนรี่)

เมื่อ  $Q_1$  ตั้งให้ดูดนำกระแส ขดลวดทุติยภูมิจะเริ่มมีกระแสไหล แต่เนื่องจากกระแสที่ตัวเหนี่ยววนนำจะเปลี่ยนแปลงในทันทีทันใดไม่ได้ กระแสที่ขดลวดทุติยภูมิ  $I_s$  จะต้องเริ่มต้นที่ค่าสูงสุดของกระแสที่ขดลวดปฐมภูมิ  $I_{p(PK)}$  โดยมีค่าเป็นสัดส่วนตามอัตราส่วนจำนวนรอบดังนั้นกระแสที่ขดลวดทุติยภูมิจะมีค่าเริ่มต้นตามสมการ และมีค่าลดลงตามเวลา

$$I_s = \left( \frac{N_p}{N_s} \right) \times I_{p(PK)} \quad (2.30)$$

เมื่อมีกระแสไฟหล่อผ่านขดลวดทุติยภูมิในขณะที่  $Q_1$  ดูดนำกระแส จะทำให้เกิดแรงดันต่อกครรั่มขดลวดปฐมภูมิด้วย เนื่องจากแรงดันต่อกครรั่มของขดลวดทุติยภูมินี้ค่าเท่ากับ  $V_{out} + V_D$  ดังนั้นแรงดันที่ต่อกครรั่มขดลวดปฐมภูมิจึงมีค่าเท่ากับ  $\left( \frac{N_p}{N_s} \right) (V_{out} + V_D)$  ทำให้แรงดันต่อกครรั่ม  $Q_1$  ขณะดูดนำกระแสมีค่าเป็น  $V_{in} + \left( \frac{N_p}{N_s} \right) (V_{out} + V_D)$  จนกระทั่งกระแสที่ไฟหล่อไปในขดลวดทุติยภูมิมีค่าลดลงเป็นศูนย์ และแรงดันที่ต่อกครรั่ม  $Q_1$  จึงคงลงมา มีค่าเท่ากับแรงดันอินพุต  $V_{in}$  ในรูปที่ 2.32 จะแสดงถักยமะของกระแสและแรงดันที่เกิดขึ้นภายในวงจร เทอร์เรนบอร์ดแบบฟลายแบค ขณะทำงาน



รูปที่ 2.32 กราฟถักยมะกระแสและแรงดันในวงจร [3]

### 2.3.4 การทำงานในโหมดกระแสต่อเนื่องและโหมดกระแสไม่ต่อเนื่อง

#### - โหมดกระแสต่อเนื่อง (Continuous Mode)

ถ้าความเวลาไม่ค่าคงที่ เมื่อเพิ่มช่วงเวลาการนำกระแส  $t_{on}$  ของทรานซิสเตอร์กำลัง  $Q_1$  ให้มากขึ้น ช่วงเวลาหยุดนำกระแส  $t_{off}$  ก็จะมีค่าน้อยลงและกระแสสูงสุดที่ขดลวดปฐมนิเทศมีค่าเพิ่มขึ้นตามเวลาไปด้วย แต่เมื่องจากช่วงเวลาหยุดนำกระแส  $t_{off}$  มีค่าน้อย กระแสที่ขดลวดยุบไม่สามารถลดลงจนมีค่าเป็นศูนย์ได้ทันทัยในช่วงเวลา  $t_{off}$  จึงยังคงมีพลังงานบางส่วนเหลือค้างอยู่ ในขดลวดปฐมนิเทศ เนื่องจากกระแสไม่สามารถเปลี่ยนแปลงทันทีทันใดได้ เมื่อ  $Q_1$  เริ่มนำกระแสอีกครั้ง กระแสที่ขดลวดปฐมนิเทศต้องเริ่มต้นด้วยค่าของกระแสที่ขดลวดทุกยูนิตยังคงที่ลอดลงได้คุณค่าวัตตราส่วนจำนวนรอบ การทำงานในลักษณะนี้จึงเรียกว่า การทำงานในโหมดกระแสต่อเนื่อง

#### - โหมดกระแสไม่ต่อเนื่อง (Discontinuous Mode)

ค่อนเวอร์เตอร์แบบฟลายแบคจะมีการทำงานในโหมดของกระแสไม่ต่อเนื่องและเมื่อทรานซิสเตอร์กำลัง  $Q_1$  หยุดนำกระแส พลังงานที่สะสมไว้ในขดลวดปฐมนิเทศถูกด่ายเทออกไป ยังขดลวดทุกยูนิตจนหมด ทำให้กระแสที่ไหลในขดลวดทุกยูนิตมีค่าลดลงจนเป็นศูนย์ ก่อนที่  $Q_1$  จะเริ่มนำกระแสอีกครั้ง

### 2.3.5 การออกแบบค่อนเวอร์เตอร์แบบฟลายแบคที่โหมดกระแสไม่ต่อเนื่อง

#### - กำหนดค่าอัตราส่วนจำนวนรอบ

การกำหนดอัตราส่วนจำนวนรอบของหม้อแปลงความถี่สูง เป็นสิ่งที่ควรคำนึงถึงเป็นอันดับแรก เนื่องจากค่าอัตราส่วนจำนวนรอบจะมีผลต่อแรงดันต่ำคร่อมสูงสุดของทรานซิสเตอร์ กำลังและหยุดนำกระแสโดย

$$V_{ce(\max)} = V_{in(\max)} + \frac{N_p}{N_s} (V_{out} + V_D) \quad (2.31)$$

ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันการพังเสียหายของทรานซิสเตอร์กำลังที่จะนำมาใช้ จึงควรกำหนดอัตราส่วนจำนวนรอบดังนี้

$$\frac{N_p}{N_s} < \frac{V_{CEO} - (V_{in(\max)} + V_{spike})}{(V_{out} + V_D)} \quad (2.32)$$

เมื่อ  $V_{CEO}$  คือค่าอัตราหานแรงดัน ได้สูงสุดของทรายซิสเตอร์กำลังที่ใช้ และ  $V_{spike}$  คือค่าแรงดันกระชากที่เกิดขึ้นขณะที่ทรายซิสเตอร์กำลังเริ่มหยุดนำกระแส แรงดันกระชากนี้เกิดขึ้นเนื่องจากฟลักซ์ร่วงไฟลกภายในหน้าแปลง ซึ่งทำให้เกิดค่าความหนาแน่นขึ้นเพื่อคล漉ปฐมภูมิและการลดลงของพลังงานเข้าดียวกับคล漉ปฐมภูมิ แรงดันกระชากที่เกิดขึ้นนี้จะมีค่าประมาณ  $0.3V_{in}$  และเกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆ จนกว่าพลังงานที่ถูกสะสมในตัวหนีบวนนำไฟจะถูกดึงไป

การกำหนดค่าอัตราส่วนจำนวนรอบที่มีค่ามากหรือน้อยเกินไป จะมีผลผลกระทบต่อขนาดของหน้าแปลงและกระแสสูงสุดที่เกิดขึ้นในวงจร การพิจารณาค่าอัตราส่วนจำนวนรอบนั้นต้องพิจารณาผลของค่าอัตราส่วนจำนวนรอบที่มีค่าคงที่ประกอบกันในวงจรอย่างเหมาะสมด้วย

### 2.3.6 ช่วงเวลานำกระแสสูงสุด ( $t_{on(max)}$ )

เพื่อให้แน่ใจว่างจรอณเวอร์เตอร์แบบฟลายแบคที่ออกแบบ ทำงานในโหมดกระแสที่ไม่ต่อเนื่อง จำเป็นต้องกำหนดให้ช่วงเวลาหยุดนำกระแส  $t_{off}$  ให้มีค่ามากกว่า  $t_{on}$  เพื่อให้กระแสที่คล漉ปฐมภูมิลดลงจนมีค่าเป็นศูนย์ก่อนที่ทรายซิสเตอร์กำลังจะเริ่มนำกระแสอีกครั้ง ดังนั้นจึงกำหนดค่าเวลาเพื่อ (Dead Time)  $t_D$  ทำให้เวลาของการลดลงของกระแสที่คล漉ทุติยภูมิในเป็นศูนย์จะต้องใช้เวลาไม่เกิน  $t_{OFF} = T - (t_{ON} + t_D)$

ค่าของ  $t_D$  จะกำหนดให้เป็นเท่าไหร่ดี โดยทั่วไปมักกำหนดไว้ที่ประมาณ 20 % ของค่าความเวลา  $T$  หรือเท่ากับ  $0.2T$  ดังนั้น

$$t_{ON(max)} + t_{OFF} = 0.8T \quad (2.33)$$

เนื่องจากกระแสที่คล漉ปฐมภูมิต้องลดลงจนมีค่าเป็นศูนย์โดยใช้เวลามากที่สุดเท่ากับ  $t_{OFF}$  นั้นคือ

$$-(0 - I_{s(PK)}) = \frac{(V_{out} + V_D)}{L_s} t_{OFF}$$

$$\left( \frac{N_p}{N_s} \right) I_{p(PK)} = \frac{(V_{out} + V_D)}{L_s} t_{OFF} \quad (2.34)$$

จากสมการที่ (2.29) แทนค่า  $I_{p(PK)}$  ใน (2.34) จะได้ว่า

เมื่อจาก  $\frac{N_p}{N_s} = \sqrt{\frac{L_p}{L_s}}$  และแทนค่า  $t_{OFF} = 0.8T - t_{ON(max)}$

$$\frac{N_p}{N_s} \frac{(V_{in(min)} - V_{CE(sat)})_{ON(max)}}{L_p} = \frac{(V_{out} + V_D)t_{OFF}}{L_s}$$

$$t_{ON(max)} = \frac{(V_{out} + V_D)(N_p/N_s)(0.8T)}{(V_{in(min)} - V_{CE(sat)}) + (V_{out} + V_D)(N_p/N_s)} \quad (2.35)$$

### 2.3.7 กำหนดค่าความหนี้iyuan ของขดลวดปั๊มนูน $L_p$

ค่อนเวอร์เตอร์แบบฟลายแบคทำงานด้วยการเก็บสะสมพลังงานในช่วงเวลาที่ทราบซิสเตอร์กำลังนำกระแส และส่งผ่านพลังงานออกไปในขณะที่ทราบซิสเตอร์กำลังหยุดนำกระแสโดยในแต่ละช่วงเวลาที่ทราบซิสเตอร์กำลังนำกระแส พลังงานที่เก็บสะสมไว้ที่ขดลวดปั๊มนูน สามารถพิจารณาได้ดังนี้

$$E = \frac{1}{2} L_p I_{p(PK)}^2 \quad (2.36)$$

และในขณะที่ทราบซิสเตอร์กำลังหยุดนำกระแสค่อนเวอร์เตอร์จะไม่มีการสะสมพลังงานดังนี้ กำลังงานที่ใช้ไปในหนึ่งคานเวลาจึงมีค่าเท่ากับ

$$P_{in} = \frac{(1/2)L_p I_{p(PK)}^2}{T} \quad (2.37)$$

จาก (2.3) แทนค่าลงใน (2.11) และสามารถจัดรูปใหม่ได้ดังนี้

$$P_{in} = \frac{[(V_{in(min)} - V_{CE(sat)})_{ON(max)}]^2}{2TL_p} \quad (2.38)$$

ถ้าประสิทธิภาพการส่งผ่านพลังงานของวงจร มีค่าเท่ากับ  $\eta$  (ประมาณ 65 - 80 % สำหรับแหล่งจ่ายไฟแบบสวิตซิง) กำลังงานที่ค่อนเวอร์เตอร์จะสามารถจ่ายให้กับโหลดได้จะมีค่า

$$P_{out} = \eta P_{in} = \eta \frac{[(V_{in(min)} - V_{CE(sat)})]_{ON(max)}^2}{2TP_{out}} \quad (2.39)$$

ดังนั้นเพื่อให้ได้ค่าอนัวร์เตอร์แบบฟลัตแบบจำลองสำหรับการคำนวณค่า  $P_{out}$  ค่าความหนาแน่นของขดลวดปฐมภูมิต้องมีค่าอย่างต่ำเท่ากับ

$$L_p = \eta \frac{[(V_{in(max)} - V_{CE(sat)})]_{ON(max)}^2}{2TP_{out}} \quad (2.40)$$

### 2.3.8 จำนวนรอบของขดลวดปฐมภูมิ $N_p$ และจำนวนรอบของขดลวดทุติยภูมิ $N_s$

การกำหนดจำนวนรอบของขดลวดปฐมภูมิ  $N_p$  จะขึ้นอยู่กับขนาดของแกนเฟอร์ไรต์ และความหนาแน่นฟลักซ์สูงสุดที่ยอมให้เกิดขึ้นได้ในแกน โดยจำนวนรอบ  $N_p$  จะมีค่าเท่ากับ

$$N_p = \frac{V_{in(min)} \times t_{ON(max)}}{\Delta B_{max} \times A_e} \times 10^8 \quad (2.41)$$

โดยที่  $\Delta B_{max}$  คือ ค่าความหนาแน่นฟลักซ์สูงสุดที่ยอมให้เกิดขึ้น (เกาส์)

$A_e$  คือ พื้นที่หน้าตัดของแกนเฟอร์ไรต์ (ตารางเซนติเมตร)

$A_e$  คือ พื้นที่หน้าตัดของแกนเฟอร์ไรต์ (ตารางเซนติเมตร)

สำหรับจำนวนรอบของขดลวดทุติยภูมิ  $N_s$  นั้นสามารถหาได้จากค่าอัตราส่วนจำนวนรอบและจำนวนรอบของขดลวดปฐมภูมิที่หาได้จากสมการ (2.41)

### บทที่ 3

## การออกแบบหน้าจอแสดงความถี่สูงแบบฟลายแบค

จากการศึกษาการทำงานของชุดการทำงานและการออกแบบหน้าจอแสดงในบทที่ 2 ชี้ว่างชุดการทำงานต้องถอนเวอร์เตอร์แบบฟลายแบคและหน้าจอแสดงความถี่สูงแบบฟลายแบค ดังนั้นในบทนี้จึงได้อธิบายกระบวนการออกแบบหน้าจอแสดงความถี่สูง เพื่อที่จะนำไปประกอบในชุดข้อมูลแบบเดอร์รีแบบพกพา ดังจะแสดงในหัวข้อต่อไป

### 3.1 การสร้างหน้าจอแสดงความถี่สูงแบบฟลายแบค

วัตถุประสงค์ของการออกแบบหน้าจอแสดงความถี่สูงแบบฟลายแบคในชุดข้อมูลแบบเดอร์รีแบบพกพา นี้เพื่อแปลงลักษณะดั้งเดิมของหน้าจอแสดงความถี่สูงแบบฟลายแบค ให้สามารถแสดงผลลัพธ์ทางภาพได้รวดเร็วและแม่นยำ สำหรับผู้ใช้งานที่ต้องการใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น ผู้ใช้โทรศัพท์มือถือ หรือผู้ใช้คอมพิวเตอร์ ที่ต้องการเข้าใจข้อมูลที่แสดงอยู่บนหน้าจออย่างรวดเร็วและแม่นยำ

#### 3.1.1 ขั้นตอนการสร้างคอนเวอร์เตอร์แบบฟลายแบค

- 1) ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับหน้าจอแสดงความถี่สูงจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น หนังสือ อินเทอร์เน็ต ฯลฯ
- 2) ศึกษาโครงงานตัวอย่างชุดข้อมูลแบบเดอร์รีแบบพกพาสำหรับงานยานยนต์ขนาดเล็กสองล้อเพื่อ นำมาประยุกต์ใช้กับหน้าจอแสดงความถี่สูงแบบฟลายแบค
- 3) ทำการทดสอบหน้าจอแสดงที่มีอยู่เดิม และบันทึกค่าไว้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไข กับ หน้าจอแสดงตัวที่ออกแบบขึ้นมาใหม่
- 4) ทำการออกแบบหน้าจอแสดงความถี่สูงแบบฟลายแบค โดยออกแบบให้มีความหลากหลาย เพื่อรองรับความต้องการของผู้ใช้งานต่างๆ ที่แตกต่างกัน และนำໄไปวิเคราะห์ต่อไป
- 5) จัดซื้ออุปกรณ์ตามที่ได้ศึกษา และออกแบบไว้เพื่อนำมาประกอบหน้าจอแสดง และวงจร
- 6) ทำการพัฒนาหน้าจอแสดงความถี่สูงแบบฟลายแบค โดยเลือกใช้อุปกรณ์ตามที่ออกแบบไว้ อย่างเหมาะสม สามารถทำงานต่อกราฟิก แรงดัน ที่คำนวณได้ โดยพัฒนาให้มีความคล่องตัว 3 ชุด คือ ชุดควบคุมภูมิ ชุดควบคุมภูมิและชุดควบคุมช่วง ลักษณะการพัฒนาให้พัฒนาขึ้นกัน ระหว่างชุดควบคุมภูมิและชุดควบคุมทุติภูมิ ตามลักษณะของคอนเวอร์เตอร์แบบฟลาย แบค

- 7) ทำการทดสอบหน้อแปลงความถี่สูงแบบฟลายแบคที่ได้สร้างขึ้นแล้วบันทึกผลการทดสอบ
- 8) นำข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์ผลกระบวนการและนำข้อมูลเหล่านี้ไปรวมกับสร้างตัวที่สมบูรณ์และนิปะสิติกาพดีขึ้น
- 9) ทำการสร้างตัวตนแบบที่สมบูรณ์
- 10) ทำการทดสอบหน้อแปลงตัวสมบูรณ์ และบันทึกผล
- 11) สรุปผลการทดสอบและเปรียบเทียบ

### 3.1.2 ตัวอย่างการออกแบบหน้อแปลงความถี่สูงแบบฟลายแบค

เพื่อความเข้าใจและเป็นแนวทางในการออกแบบหน้อแปลงความถี่สูงเพื่อใช้กับวงจรฟลายแบคของเวย์เตอร์ ที่กำลังเอาต์พุตเท่ากับ 45 วัลต์ ที่แรงดันเอาต์พุต 36 โวลต์ และกระแส 1.25 แอมป์ โดยตอนเวย์เตอร์ใช้กับแรงดันไฟสัลบ 220 โวลต์ความถี่ 50 กิโลเฮิรตซ์ มีการออกแบบขดลวดของหน้อแปลงความถี่สูงแบบฟลายแบคออกแบบเป็น 3 ชุดคือ ขดลวดปฐมภูมิ ( $N_p$ ) ขดลวดที่二ภูมิ ( $N_s$ ) และขดลวดช่วย ( $N_b$ ) การกำหนดขนาดขดลวดโดยมีข้อควรพิจารณาประกอบคือ เมื่อพันขดลวดทุกชุดลงบนเก็นบนอบบีนแล้ว ความสูงของขดลวดทั้งหมดจะต้องไม่เกินความสูงของช่องพันขดลวดบนอบบีน ( $H_{CF}$ ) เพราะจะทำให้พันไม่ได้

$$\begin{aligned} t_{ON(max)} &= 0.4T \\ &= 8 \times 10^{-6} \end{aligned} \quad (3.1)$$

ถ้ากำหนดแรงดันไฟตรงอินพุตค่าต่ำสุด  $V_{in(min)}$  ของเวย์เตอร์ไว้ที่ 300 โวลต์และ  $V_{CE(sat)} = V_D = 1$  โวลต์จะได้ว่า

$$\frac{N_p}{N_s} = \frac{(310 - 300) \times 8 \times 10^{-6}}{(36 + 21) \times 20 \times 10^{-6}}$$

ในที่นี้เลือก  $\frac{N_p}{N_s} = 8.9$

ตารางที่ 3.1 ตัวอย่างการคำนวณค้านปฐมภูมิ ( $N_p$ )

ข้อมูลแกนเฟอร์ไรต์	EE 33	EI35	EE40	หน่วย
ขนาดพื้นที่หน้าตัดแกนเฟอร์ไรต์ ( $A_e$ )	0.81	1.22	1.48	$cm^2$
ขนาดพื้นที่ของพื้นที่คลุมขอบบีน ( $A_w$ )	1.33	1.36	1.57	$cm^2$
ปริมาตรของแกนเฟอร์ไรต์ ( $V_e$ )	8	8.35	11.3	$cm^3$
ระยะฟลักซ์แม่เหล็กในแกนเฟอร์ไรต์ ( $I_e$ )	67.5	68	77	$mm$
ความกว้างของบอนบีน ( $B_{CF}$ )	15	15	18	$mm$
ระยะทางที่สามารถใช้พื้นที่คลุมทองแดงได้ ( $b_w = B_{CF} - C$ , $C = 8 mm$ )	15-8=7	15-8=7	18-8=10	$mm$
ความสูงของบอนบีนรับได้ ( $H_{CF}$ )	65	55	70	$m$
$\Delta B_{max}$	1800	1800	1800	Gauss
จำนวนรอบของขดลวดปฐมภูมิ				
$(N_p = \frac{(V_{in(min)} - V_{CE(sat)})t_{ON(max)} \times 10^8}{\Delta B_{max} \times A_e})$	11	8	6	
เลือกจำนวนรอบเป็นเลขคู่ ( $N_p$ )	11	8	6	
ค่าความต้านทานของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 漉ดทองแดง ( $d_{id}$ )	0.62	0.6688	0.8291	$mm$
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ( $d$ )	0.6426(#22)	0.6426(#22)	0.8128(#20)	$mm$
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเมื่อรวนกลม ( $d_0$ )	0.7214	07214.	0.8966	$mm$
ระยะเรียงชิดคำสุด ( $t_{min}$ )	0.754	0.754	0.937	$mm$
ความต้านทานที่ $100^\circ$ ( $R_{dc}$ )	0.06852	0.06852	0.04283	$\Omega / m$
จำนวนชั้นของขดลวดทองแดง				
$P_{id} = N / (\frac{b_w}{t_{min}} - 1)$	1.31	0.96	0.6195	
ชั้นที่เลือก ( $P$ )	2	1	1	
ความสูงของคลุมบนบอนบีน				
$(H_{id} = P(d_0 + i), i = 0.04 mm)$	1.522	0.7614	0.9366	$mm$
$F_R = 1 + \frac{1}{2}(\frac{d}{d_{id}})^6$	1.61	1.3934	1.4438	
ค่าความต้านทานที่กระแสตรงต่อหนึ่งหน่วย ความยาวของขดลวด ( $R_{ac} = F_R R_{dc}$ )	0.11	0.0954	0.06183	$\Omega / m$
กำลังสูญเสียที่เกิดขึ้นในขดลวด				
$P_w = C I_{rms}^2 N l_{av} R_{ac}, c = 1$	0.2239	0.01545	0.086	$W$

ตารางที่ 3.2 ตัวอย่างการคำนวณค้านทุติกูมิ ( $N_s$ )

จำนวนรอบ ( $N_s$ )	29	21	16	รอบ
เดือกจำนวนรอบ ( $N_s$ )	29	21	16	รอบ
$D_{id} = (17.1 b_w / N_s f)^{1/3}$	0.4354	0.4848	0.5979	mm
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง (d)	0.5105(#24)	0.5105(#24)	0.5740(#23)	mm
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเมื่อร่วมกัน ( $d_0$ )	0.5817	0.5817	0.6502	mm
ระยะเรียงชิดต่ำสุด ( $t_{min}$ )	0.608	0.608	0.679	mm
ความค้านทานที่ $100^0$ ( $R_{dc}$ )	0.10860	0.10860	0.08586	$\Omega / m$
จำนวนชั้นของขดลวดทองแดง				
$P_{id} = N / \left( \frac{b_w}{t_{min}} - 1 \right)$	2.75	1.99	1.16	
$t = Pb_w / (N+P)$	3	2	2	
$t = 0.5b_w / (N+0.5)$	0.6562	0.60	1.111	mm
ความสูงขดลวดบนอบบีน ( $H_{id} = d_0 + i$ )	0.6217	0.6217	0.692	mm
$\varphi = \sqrt{\frac{0.124 f d^3}{t}}$	1.12	1.17	1.456	
$F_R$	2.1	1.5	1.9	
ค่าความค้านทานที่กระแสตรงต่อหนึ่งหน่วย ความยาวของขดลวด ( $R_{ac} = F_R R_{dc}$ )	0.23	0.163	0.1974	$\Omega / m$
กำลังสูญเสียที่เกิดขึ้นในขดลวด				
$P_w = CI_{rms}^2 N I_{av} R_{ac}, c=1$	0.175	0.0965	0.0863	W

ตารางที่ 3.3 ตัวอย่างการคำนวณด้านขดลวดซี่ง ( $N_s$ )

ขนาดของเกณฑ์ไฮต์	EE33	EI35	EI40	หน่วย
จำนวนรอบ ( $N_s$ )	123	123	123	รอบ
เลือก $d < \Delta e$ ,				
$\Delta e = \sqrt{5.62 / f} = 0.335 \text{ mm}$				
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ( $d$ )	0.3200(#24)	0.3200(#24)	0.3200(#24)	mm
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเมื่อร่วมกัน ( $d_0$ )	0.3759	0.3759	0.3759	mm
ระยะเรียงชิดต่ำสุด ( $t_{\min}$ )	0.393	0.393	0.393	
จำนวนชั้นของขดลวดทองแดง				
$P_{id} = N / \left( \frac{b_w}{t_{\min}} - 1 \right)$	7.316	7.316	5.032	
จำนวนชั้นที่เลือก ( $P$ )	8	8	6	รอบ
ความสูงของคลาวบนบอนบัน ( $H_{id} = d_0 + i$ )	3.327	3.327	2.495	mm

ตารางที่ 3.4 ผลกำลังสูญเสียและความสูงทั้งหมดของขดลวด

ขนาดของเกณฑ์ไฮต์	EE33	EI35	EI40	หน่วย
ความสูงของขดปูนภูมิ $N_p$	1.522	0.7614	0.9366	mm
ความสูงของขดทุติภูมิ $N_s$	0.6217	0.6217	0.692	mm
ความสูงของขดคีเมากเน่ ไตรช่อง $N_t$	3.272	3.3.27	2.4954	mm
ความสูงของขดลวด $H_{tot} = H_{Np} + H_{Ns} + H_{Nr}$	5.4157	4.655	4.124	mm
ความสูงรวมของเทปจำนวน $= 0.4+0.4+0.4+0.4$	1.6	1.6	1.6	mm
ความสูงของบอนบัน $H_{CF}$	65	55	70	mm
กำลังสูญเสียบนขดลวดทั้งหมด $P_{tot}$	0.615	0.4160	0.2583	W
อุณหภูมิของหม้อแปลงที่เพิ่มขึ้น				
$P_{id} = \Delta T = \frac{23.5 P_{tot}}{\sqrt{Ae \cdot Aw}}$	13.924	7.6	3.98	°C
อุณหภูมิของหม้อแปลงขณะทำงาน ( $T+25$ °C)	38.924	32.6	28.98	°C

### 3.1.3 การเลือกใช้อุปกรณ์ในการพันห้องแม่เหล็กความถี่สูงแบบฟลายแบค

ในการออกแบบหม้อแปลงความถี่สูงเพื่อใช้กับวงจรฟลายแบคตอนเวอร์เตอร์ ที่ความถี่ 50 กิโลเฮิรตซ์ กำลังเอาต์พุตเท่ากับ 45 วัตต์ ที่แรงดันเอาต์พุต 36 โวลต์ และกระแสสูงสุด 1.3 แอมป์ โดยตอนเวอร์เตอร์ใช้กับแรงดันไฟฟ้าลับ 220 โวลต์ความถี่ 50 เฮิรตซ์ มีการออกแบบขดลวดของหม้อแปลงความถี่สูงแบบฟลายแบคออกเป็น 3 ชุดคือ ขดลวดปฐมภูมิ ( $N_p$ ) จำนวน 6 รอบ ขดลวดที่二ภูมิ ( $N_s$ ) จำนวน 16 รอบ และขดลวดช่วย ( $N_a$ ) จำนวน 123 รอบ

#### 1) แกนเฟอร์ไรต์ (Ferrite Core)

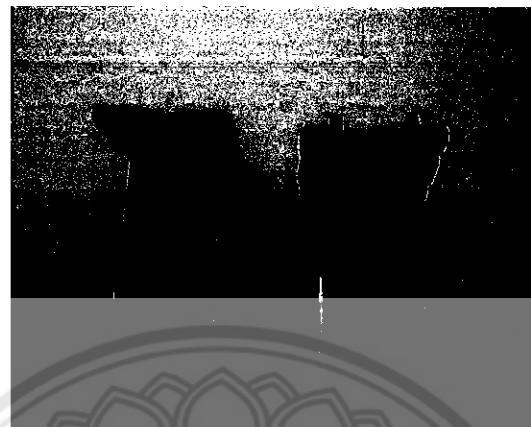
เฟอร์ไรต์เป็นวัสดุประเกทสารเฟอร์โรแมกเนติก การเหนี่ยวนำแม่เหล็กบนแกนเฟอร์ไรต์จะมีผลทำให้เกิดความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็กสูงสุดกว่าการเหนี่ยวนำแม่เหล็กที่เกิดขึ้นบนแกนอากาศมาก แกนเฟอร์ไรต์มีค่าจุดอิมตัวฟลักซ์แม่เหล็กค่อนข้างสูง ประมาณในช่วง 3,000 ถึง 4,000 เกาส์ และเกิดการสูญเสียในแกนเฟอร์ไรต์ต่ำที่ความถี่สูงๆ จากที่กำลังเอาต์พุต 45 วัตต์ดังนั้นจึงเลือกใช้แกนเฟอร์ไรต์ขนาด EI 40



รูปที่ 3.1 ลักษณะแกนเฟอร์ไรต์ขนาด EI 40

## 2) บอนบีน (Bobbin)

บอนบีนหรือแบบรองพื้น ทนความร้อนสูงและไม่ติดไฟ บอนบีนจะมีขนาดมาตรฐานตามมาตรฐานของแกนเฟอร์ไรต์ ซึ่งเลือกตามขนาดของแกนเฟอร์ไรต์ขนาด EI 40



รูปที่ 3.2 ลักษณะบอนบีนหรือแบบรองพื้นขนาด EI 40

## 3) สวัสดิ์ทองแดงอาบน้ำ (Enamelled Copper Wire)

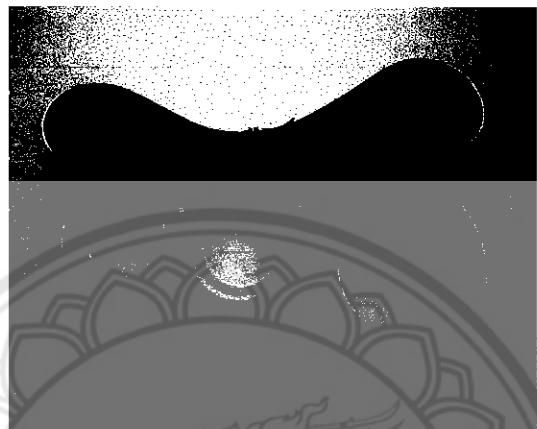
การพันขดลวดปูนภูมิ ขดลวดทุติยภูมิ และขดลวดช่วยของหม้อแปลงความถี่สูงที่กำลังสูงปกติจะใช้สวัสดิ์ทองแดงอาบน้ำพันบนแกนบอนบีน เพื่อให้ได้จำนวนรอบตามต้องการ ขนาดของขดลวดทองแดงที่ใช้พันนั้น ขึ้นอยู่กับค่ากระแสสูงสุดที่ผ่านขดลวด ความถี่และผลข้างเคียงอื่นๆ ที่ขนาดกระแส 1.3 แอมป์ความถี่ 50 กิโลเฮิรตซ์ เมื่อจากที่ความถี่สูงกระแสจะใช้พื้นที่ให้เพียง 37% ของเดือนลวดเท่านั้นดังนั้นจึงเลือกขนาดขดลวดปูนภูมิ ( $N_p$ ) ขดลวดทุติยภูมิ ( $N_t$ ) เมอร์ 20 สามารถใช้ที่พิกัดกระแส 1.362 แอมป์ (ทานกระแสสูงสุดได้ที่ 2.04 แอมป์) ขนาดขดลวดช่วยใช้เมอร์ 28 สามารถทานกระแสสูงสุดได้เท่ากับ 0.3196 แอมป์



รูปที่ 3.3 ลักษณะขดลวดทองแดงอาบน้ำ

#### 4) เทปปอนวัน (Insulation Tape)

เทปปอนวันใช้พันสำหรับเป็นตัวรองระหว่างชั้นของขดลวดในหม้อแปลงความถี่สูง และมีหน้าที่สำคัญในการแยกกันทางไฟฟ้าระหว่างขดลวดปฐมภูมิและขดลวดทุติยภูมิการเลือกใช้ในการออกแบบเพื่อความปลอดภัย เทปที่ใช้ต้องสามารถร้อนได้สูงและไม่ติดไฟและบางคัวบีจึงเลือกใช้เทปพันสายไฟที่ทนแรงดันไฟฟ้าได้สูงถึง 600 โวลต์ ทนอุณหภูมิได้  $100^{\circ}$



รูปที่ 3.4 ลักษณะเทปปอนวัน

หลังจากที่ออกแบบและเลือกอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วทำการพันหม้อแปลงความถี่สูงแบบฟลายแบค โดยพันให้มีขดลวด 3 ชุด คือ ขดลวดปฐมภูมิ ขดลวดทุติยภูมิและขดลวดช่วง ลักษณะการพันให้พันกลับขึ้กันระหว่างขดลวดปฐมภูมิและขดลวดทุติยภูมิตามลักษณะของกองเวอร์เตอร์แบบฟลายแบคที่กล่าวไว้ข้างต้นแล้วจะได้มีหม้อแปลงที่พันสำเร็จดังรูปที่ 3.5



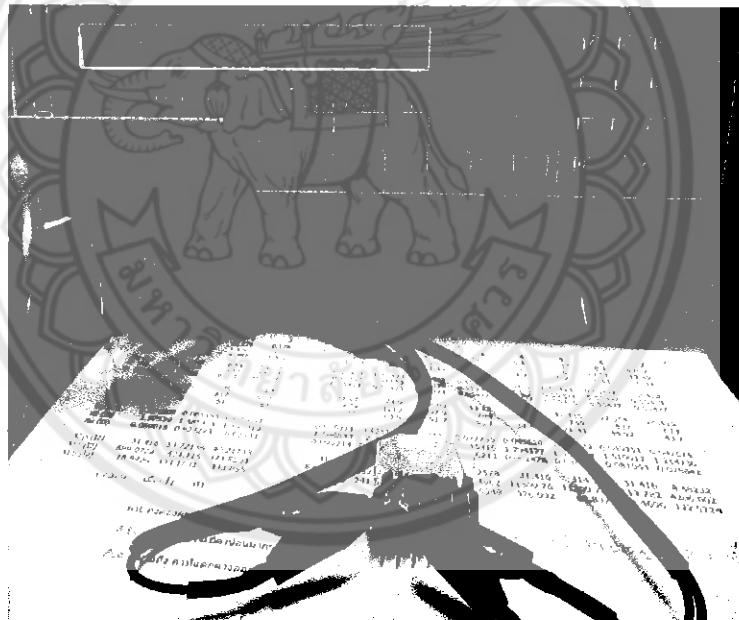
รูปที่ 3.5 ลักษณะหม้อแปลง

## บทที่ 4

### ผลการทดลองและวิเคราะห์ผล

จากการที่ได้ทำการออกแบบหน้าจอแสดงความถี่สูงแบบฟลายเบนและเลือกอุปกรณ์แล้ว ได้ทำการวัดค่าโดยการใช้เครื่องวัด HP 4263 LCR Meter at Glance วัดหาค่าพารามิเตอร์ของ ขดลวดหน้าจอแปลง เช่น ความเหนี่ยวนำ (*L*) ของขดลวดแต่ละชุด ค่าความต้านทาน (*R*) ของขดลวด แต่ละชุดเพื่อนำผลที่ได้วิเคราะห์ถึงการเปลี่ยนแปลงและนำไปเปรียบเทียบนำไปสู่การออกแบบ หน้าจอแปลงที่มีประสิทธิภาพค่อไป

#### 4.1 รูปของการออกแบบการพันหน้าจอแปลงและผลการวัดค่าพารามิเตอร์

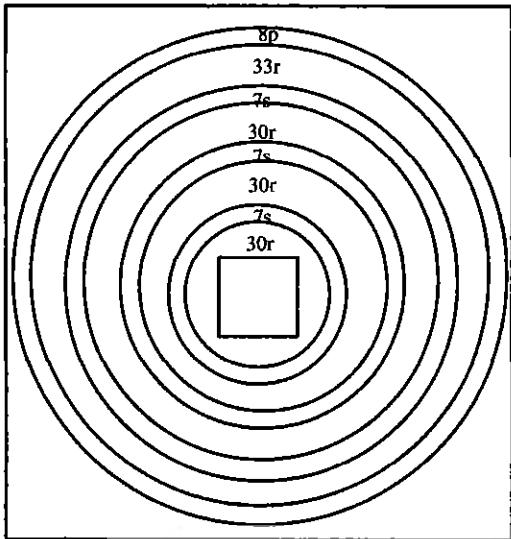


รูปที่ 4.1 วัดหาค่าความเหนี่ยวนำ (*L*) ค่าความต้านทาน (*R*) ของขดลวดหน้าจอแปลง

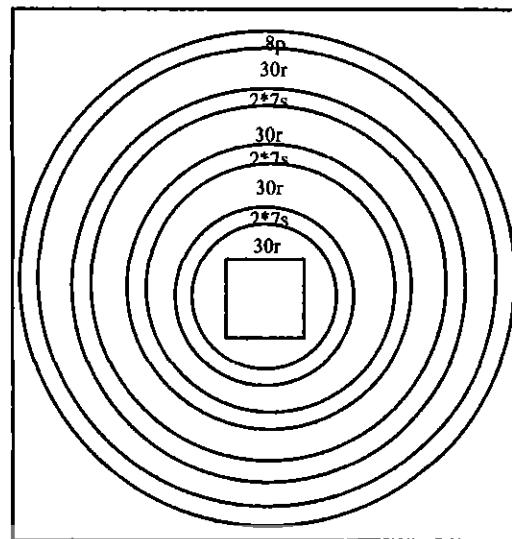
โดยตั้งพิกัดการวัดที่ระดับความถี่ 100 kHz ระดับแรงดันเท่ากับ 1000 mV

##### 4.1.1 รูปการออกแบบการพันของหน้าจอแปลงและผลการทดสอบ

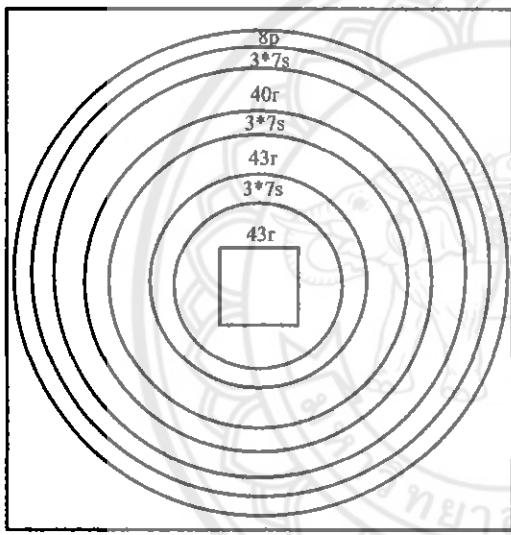
ขั้นตอนนี้เป็นรูปของการออกแบบของหน้าจอแปลงความถี่สูงและผลของการวัดค่าความ เหนี่ยวนำของขดลวด (*L*) ค่าความต้านทานของขดลวด (*R*) และค่าความเร็วแอกแตนซ์ (*XL*)



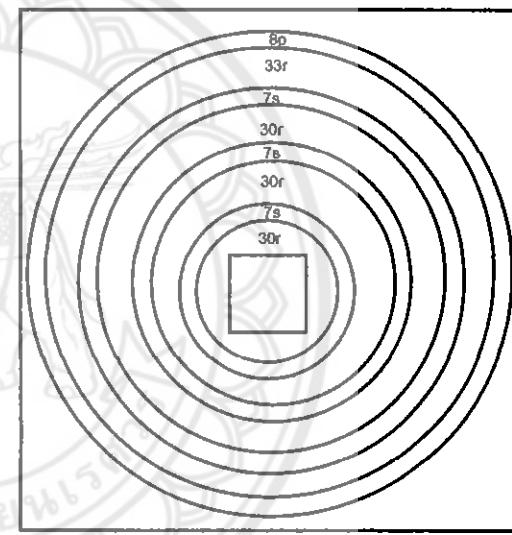
(ก) สักษณะการพัฒนามือแปลงตัวอ้างอิง



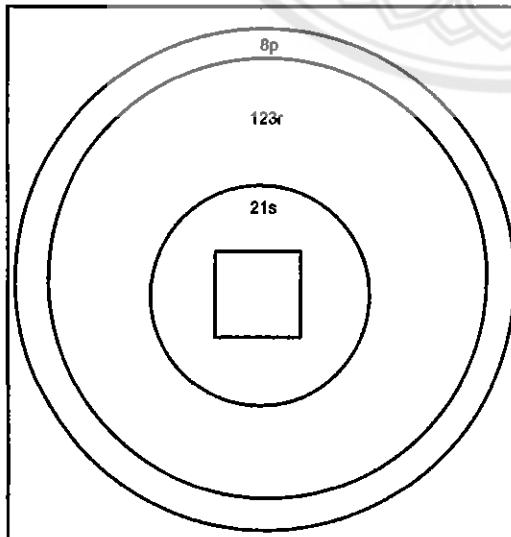
(ว) ลักษณะการพัฒนามือแปลงตัว 1



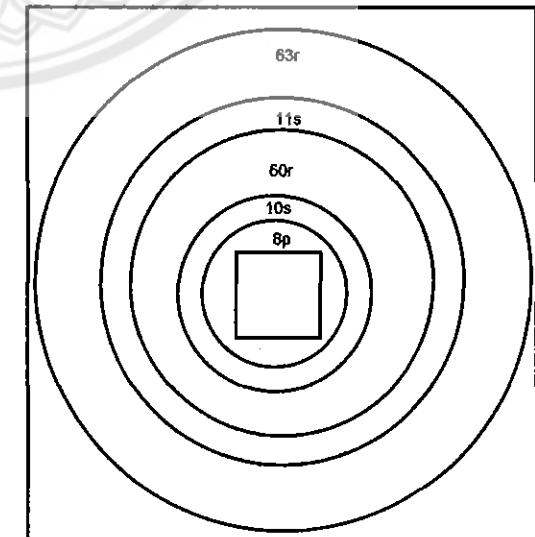
(ก) ตั้งigmะการพั่นหม้อแปลงทัว 2



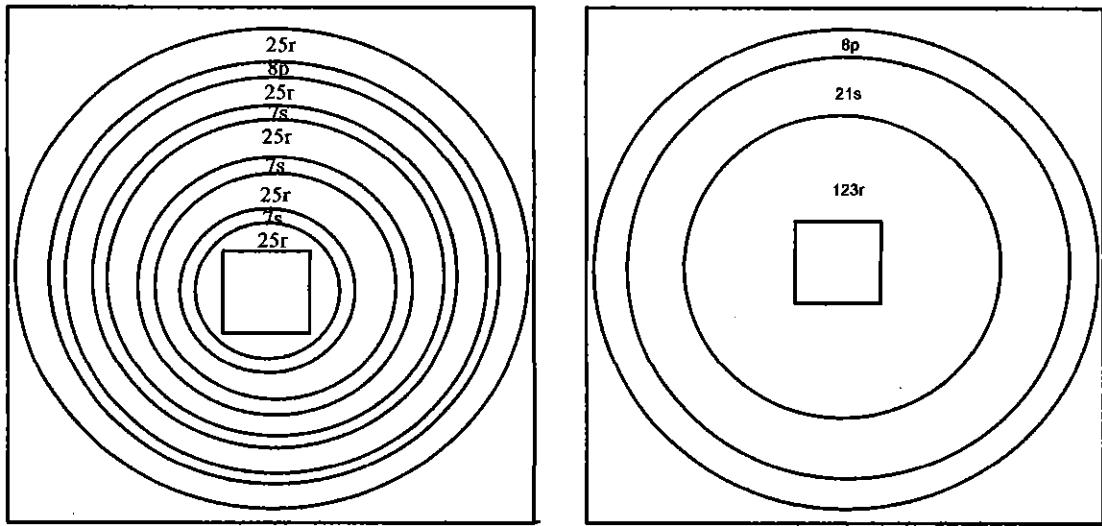
### (๑) ลักษณะการพัฒนามือแปลงตัวที่ ๓



(ก) ลักษณะการพัฒนามือเปล่งตัวที่ 4



(น) ลักษณะการพัฒนามือเปล่งตัวที่ 5



(ช) ลักษณะการพันหนื้นแม่เหล็กตัวที่ 6

(ช) ลักษณะการพันหนื้นแม่เหล็กตัวที่ 7

### รูปที่ 4.2 การออกแบบหนื้นแม่เหล็กเพื่อเปลี่ยนความถี่สูงลักษณะต่างๆ

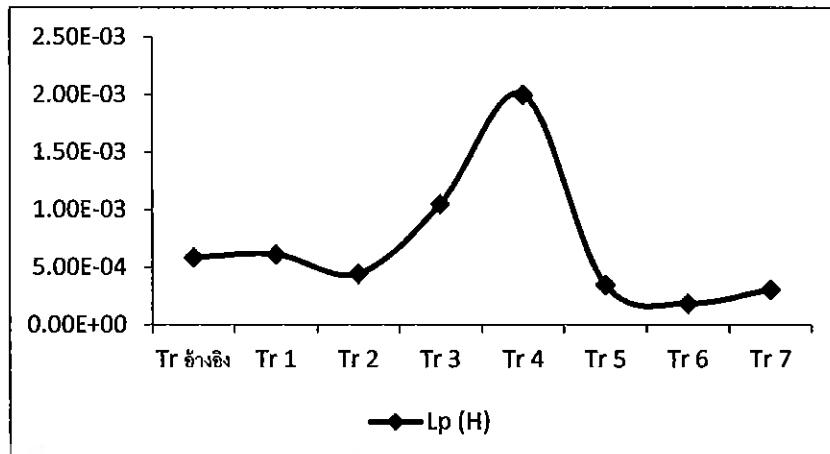
#### 4.1.2 ผลการวัดค่าพารามิเตอร์ของหนื้นแม่เหล็กเพื่อเปลี่ยนความถี่สูง (ไม่มีช่องอากาศคั่น)

จากผลการทดสอบข้างต้นพบว่า ค่าเฉลี่ยของหนื้นแม่เหล็กเพื่อเปลี่ยนความถี่สูง ขณะไม่มีช่องอากาศคั่นทางเดินแม่เหล็กในแกนเฟอร์ไรร่าทำให้ค่าความหนาแน่นนำสูงภายในหนื้นแม่เหล็ก เป็นส่วนใหญ่ เกิดค่ารีแอคแทนซ์ภายนอกคลื่นมากขึ้นตาม ซึ่งทำให้ค่าประสิทธิภาพของหนื้นแม่เหล็ก

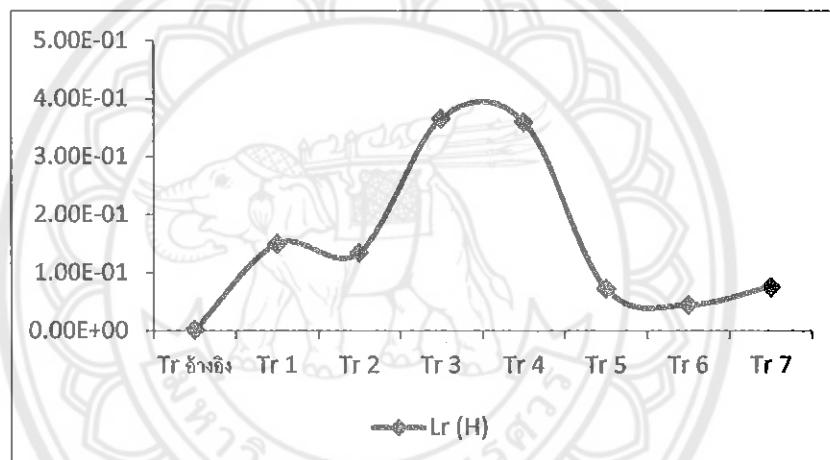
ตารางที่ 4.1 ค่าเฉลี่ยพารามิเตอร์ของหนื้นแม่เหล็กเพื่อเปลี่ยนความถี่สูง (ยังไม่มีช่องอากาศคั่น)

ค่า	Tr ห้อง	Tr 1	Tr 2	Tr 3	Tr 4	Tr 5	Tr 6	Tr 7
Lp (H)	1.33E-5	6.12E-4	4.46E-4	1.05E-3	2.00E-3	3.50E-4	1.87E-4	3.06E-4
Lr (H)	2.32E-3	1.50E-1	1.35E-1	3.66E-1	3.60E-1	7.27E-2	4.49E-2	7.58E-2
Ls(H)	8.16E-5	4.32E-3	4.20E-3	9.98E-3	1.33E-2	2.13E-3	1.34E-3	2.17E-3
Rp ( $\Omega$ )	2.03E-1	3.89E-1	2.05E-1	2.26E-1	2.01E-1	1.95E-1	2.02E-1	2.01E-1
Rr ( $\Omega$ )	1.41E+0	4.21E+0	1.93E+0	1.63E+0	1.42E+0	1.47E+0	1.63E+0	1.37E+0
Rs ( $\Omega$ )	2.37E-1	2.75E-1	4.02E-1	2.29E-1	2.17E-1	2.31E-1	2.42E-1	2.36E-1
XLp( $\Omega$ )	4.18E-3	1.92E-1	1.40E-1	3.31E-1	6.28E-1	1.10E-1	5.89E-2	9.61E-2
XLr( $\Omega$ )	7.30E-1	4.71E+1	4.25E+1	1.15E+2	1.13E+2	2.28E+1	1.41E+1	2.38E+1
XLs( $\Omega$ )	2.56E-2	1.36E+0	1.32E+0	3.14E+0	4.16E+0	6.70E-1	4.21E-1	6.83E-1

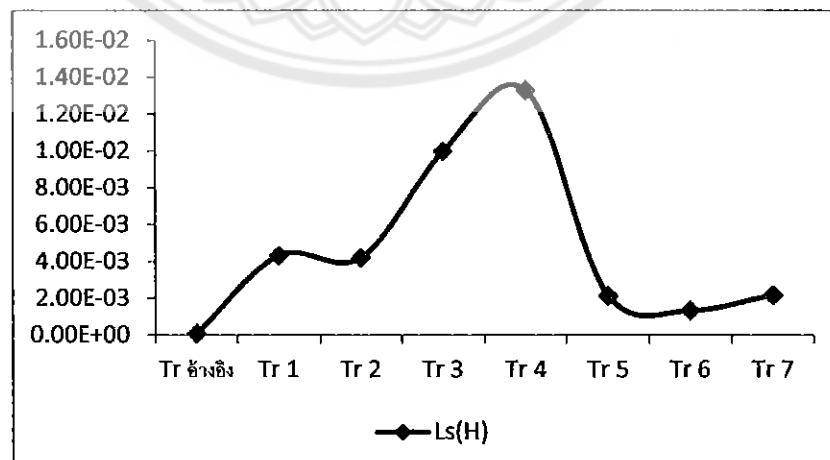
#### 4.1.3 กราฟแสดงค่าของพารามิเตอร์ของหม้อแปลงความถี่สูง



(ก) เปรียบเทียบค่าความเหนี่ยวแน่น้ำในขดลวดปฐมภูมิ

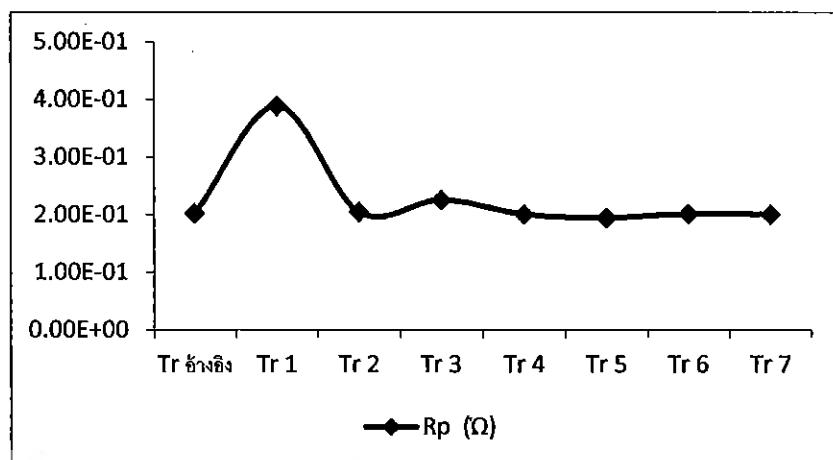


(ข) เปรียบเทียบค่าความเหนี่ยวแน่น้ำในขดลวดช่วย

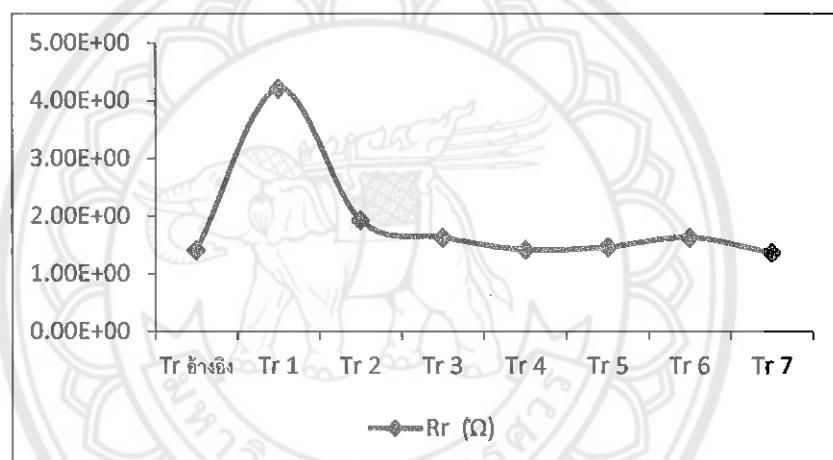


(ค) เปรียบเทียบค่าความเหนี่ยวแน่น้ำในขดลวดทุติยภูมิ

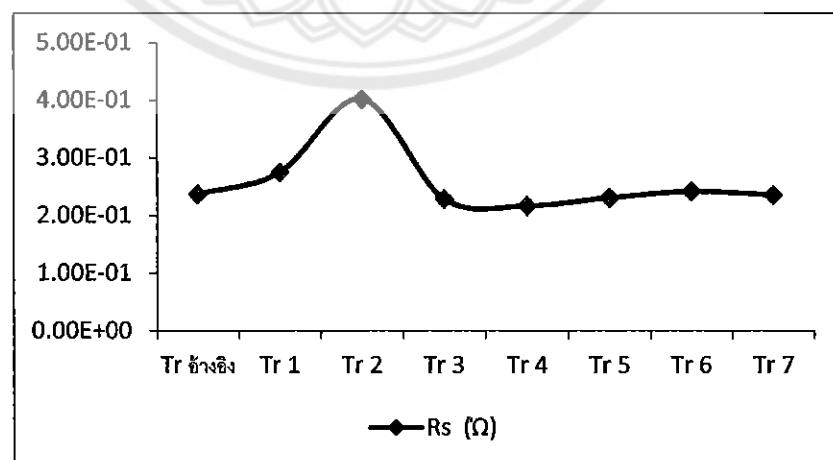
รูปที่ 4.3 กราฟแสดงการเปรียบเทียบค่าความเหนี่ยวแน่นของหม้อแปลง



(ก) เปรียบเทียบค่าความต้านทานในขดลวดปั๊มภูมิ

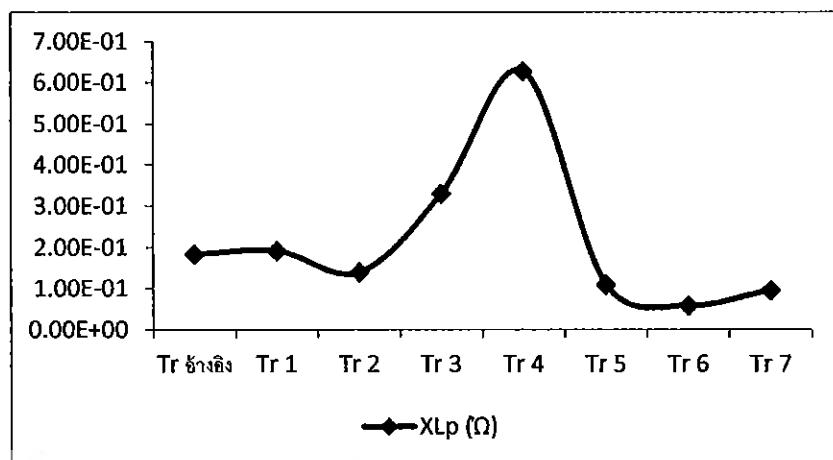


(ข) เปรียบเทียบค่าความต้านทานในขดลวดช่วย

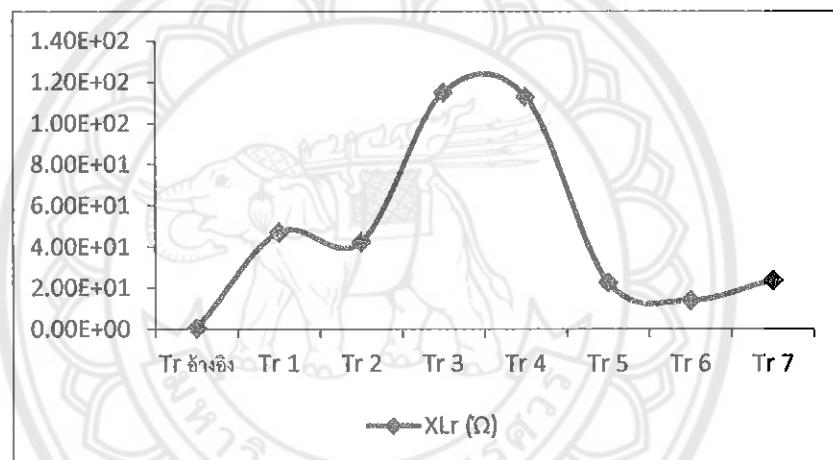


(ค) เปรียบเทียบค่าความต้านทานในขดลวดทุติยภูมิ

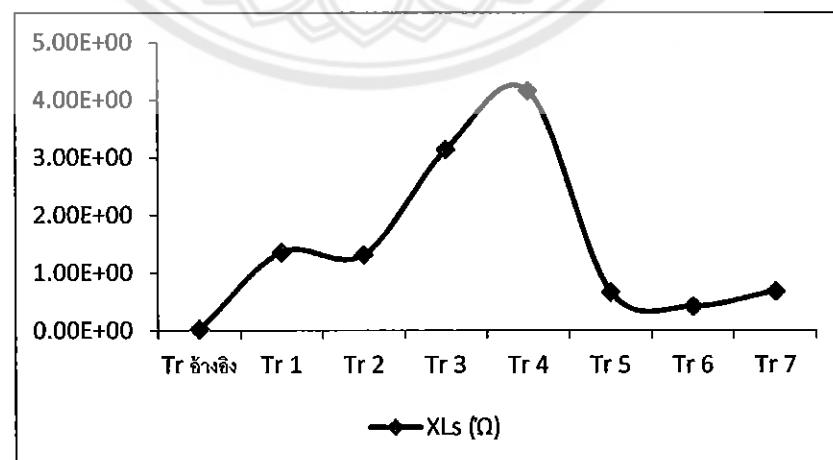
รูปที่ 4.4 กราฟแสดงการเปรียบเทียบค่าความต้านทานของหม้อแปลง



(ก) เปรียบเทียบค่าความรีแอคแทนซ์ในขดลวดปั๊มภูมิ



(ข) เปรียบเทียบค่าความรีแอคแทนซ์ในขดลวดช่วย



(ค) เปรียบเทียบค่าความรีอคแทนซ์ในขดลวดทุติยภูมิ

รูปที่ 4.5 กราฟแสดงการเปรียบเทียบค่ารีแอคแทนซ์ของหม้อแปลง

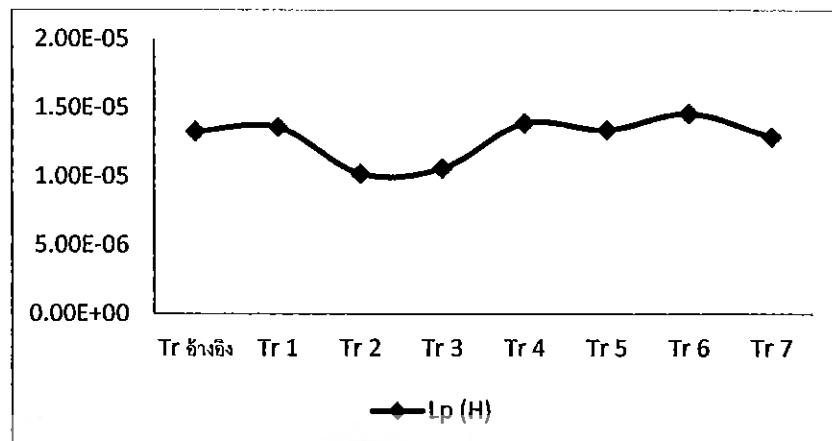
#### 4.1.4 ผลการวัดค่าพารามิเตอร์ของหม้อแปลงความถี่สูง (เพิ่มช่องอากาศคั้น)

จากผลการทดสอบข้างต้นพบว่าค่าเฉลี่ยของหม้อแปลงความถี่สูง ขณะเพิ่มช่องอากาศคั้นทางเดินแม่เหล็ก (Air Gap) ในแกนเฟอร์ไรต์ เป็นการป้องกันการอิ่มตัวของแกนเฟอร์ไรต์ และช่วยให้การสะสมพลังงานของขดลวดในหม้อแปลงสวิตซิ่งที่ความถี่สูงมีค่ามากขึ้น จะเห็นคังกราฟที่แสดงพบว่าค่าความเหนี่ยวนำของหม้อแปลงจะลดลงส่งผลให้ค่ารีแอคแทนซ์มีค่าลดลงด้วยให้ประสิทธิภาพของหม้อแปลงดีขึ้นตามลำดับ

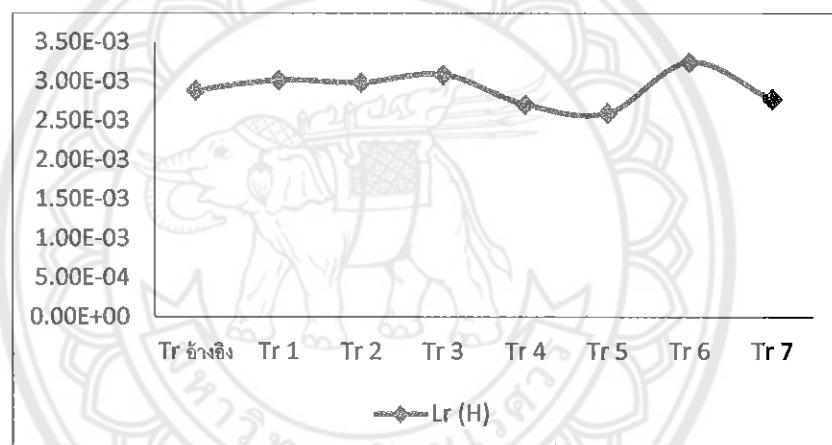
ตารางที่ 4.2 ค่าเฉลี่ยพารามิเตอร์ของหม้อแปลงความถี่สูง (เพิ่มช่องอากาศคั้น)

ค่า	Tr อังกฤษ	Tr 1	Tr 2	Tr 3	Tr 4	Tr 5	Tr 6	Tr 7
Lp (H)	1.33E-5	1.36E-5	1.02E-5	1.06E-5	1.39E-5	1.34E-5	1.46E-5	1.29E-5
Lr (H)	2.89E-3	3.02E-3	2.99E-3	3.09E-3	2.71E-3	2.60E-3	3.25E-3	2.78E-3
Ls(H)	8.17E-5	8.46E-5	8.50E-5	8.66E-5	7.25E-5	7.25E-5	9.45E-5	8.12E-5
Rp ( $\Omega$ )	2.06E-1	2.63E-1	2.04E-1	2.10E-1	2.17E-1	2.14E-1	2.13E-1	2.17E-1
Rr ( $\Omega$ )	1.70E+0	1.76E+0	1.95E+0	1.59E+0	1.45E+0	1.47E+0	1.65E+0	1.36E+0
Rs ( $\Omega$ )	2.36E-1	2.69E-1	2.66E-1	2.32E-1	2.21E-1	2.35E-1	2.40E-1	2.37E-1
XLp( $\Omega$ )	4.19E-3	4.26E-3	3.21E-3	3.32E-3	4.38E-3	4.21E-3	4.60E-3	4.04E-3
XLr( $\Omega$ )	9.07E-1	9.48E-1	9.40E-1	9.70E-1	8.52E-1	8.16E-1	1.02E+0	8.74E-1
XLs( $\Omega$ )	2.57E-2	2.66E-2	2.67E-2	2.72E-2	2.28E-2	2.28E-2	2.97E-2	2.55E-2

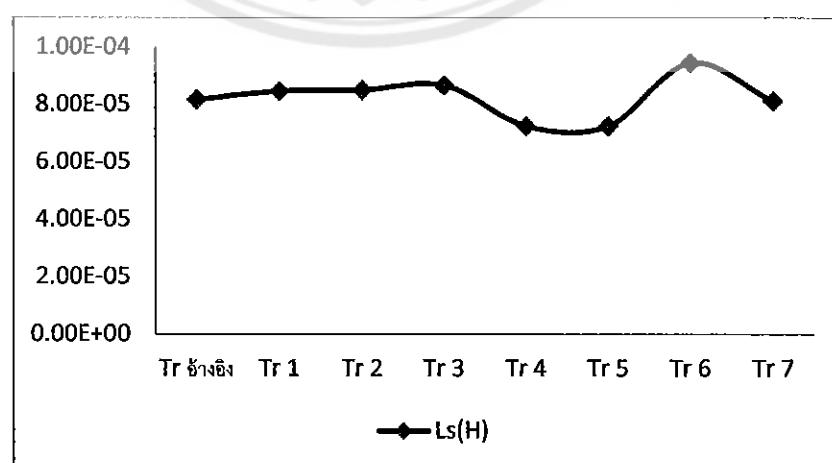
#### 4.1.5 กราฟแสดงค่าของพารามิเตอร์ของหน้าแปลงความถี่สูง



(ก) เปรียบเทียบค่าความหนึ่นยาน้ำในขดลวดปูนภูมิ

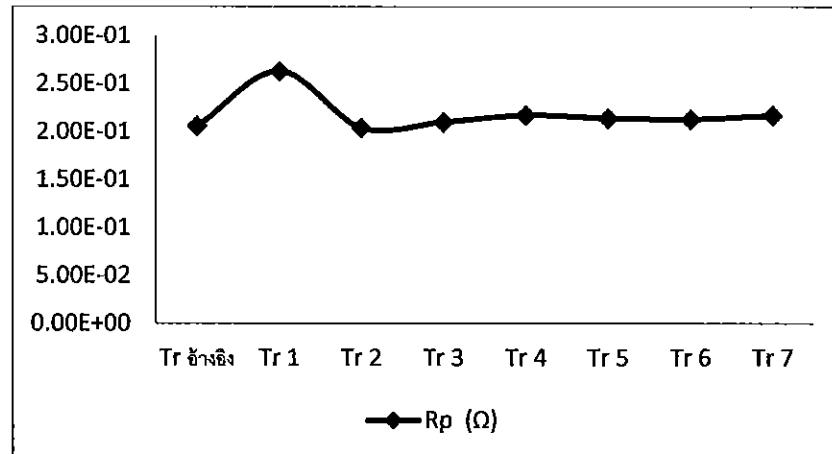


(ก) เปรียบเทียบค่าความหนึ่นยาน้ำในขดลวดช่วย

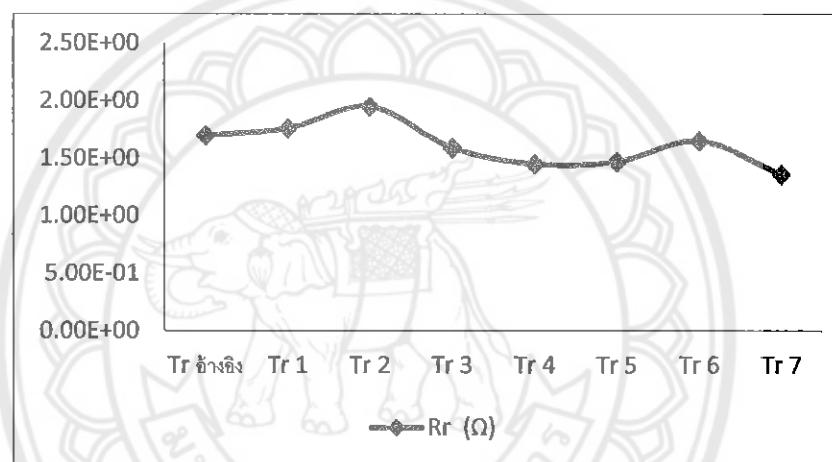


(ก) เปรียบเทียบค่าความหนึ่นยาน้ำในขดลวดทุติยภูมิ

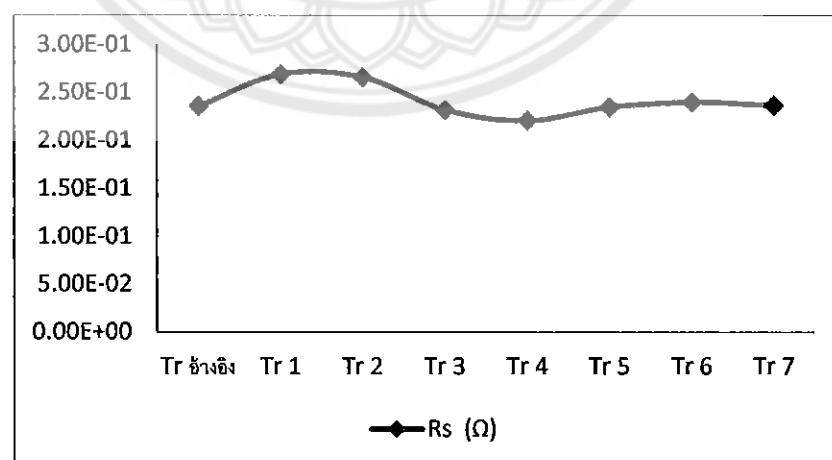
รูปที่ 4.6 กราฟแสดงการเปรียบเทียบค่าความหนึ่นยาน้ำของหน้าแปลง



(ก) เปรียบเทียบค่าความต้านทานในขดลวดปฐมภูมิ

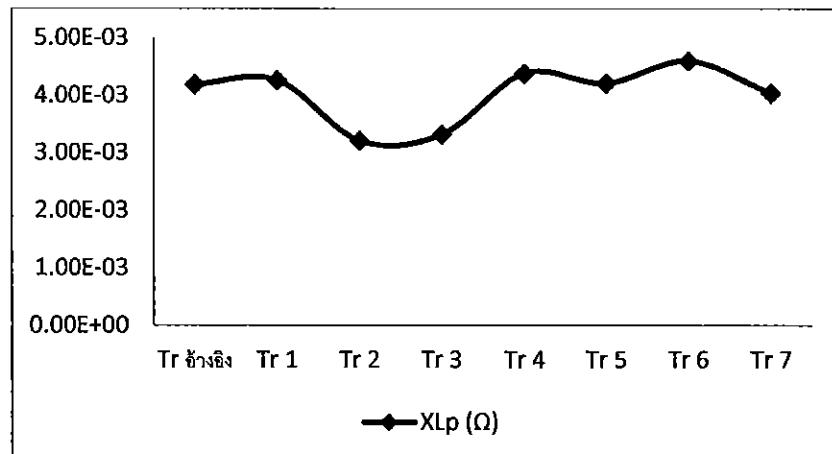


(ข) เปรียบเทียบค่าความต้านทานในขดลวดช่วย

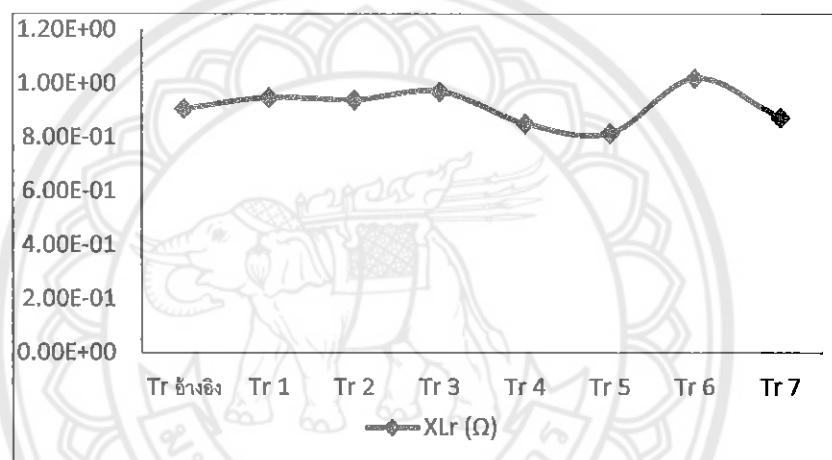


(ก) เปรียบเทียบค่าความต้านทานในขดลวดที่ยืนคงไว้

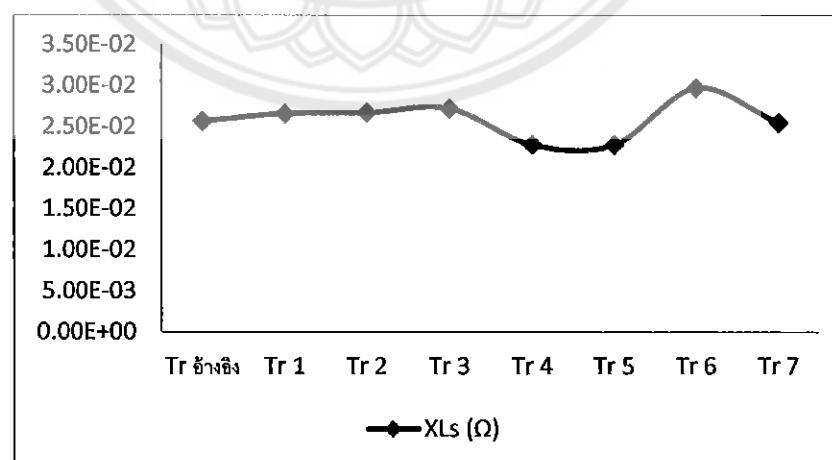
รูปที่ 4.7 เปรียบเทียบค่าความต้านทานของหม้อแปลง



(ก) เปรียบเทียบค่าความรีแอคแทนซ์ในชุดลวดปูนภูมิ



(ข) เปรียบเทียบค่าความรีแอคแทนซ์ในชุดลวดช่วย



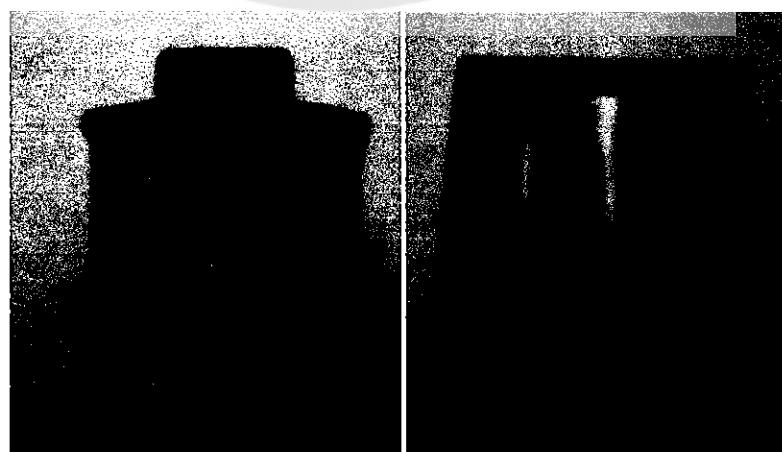
(ค) เปรียบเทียบค่าความรีแอคแทนซ์ในชุดลวดทุติยภูมิ

รูปที่ 4.8 เปรียบเทียบค่าความรีแอคแทนซ์ของหน้าแปลง

#### 4.1.6 วิเคราะห์ผลเพื่อทำการออกแบบหน้าแปลงตัวสมบูรณ์

จากผลการคำนวณข้างต้นในตัวอย่างที่ 3.1.2 การออกแบบหน้าแปลงความถี่สูงแบบฟลายแบนค่าส่งผลให้เห็นว่าการออกแบบหน้าแปลงความถี่สูงนั้นต้องพิจารณาถึงขนาดของขดลวดขนาดของแกนเฟอร์ไรต์ ขนาดของบอนบีนเนื่องจากหากเลือกใช้ขดลวดที่ใหญ่เกินความสูงของบอนบีนก็จะไม่สามารถประกอบแกนเฟอร์ไรต์ได้ แต่หากเลือกเกินไปจะทำให้หน้าแปลงมีความสูญเสียมากและไม่สามารถพิจัดกระแสสูงได้ รูปแบบของการพัน และช่องอากาศคันมีผลต่อการป้องกันการอึมตัวของแกนเฟอร์ไรต์ และช่วยให้การสะสมพลังงานของขดลวดในหน้าแปลงสวิตซิ่งที่ความถี่มีค่ามากขึ้น จะเห็นดังกราฟที่แสดงหัวข้อ 4.14 พนบว่าค่าความหนาแน่นของหน้าแปลงจะลดลงส่งผลให้ค่าเรียกแตนซ์มีค่าลดลงด้วยให้ประสิทธิภาพของหน้าแปลงดีขึ้นตามลำดับ ดังนั้นการออกแบบหน้าแปลงความถี่สูงตัวสมบูรณ์นั้น ต้องอาศัยผลการทดสอบเบื้องต้นทั้ง รูปแบบการพันที่เหมาะสมตามหัวข้อที่ 4.1.1 ด้วย

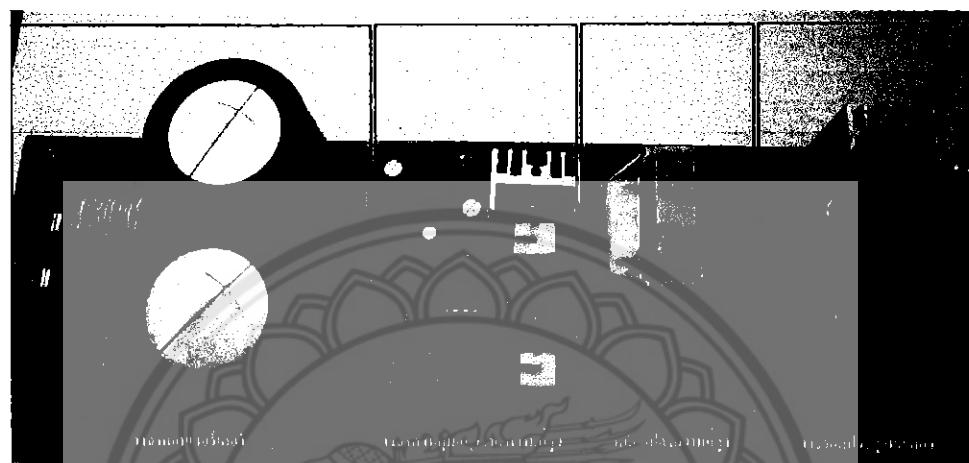
จากการขอคประจุแบบเตอร์ ต้องการหน้าแปลงความถี่ที่พิกัดกำลังเอาต์พุต 45 วัตต์ แรงดันเอาต์พุต 36 โวลต์ และกระแส 1.25 แอมป์ โดยคอนเวอร์เตอร์ในวงจรขอคประจุใช้กับแรงดันไฟสัลบ 220 โวลต์ความถี่ 50 กิโลเฮิรตซ์ โดยมีการออกแบบขดลวดของหน้าแปลงความถี่สูงออกเป็น 3 ชุดคือ ขดลวดปฐมภูมิ ( $N_p$ ) ขดลวดทุติยภูมิ ( $N_s$ ) และขดลวดช่วง ( $N_r$ ) เลือกใช้แกนเฟอร์ไรต์ขนาด EI 40 บอนบีนหรือแบบรองพันขนาด EI 40 เลือกขนาดขดลวดปฐมภูมิ ( $N_p$ ) ขดลวดทุติยภูมิ ( $N_s$ ) เบอร์ 20 สามารถใช้ที่พิกัดกระแส 1.362 แอมป์ (หน่วยกระแสสูงสุดได้ที่ 2.04 แอมป์) ขนาดขดลวดช่วงใช้เบอร์ 28 สามารถทรงกระแสสูงสุดได้เท่ากับ 0.3196 แอมป์ เลือก รูปแบบแบบธรรมชาติรีดดิ้งรูปที่ 4.2 (จ) การพันแบบหน้าแปลงตัวที่ 4 โดยเลือกมีช่องคันอากาศตามตารางคือ 0.77 mm ทำการกลับข้างตามหลักของหน้าแปลงความถี่สูงแบบฟลายแบน



รูปที่ 4.9 หน้าแปลงตัวสมบูรณ์

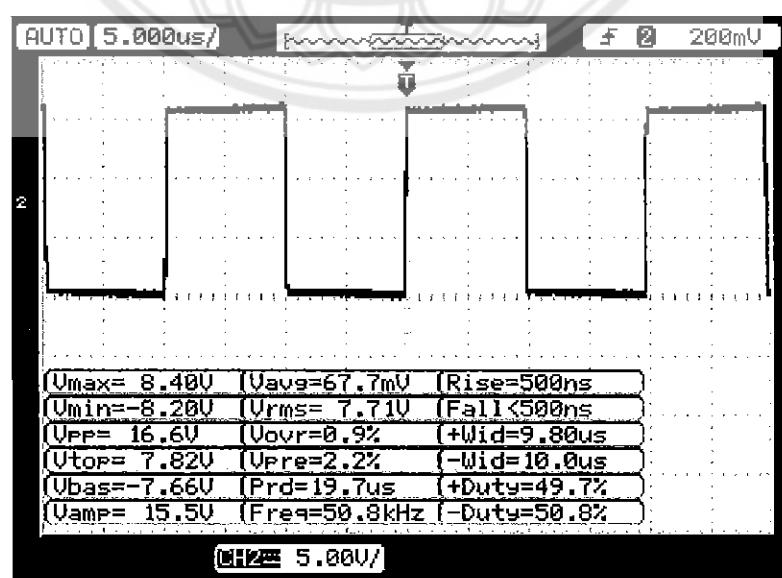
## 4.2 การทดสอบหน้มอแปลงความถี่สูงแบบฟลายแบคในวงจรอัคประจุแบบเตอร์

ขั้นตอนนี้เป็นการประกอบหน้มอแปลงความถี่สูงเข้ากับวงจรอัคประจุแบบเตอร์ และทำการทดสอบ ในขณะที่ไม่มีภาระ โหลด (No Load) เพื่อสังเกตระดับแรงดันทางด้านอินพุต และลักษณะรูปร่างของสัญญาณของแรงดันเอาท์พุตเพื่อเปรียบเทียบค่าระหว่างหน้มอแปลงถังอิมและหน้มอแปลงตัวสมบูรณ์



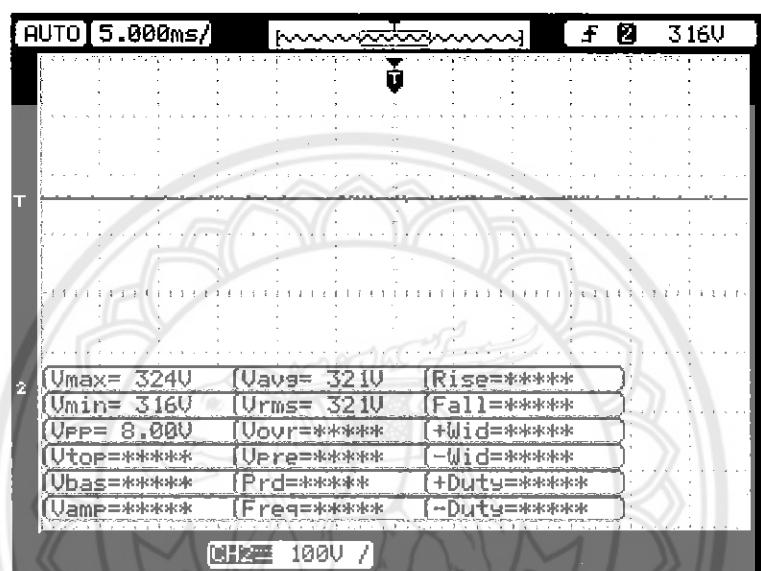
รูปที่ 4.10 วงจรอัคประจุแบบเตอร์

การทดสอบวัดค่าสัญญาณระดับแรงดันของหน้มอแปลงความถี่สูงแบบฟลายแบคในวงจรอัคประจุขณะที่ไม่มีโหลด โดยใช้ออสซิลโลสโคป 100 series ทำการวัดสัญญาณจากวงจรควบคุมสัญญาณความถี่สูง โดยการวัดจากไอซี UC3844 พร้อมวัดระดับแรงดันอินพุตและแรงดันเอาท์พุตที่เกิดขึ้นจริงในวงจรอัคประจุและหน้มอแปลงความถี่สูงแบบฟลายแบค



รูปที่ 4.11 สัญญาณควบคุมสวิตช์ของไอซี UC3844

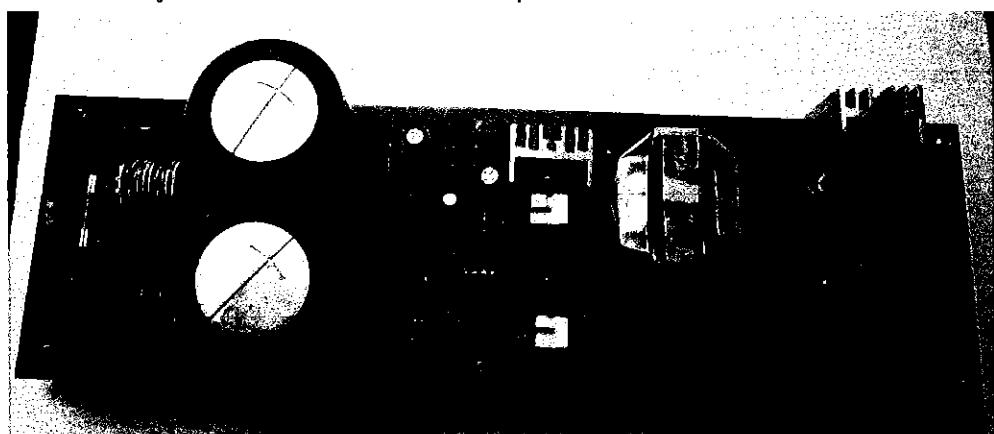
จากรูปได้ทำการวัดค่าความถี่ที่เกิดขึ้นจริงโดยการใช้ออสซิโลสโคปวัดสัญญาณที่ขา 6 และขา 4 ของไอซี UC3844 พบว่าสัญญาณมีความถี่ 50.8 กิโลเฮتزซึ่งเป็นสัญญาณความคุณการทำงานของหม้อแปลงความถี่สูงในวงจรอัคคีประจุแบบเตอร์รี่ที่รับแรงดันเข้าระหว่าง 180 - 240 โวลต์ ความถี่ 50 เฮertz เมื่อผ่านวงจรคอนเวอเรเตอร์แบบฟลัมเบกแล้วจะปรับแรงดันจากไฟสลับ (AC) ปรับเป็นไฟตรง (DC) ที่แรงดัน 310 - 325 โวลต์ ดังรูปที่ 4.11 โดยคอนเวอเรชั่นทำการกรองสัญญาณและแปลงเปลี่ยนไฟสลับ (AC) ผ่านวงจรบริดเปลี่ยนเป็นไฟตรง (DC) และปรับแรงดันด้วยตัวควบคุมเตอร์รี่ให้เป็น 310 – 325 โวลต์ เพื่อจ่ายให้หม้อแปลงความถี่สูงต่อไป



รูปที่ 4.12 ลักษณะของสัญญาณเอาต์พุตก่อนเข้าหม้อแปลง

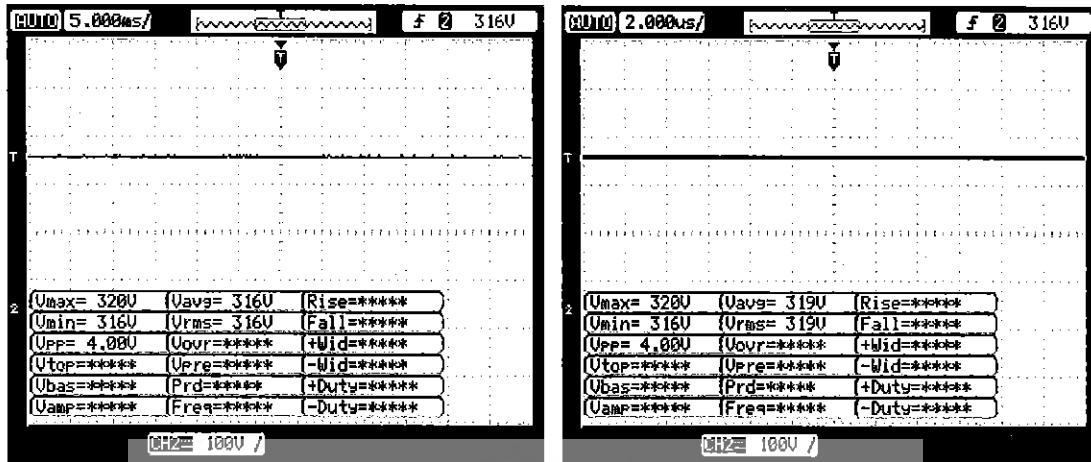
#### 4.2.1 ผลการทดสอบหม้อแปลงความถี่สูงในวงจรอัคคีประจุ

ในขั้นตอนนี้จะทำการทดสอบหม้อแปลงความถี่สูงโดยการนำหม้อแปลงตัวข้างอิจและหม้อแปลงตัวสมนรูณ์ไปประกอบกับวงจรอัคคีประจุแบบเตอร์รี่และการทดสอบค่าต่างๆ



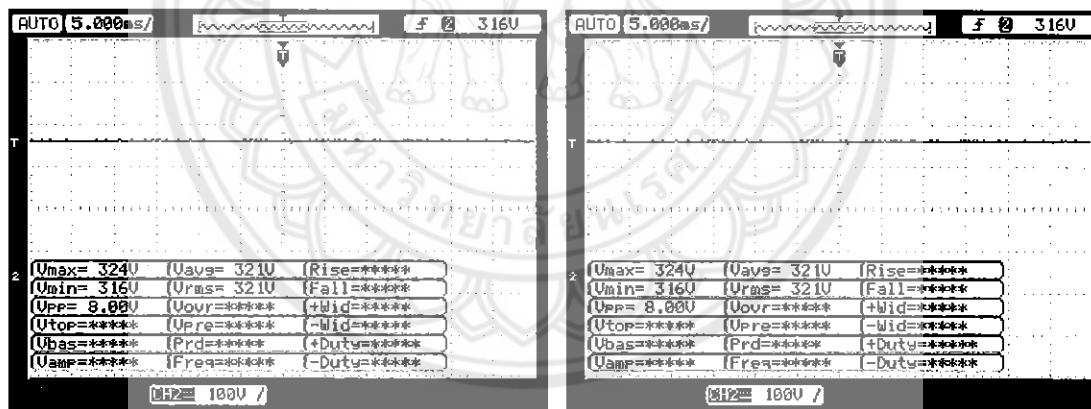
รูปที่ 4.13 ทดสอบหาค่าพารามิเตอร์หม้อแปลงหัวข้างอิจ

### เมื่อทำการทดสอบวงจรด้วยเครื่องมือและทำการวัดค่าได้ดังนี้



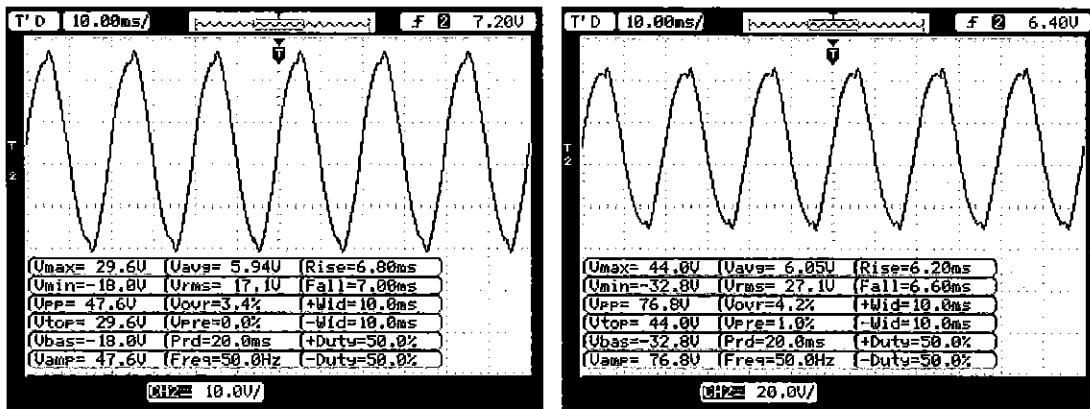
รูปที่ 4.14 ลักษณะแรงดันด้านปฐมภูมิตัวอ้างอิงและลักษณะแรงดันด้านปฐมภูมิตัวที่ออกแบบ

จากรูปเป็นลักษณะของแรงดันด้านอินพุตขาเข้าหนึ่งมือแปลงของหนึ่งมือแปลงอ้างอิงและหนึ่งมือแปลงตัวสมบูรณ์ โดยที่แรงดันอยู่ที่ 316 – 320 โวลต์ เป็นระดับแรงดันที่คอนเวอร์เตอร์จ่ายให้กับหนึ่งมือแปลงความถี่สูง



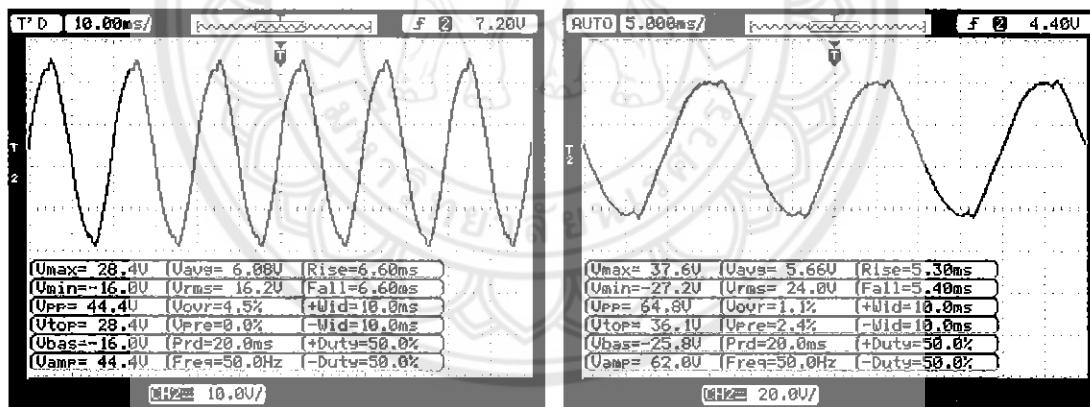
รูปที่ 4.15 ลักษณะแรงดันด้านขดลวดช่วยวัดด้านปฐมภูมิตัวอ้างอิงและตัวออกแบบ

จากรูปเป็นลักษณะของแรงดันอินพุตด้านขดลวดช่วยวัด มีแรงดันมีระดับแรงดันอยู่ในช่วงประมาณ 324 โวลต์ เท่ากันเป็นระดับแรงดันที่ส่งผ่านมาจากชุดคอนเวอร์เตอร์ที่รับไฟสลับ (AC) ที่ระดับแรงดันที่ 220 ผ่านวงจรกรอง แปลงเป็นไฟตรง (DC) ด้วยวงจรบริค และอัพแรงดันขึ้นเป็นประมาณ 315 – 320 โวลต์ ด้วยคาปิชิตเตอร์ขนาด  $2200 \mu\text{F}$  อนุกรมกัน 2 ตัว



รูปที่ 4.16 ลักษณะแรงดันค้านทุติยภูมิตัวอ้างอิงและลักษณะแรงดันค้านทุติยภูมิตัวสมบูรณ์

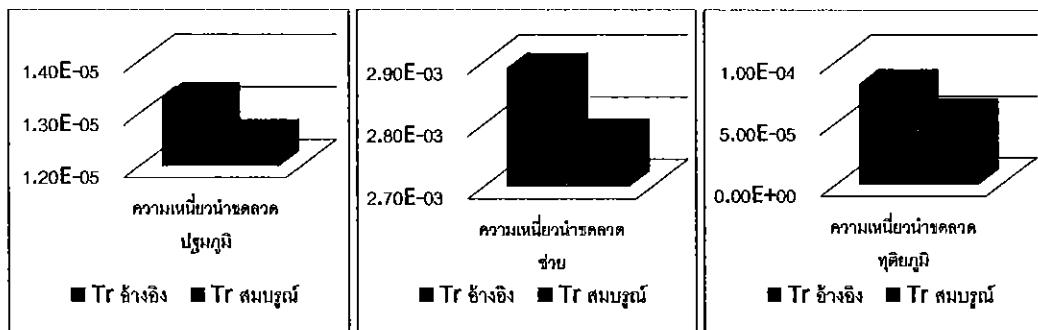
จากรูปเป็นลักษณะของสัญญาณทางค้านทุติยภูมิหลังจากที่ผ่านหน้าจอเปล่งความถี่สูงแล้ว เอาต์พุตที่ได้ของหน้าจอเปล่งหั่งสองเป็นลักษณะลูกคลื่นรายเวปที่มีค่าแรงดันไม่เท่ากันเนื่องจาก ตัวอ้างอิงมีการใช้คลื่นต่าง และรูปแบบการพันที่ต่างจากตัวสมบูรณ์ซึ่งขดคลื่นคลื่นที่ตัวอ้างอิงใช้ เมอร์ 24 จำนวน 2 เส้นประกอบกันพันรอบบนบันน์ ส่วนตัวสมบูรณ์ใช้ขดคลื่นเบอร์ 20 ที่มีขนาดใหญ่กว่าทันกระแสได้มากกว่า ทำให้มีค่าเอาต์พุตออกมากว่าไม่เท่ากัน คือ ตัวอ้างอิงมีแรงดันเอาต์พุต ออกมา 29.6 โวลต์ ส่วนตัวสมบูรณ์มีเอาต์พุตออกมา 44 โวลต์



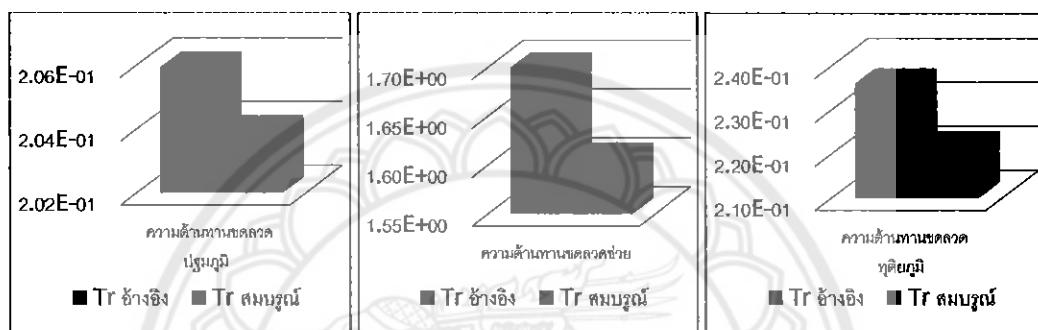
รูปที่ 4.17 ลักษณะแรงดันขาออกของวงจรอัดประจุของตัวอ้างอิงและตัวสมบูรณ์

จากรูปจะเห็นได้ว่าค่าเอาต์พุตที่ออกมาจากวงจรอัดประจุระหว่างหน้าจอเปล่งตัวอ้างอิง และหน้าจอเปล่งตัวสมบูรณ์ จะมีค่าที่ต่างกันตามแรงดันที่ออกค้านทุติยภูมิของหน้าจอเปล่งตามลำดับ โดยหน้าจอเปล่งความถี่สูงแบบฟลายแบคตัวอ้างอิง มีค่าออกมา 28.4 โวลต์ ซึ่งมีค่าระดับแรงดันที่ต่ำกว่าที่ออกแบบไว้ซึ่งไม่สามารถนำไปอัดประจุแบบเตอร์ 12 โวลต์ จำนวน 3 ก้อน ตามที่ออกแบบไว้ได้ สำหรับหน้าจอเปล่งตัวสมบูรณ์ความถี่สูงแบบฟลายมีแรงดันออกมา 37.6 โวลต์ ซึ่งเป็นระดับแรงดันที่ได้ทำการออกแบบไว้ซึ่งสามารถนำไปใช้งานอัดประจุเข้าแบตเตอรี่ 3 ก้อนได้ซึ่งแบตเตอรี่ 3 ก้อนใช้ 36 โวลต์ได้ตามที่ได้ออกแบบไว้

#### 4.2.2 การเปรียบเทียบระหว่างหน้มอแปลงตัวอ้างอิงและหน้มอแปลงตัวสมบูรณ์



(ก) เปรียบเทียบค่าความเนี่ยนนำของแต่ละขด



(ข) เปรียบเทียบค่าความด้านทานของแต่ละขด



(ค) เปรียบเทียบค่ารีแอคเคนซ์ของแต่ละขด

รูปที่ 4.18 เปรียบเทียบค่าระหว่างหน้มอแปลงอ้างอิงกับหน้มอแปลงตัวสมบูรณ์

จากราฟเปรียบเทียบค่าความเนี่ยนนำ (L) ค่าความด้านทาน (R) และค่ารีแอคเคนซ์ (XL) ของขด漉คหะหน้มอแปลงความถี่สูงระหว่างหน้มอแปลงตัวอ้างอิง ( $Tr$  อ้างอิง) กับหน้มอแปลงตัวสมบูรณ์ ( $Tr$  สมบูรณ์) แสดงเห็นว่าค่าเนี่ยนนำสูงแปลงผันตรงค่ารีแอคเคนซ์สูงตาม และในขณะที่มีค่ารีแอคเคนซ์ และค่าความด้านทานมากส่งทำให้เกิดสูญเสียในคดคามมากขึ้น ส่งทำให้ประสิทธิภาพของหน้มอแปลงลดลงด้วย ในหน้มอแปลงตัวสมบูรณ์ได้เลือกใช้คลดเบอร์ใหญ่กว่า ทำให้กระแสไฟหล่อ่านได้มากกว่า เลือกแกนเฟอร์ไรต์ที่ใหญ่กว่าทำให้มีพื้นที่ในการพั้นดคลดมากกว่าจึงเป็นผลให้หน้มอแปลงตัวสมบูรณ์เกิดความร้อนน้อยกว่าและมีประสิทธิภาพดีกว่าและยังสร้างแรงดันเอาต์พุตที่ออกมากจากวงจรนีค่าตามที่ออกแบบมากกว่า

## บทที่ 5

### สรุปผลและข้อเสนอแนะ

#### 5.1 สรุปผลการดำเนินงาน

ในโครงการเด่นนี้ได้การศึกษา สร้างและทดสอบหน้าอปอล์ฟลีบ์แบบใหม่ที่สูงในแหล่งจ่าย สวิตชิ่งแบบฟลายแบคหรือที่เรียกว่า “อีกอีบ์” หน้าอปอล์ฟลีบ์แบบใหม่ที่สูงแบบฟลายแบค จากที่ได้ทำการสร้างและทดสอบหน้าอปอล์ฟลีบ์แบบใหม่ที่สูงแบบฟลายแบคในลักษณะรูปแบบการพัฒนาต่างๆแล้วพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพของหน้าอปอล์ฟลีบ์แบบใหม่ที่สูงแบบฟลายแบคนี้ คือค่าความสูญเสียที่เกิดจากภายในคลื่นตัวนำของหน้าอปอล์ฟลีบ์แบบใหม่ที่สูงแบบฟลายแบคตามลักษณะการพัฒนาของคลื่นตัวนำภายในของหน้าอปอล์ฟลีบ์ และค่าความสูญเสียภายในแกนเหล็ก โดยการสูญเสียภายในแกนเหล็กจะมีค่าไม่สูงนัก มีการเปลี่ยนแปลงตามขนาดของแกนเหล็กดังนั้นจึงเลือกขนาดของคลื่นตัวนำที่ใหญ่เพื่อให้กระแสไฟฟ้าได้มากกว่า เลือกแกนเฟอร์ไรต์ที่ขนาดใหญ่กว่าเพื่อให้มีพื้นที่พัฒนาตัวนำมากขึ้น และทำการพัฒนาโดยมีช่องอากาศคั่นทางเดินของฟลักแม่เหล็กเพื่อป้องกันการอิ่มตัวของแกนเฟอร์ไรต์ ทั้งได้มีการพัฒนาวนระหัวงชั้นของคลื่นตัวนำเพื่อป้องกันการสัมผัสโดยตรงของคลื่นตัวนำและให้มีการระบายความร้อนด้วย

จากการทดสอบและใช้งานจริงในวงจรอัคประจุแบบพกพาแล้วพบว่า การทำงานของหน้าอปอล์ฟลีบ์แบบใหม่ที่สูงแบบฟลายแบคตัวสมบูรณ์นี้มีประสิทธิภาพสูงกว่าหน้าอปอล์ฟลีบ์แบบฟลายแบคของตัวอ้างอิงที่มีอยู่แล้ว จริงตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้ทั้งต้น

#### 5.2 ปัญหาและข้อเสนอแนะ

ไม่มีความหลากหลายมากพอในการออกแบบ เช่นในลักษณะของแบบที่มีความซับซ้อนมากฯ เพาะใช้เวลาในการสร้าง ขาดอุปกรณ์บางอย่างที่หายาก และบุญยาการทดสอบเพื่อให้ได้ผลในแต่ละขั้นตอน

ดังนี้จึงคาดหวังว่าการนำเอาโปรแกรมมาช่วยออกแบบแล้ววิเคราะห์ผลข้างต้นก่อนเพื่อให้มีความหลากหลาย ลดการใช้เวลา ลดการใช้อุปกรณ์

#### 5.3 แนวทางในการพัฒนาโครงการต่อไป

ใช้โปรแกรมช่วยในการออกแบบให้มีความหลากหลายในการออกแบบหน้าอปอล์ฟลีบ์ในลักษณะต่างๆที่มากขึ้นซับซ้อน ทั้งนี้หวังว่าจะมีการพัฒนาต่อไปในเรื่องของการออกแบบหน้าอปอล์ฟลีบ์เพื่อจะได้มีหน้าอปอล์ฟลีบ์ที่มีประสิทธิภาพสูงยิ่งๆขึ้นไปเรื่อยๆ นำไปสู่การประหยัดและการสูญเสียพลังงานมากขึ้น

## เอกสารอ้างอิง

- [1] ราช.คร.วีระเชษฐ์ ขันเงิน, วุฒิพล ชาราธีรเศรษฐ์, 2547, อิเล็กทรอนิกส์กำลัง, ห้องหุ้นส่วนจำกัด วีเจ พรีนต์ พิมพ์ครั้งที่ 1, สืบค้นเมื่อ ตุลาคม 2554
- [2] สุวัฒน์ ดั่น, 2537, เทคนิคและการออกแบบสวิตซิ่งเพาเวอร์ชัพพลาຍ, บริษัท เอ็นเกล ไทย จำกัด พิมพ์ครั้งที่ 1, สืบค้นเมื่อ ตุลาคม 2554.
- [3] นพพล หนูนาก, “ตัวอัคประจุแบบเตอร์เรียนพกพาสำหรับยานยนต์ขนาดเล็กสองล้อ”, ปริญญาในพนธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา 2552.
- [4] <http://wenku.baidu.com/view/87b9043283c4bb4cf7ecd11c.html>, สืบค้นเมื่อ เมษายน 2554
- [5] <http://wenku.baidu.com/view/8f369dd133d4b14e852468c4.html>, สืบค้นเมื่อ เมษายน 2554
- [6] <http://ecee.colorado.edu/~ecen4517/materials/flyback.pdf>, สืบค้นเมื่อ ตุลาคม 2554
- [7] <http://www.irf.com/technical-info/appnotes/an-1024.pdf>, สืบค้นเมื่อ ตุลาคม 2554
- [8] <http://wenku.baidu.com/view/b33c820d6c85ec3a87c2c50b.html>, สืบค้นเมื่อ ตุลาคม 2554
- [9] <http://www.ti.com/lit/ml/slup127/slup127.pdf>, สืบค้นเมื่อ ตุลาคม 2554
- [10] <http://www.stable.co.th/index.php?lay=show&ac=article&Id=539185370&Ntype=17>, สืบค้นเมื่อ ตุลาคม 2554



### 1) สวิตช์

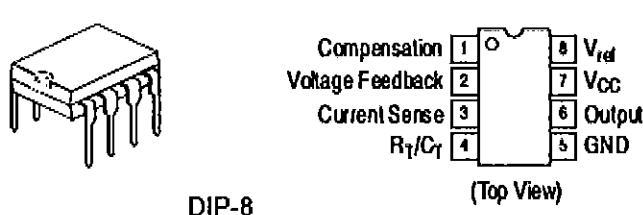
เนื่องจากคอนเวอร์เตอร์แบบฟลัตตี้แบนคนนี้คือวงจรแปลงไฟตรงที่ใช้งานกับความถี่สวิตซิ่ง ในโครงงานเลือกใช้ความถี่อยู่ในช่วง 50 - 500 กิโลเฮิรตซ์ จึงเลือกใช้มอสเฟตแทนการใช้ทรานซิสเตอร์ เพราะมอสเฟตเหมาะสมกับการใช้งานที่ความถี่สวิตซิ่งสูงเมื่อเทียบกับสวิตช์กำลังชนิดอื่น และในที่นี้เลือกใช้มอสเฟต หมายเลข FQP7N80 ซึ่งทนกระแสได้ 6.6 แอมป์ และทนแรงดันได้ 800 โวลต์ N - Channel ตัวถังเป็นแบบ TO - 220



รูปที่ ก.1 ลักษณะมอสเฟตและขาต่างๆ [3]

### 2) วงจรสร้างสัญญาณควบคุมสวิตช์

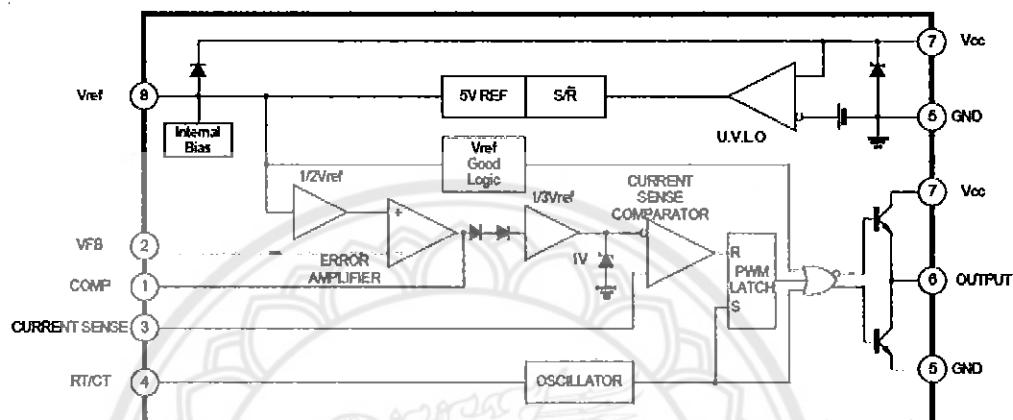
ในโครงงานนี้ สวิตช์จะถูกควบคุมด้วยสัญญาณที่สร้างมาจากไอซี (Integrated Circuit, IC) หมายเลข UC3844 (ดูรูปที่ ก.1) ซึ่งใช้งานง่าย และเป็นไอซีที่ใช้ควบคุมในโหมดกระแสด้วย และมีข้อดีคือ ใช้กระแสเริ่มต้นต่ำ 0.5 มิลลิแอมป์ และสามารถทำงานที่ความถี่สูงถึง 500 กิโลเฮิรตซ์ ต้องการไฟเลี้ยง 16 โวลต์ มีค่าดิวตี้ไซเคิลสูงสุด 50% เหมาะสำหรับใช้งานในโหมดกระแสไม่ต่อเนื่อง



รูปที่ ก.2 ลักษณะไอซีและขาต่างๆ ของ UC3844 [3]

หลักการทำงานของ UC3844 แสดงในรูปที่ ก.2 โดยจะรับแรงดันด้านเข้าทางขาที่ 7 และรับค่าแรงดันอ้างอิง 5 โวลต์ ทางขาที่ 8 และมีการต่อสายคินออกทางขาที่ 5 ภายในไอซีจะมีวงจรการ模ดูเล็ตความกว้างพัลส์ (Pulse - width modulation, PWM) เพื่อรับสัญญาณต่างๆ มาประมวลผลแล้วสร้างเป็นสัญญาณพัลส์ก่อนที่จะส่งสัญญาณออกทางขาที่ 6 เพื่อใช้ในการควบคุม mosfet

BLOCK DIAGRAM

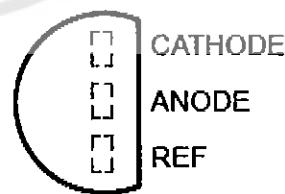
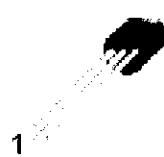


รูปที่ ก.3 วงจรภายในของ ไอซี UC3844 [3]

3) อุปกรณ์ที่ใช้จรวจควบคุมแรงดันและกระแส

ในโครงงานนี้เลือกใช้ไอซีเบอร์ TL431 เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ควบคุมแรงดันและกระแสตัวถังเป็นแบบ TO - 92 ซึ่งจะประกอบด้วยขาทั้งหมด 3 ขา คือ ขาเอโนด ขาแคโทด และขาอ้างอิง

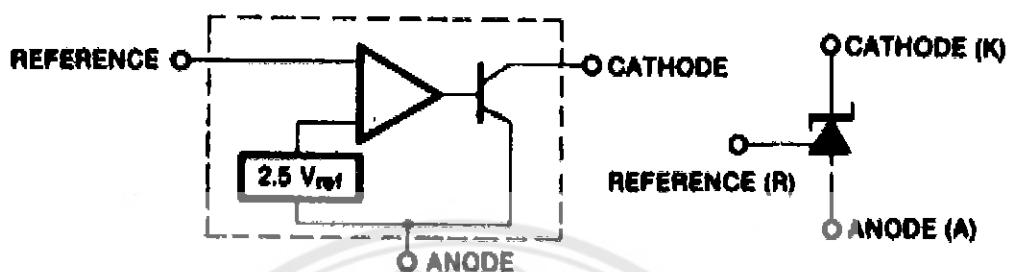
TO-92



1. Ref 2. Anode 3. Cathode

รูปที่ ก.4 ลักษณะไอซีและขาต่างๆ ของ TL431 [3]

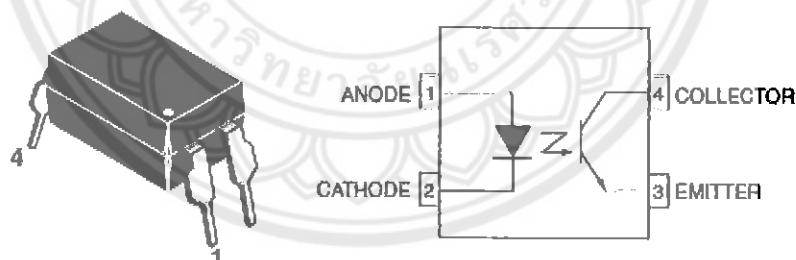
ด้วยผลการทำงานค้ายกับจีเนอร์ไคโอด แต่แตกต่างกันตรงที่ TL431 จะทำงานเมื่อได้รับแรงดัน 2.5 โวลต์ป้อนเข้าที่ขาอ้างอิง เมื่อมีแรงดันป้อนเข้าที่ขาอ้างอิงถึง 2.5 โวลต์ จะทำให้กระแสสามารถไหลจากขั้วแคทโอดไปแอโนดได้ จากการทำงานดังกล่าวจึงสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในส่วนของการควบคุมแรงดันและกระแสได้



รูปที่ ก.5 วงจรภายในและสัญลักษณ์ของ TL431 [3]

4) อุปกรณ์ที่ใช้ในการส่งสัญญาณระหว่างอินพุตและเอาต์พุต

อุปกรณ์ที่ใช้ในการส่งสัญญาณระหว่างอินพุตและเอาต์พุต มีหน้าที่ทำให้เกิดการแยกกันทางไฟฟ้า (Isolated) เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งาน ในโครงการนี้เลือกใช้ออชี FOD817

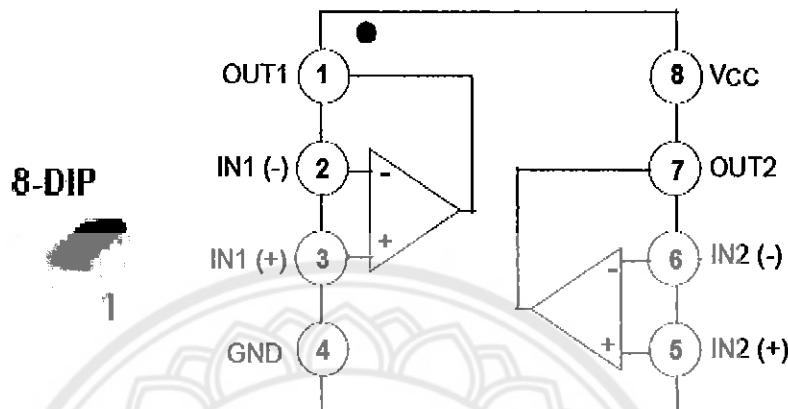


รูปที่ ก.6 สัญลักษณ์ไอซีและวงจรภายในของ FOD817 [3]

ไอซี FOD817 ประกอบด้วยขาทั้งหมด 4 ขา ภายในของ FOD817 จะประกอบไปด้วยไฟฟ้าทรานซิสเตอร์และไคโอดเปล่งแสง มีหลักการทำงานคือ ไฟฟ้าทรานซิสเตอร์จะนำกระแสมากน้อยขึ้นอยู่กับความเข้มแสงที่ถูกปล่อยออกจากไคโอดเปล่งแสง ส่วนแสงที่ถูกปล่อยออกมายังไคโอดเปล่งแสงจะเข้ากับปริมาณกระแสที่ไอล์ฟ่านไคโอดเปล่งแสง ถ้ามีกระแสไฟฟ่านำไปด้วย

### 5) อุปกรณ์ที่ใช้ในการขยายสัญญาณ

เนื่องจากวงจรควบคุมกระแสใช้ตัวต้านทาน (R Sense) ที่มีความต้านทานต่ำมาก ทำให้สัญญาณที่ส่งมาเพื่อควบคุม TL431 มีค่าน้อยมาก ดังนั้นเพื่อการขยายสัญญาณให้ได้ตามที่ต้องการ จึงใช้อปแอมป์ (Operational Amplifier) เพื่อขยายสัญญาณ ซึ่งอปแอมป์ที่เลือกใช้คือ LM358

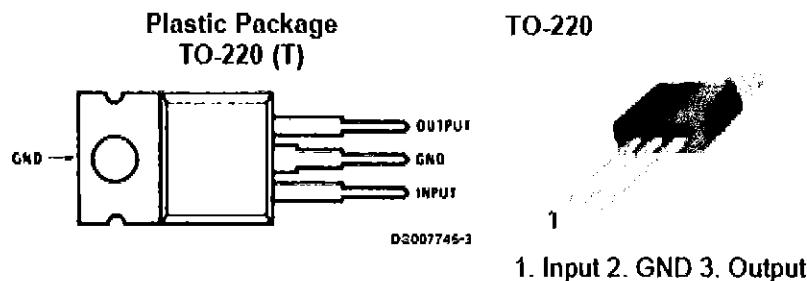


รูปที่ ก.7 ลักษณะไอซีและวงจรภายในของ LM358 [3]

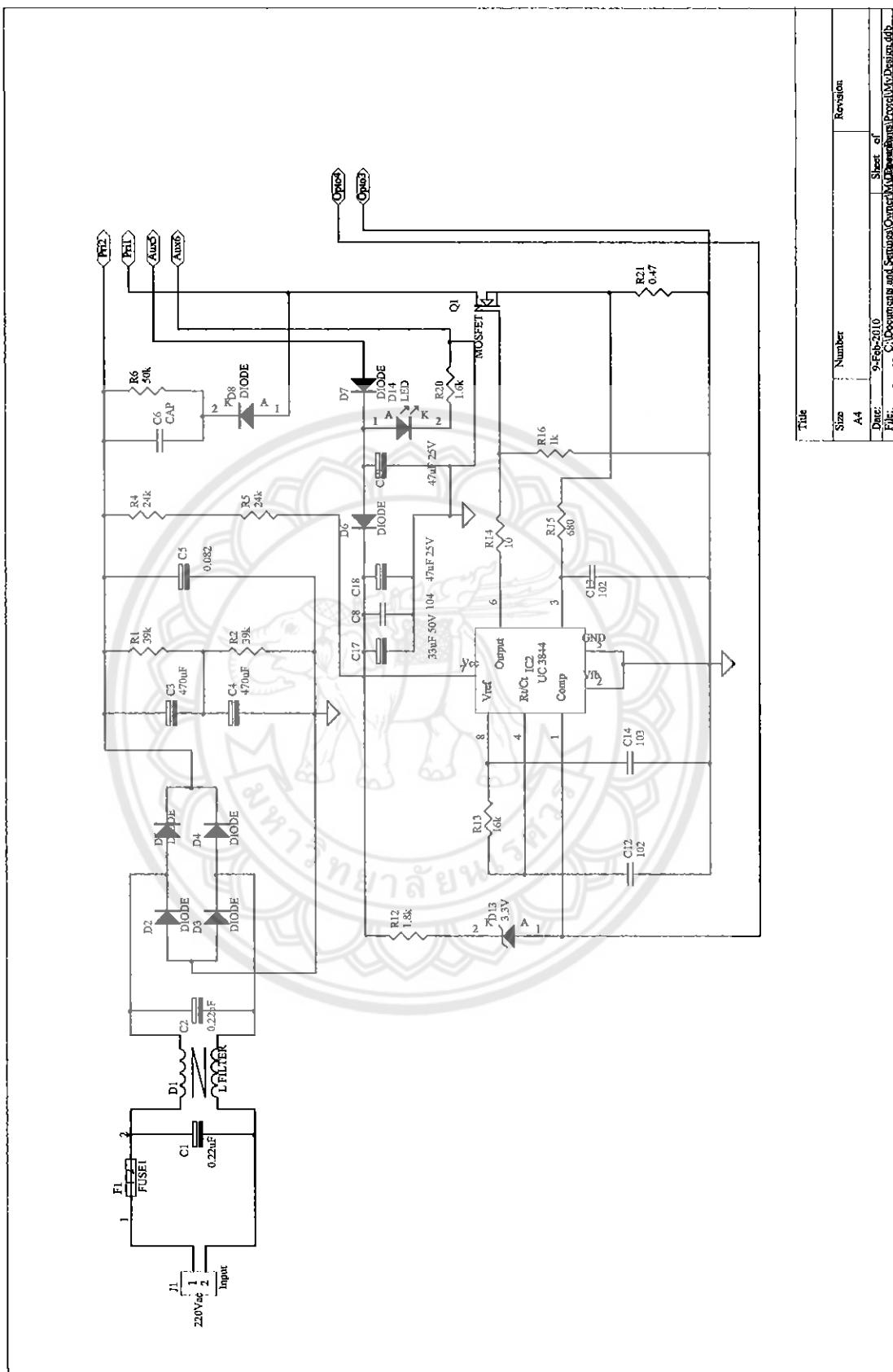
อปแอมป์เบอร์ LM358 เป็นอปแอมป์ที่สามารถใช้ไฟเลี้ยงได้ตั้งแต่ 3 - 32 โวลต์ ซึ่งเป็นอปแอมป์ที่ใช้ไฟเลี้ยงเป็นไฟบวกเพียงอย่างเดียวเท่านั้น ภายในประกอบด้วยอปแอมป์จำนวนสองชุด ข้ออินพุตสามารถรับค่าแรงดันได้ตั้งแต่ 0.3 - 32 โวลต์

### 6) อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรกุเลทรังดัน (Voltage Regulator)

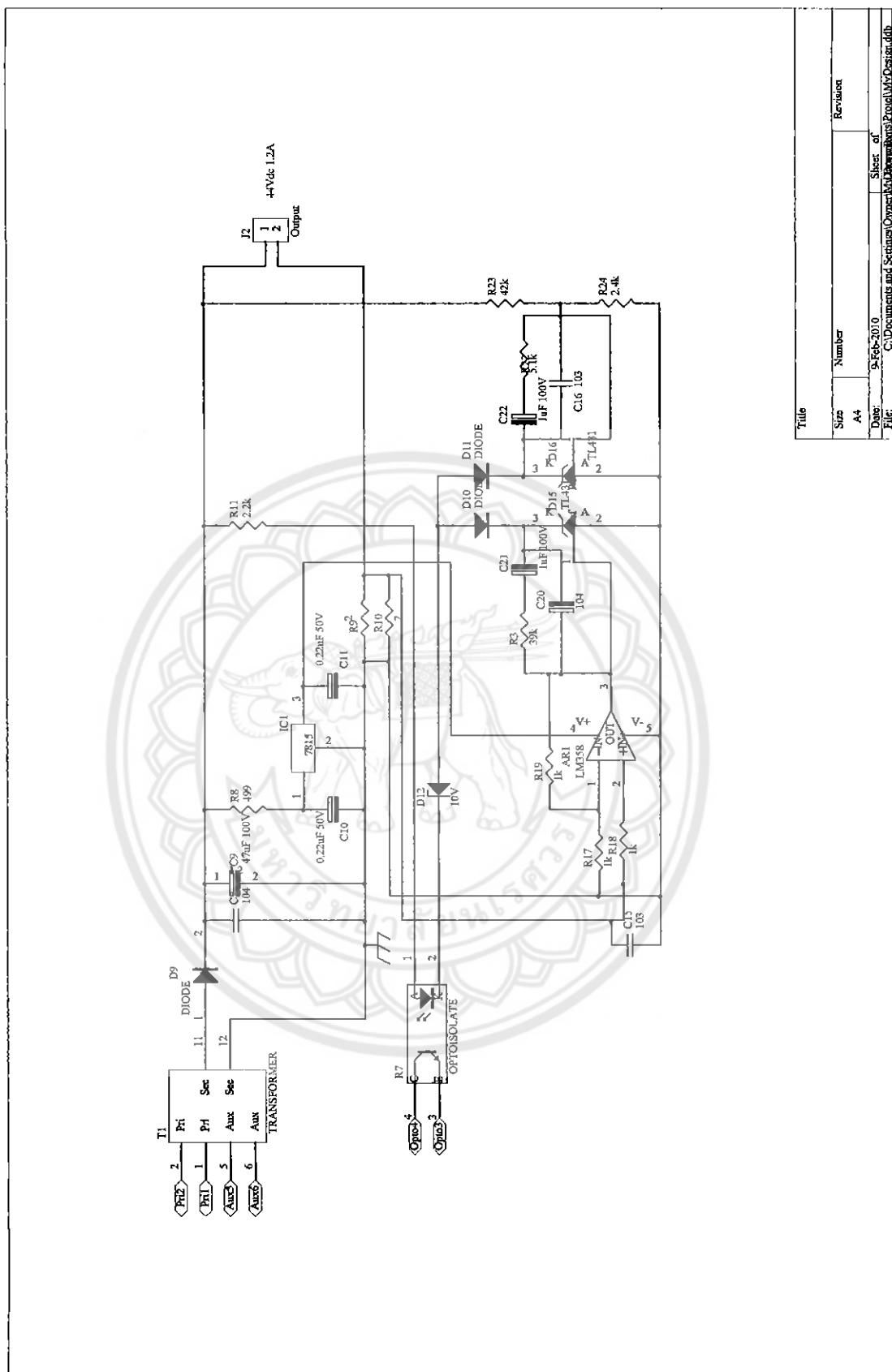
เนื่องจากต้องการไฟเลี้ยงไปจ่ายให้อปแอมป์ 15 โวลต์ จึงต้องมีการเรกุเลทรังดันเพื่อนำมาใช้เป็นไฟเลี้ยงอปแอมป์ ดังนั้นจึงเลือกใช้ไอซี 7815 ตัวถังแบบ TO - 220 ซึ่งเป็นไอซีที่ใช้งานง่าย สามารถเรกุเลตจากแรงดันอินพุตในช่วง 17.7 - 35 โวลต์และสามารถจ่ายกระแสได้สูงสุด 1 แอมป์ ให้อาต์พุตออกม 15 โวลต์ ไอซีประกอบด้วยขาทั้ง 3 ขา ได้แก่ อินพุต เอาต์พุต และกราว์ด



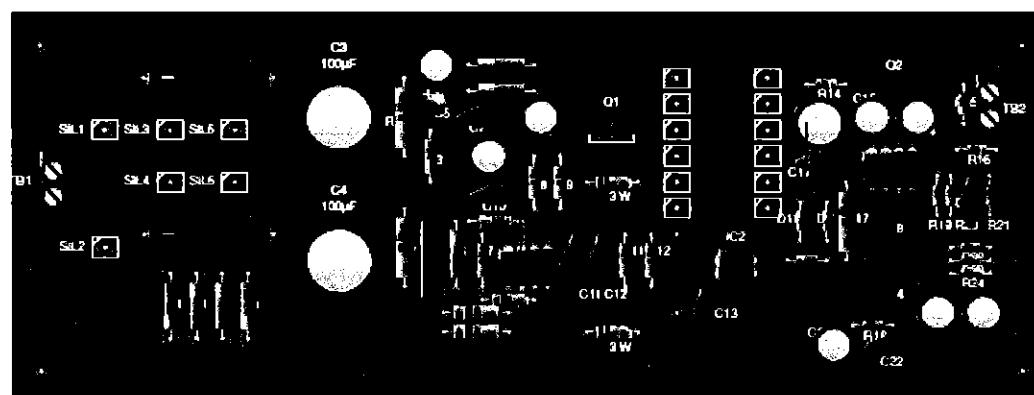
รูปที่ ก 3.8 ลักษณะไอซีและขาต่างๆ ของ 7815 [3]



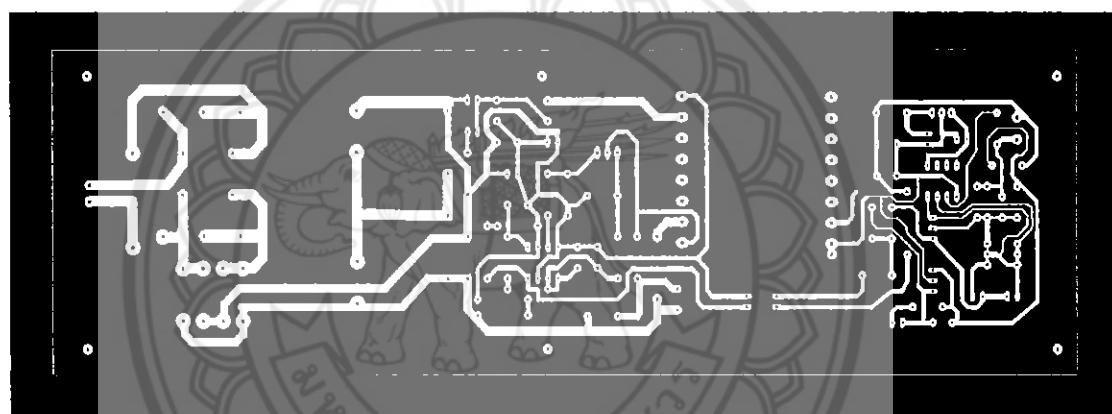
รูปที่ ก.10 วงจรอัดประจุส่วนอินพุต [3]



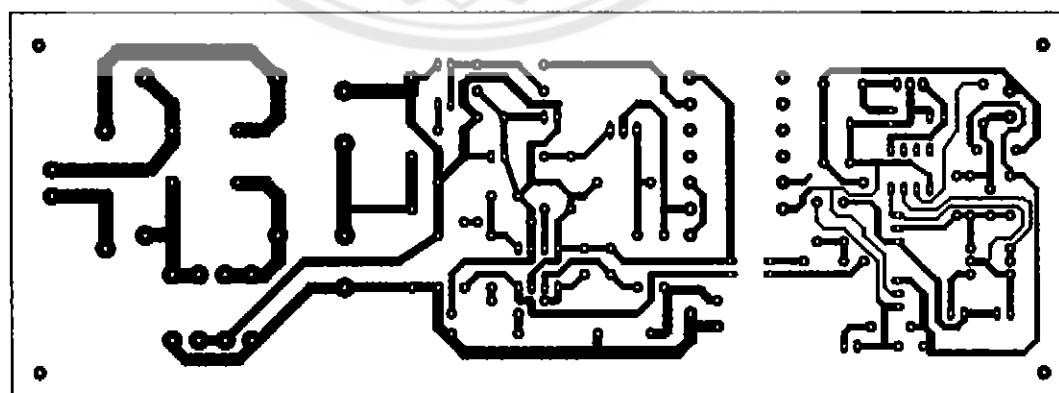
รูปที่ ก.11 วงจรอัคปะจุส่วนเอาต์พุต [3]



ก) ผังวงจรอัคประจุฟลายแบค



ข) ล่ายพิมพ์วงจรอัคประจุ



ค) ล่ายพิมพ์วงจรอัคประจุ

รูปที่ ก.12 ล่ายพิมพ์วงจรอัคประจุ





[www.fairchildsemi.com](http://www.fairchildsemi.com)

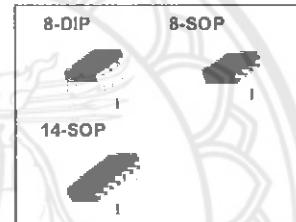
## UC3842/UC3843/UC3844/UC3845 SMPS Controller

### Features

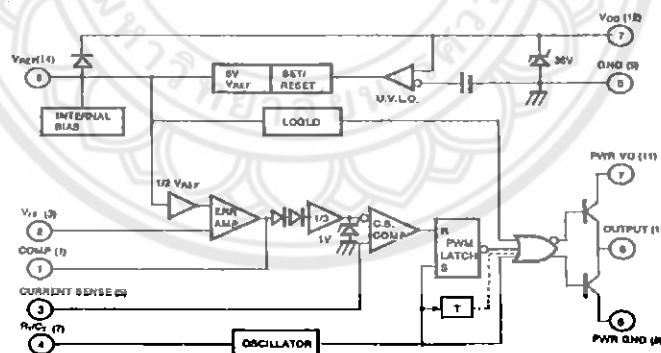
- Low Start up Current
- Maximum Duty Clamp
- UVLO With Hysteresis
- Operating Frequency up to 500KHz

### Description

The UC3842/UC3843/UC3844/UC3845 are fixed frequency current-mode PWM controller. They are specially designed for Off-Line and DC to DC converter applications with minimum external components. These integrated circuits feature a trimmed oscillator for precise duty cycle control, a temperature compensated reference, high gain error amplifier, current sensing comparator and a high current totempole output for driving a Power MOSFET. The UC3842 and UC3844 have UVLO thresholds of 16V (on) and 10V (off). The UC3843 and UC3845 are 8.5V(on) and 7.9V (off). The UC3842 and UC3843 can operate within 100% duty cycle. The UC3844 and UC3845 can operate with 50% duty cycle.



### Internal Block Diagram



\* NORMALLY 8DIP/8SOP PIN NO.  
\*(1) IS 14SOP PIN NO.  
\* TOGGLE FLIP FLOP USED ONLY IN UC3844, UC3845

Rev. 1.0.1

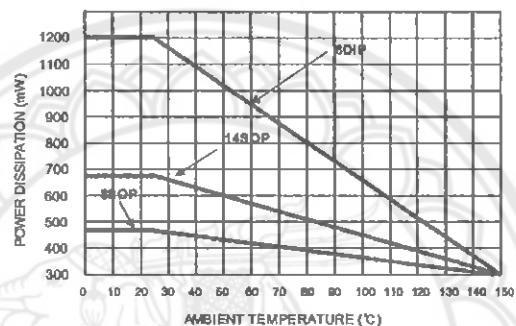
UC3842/UC3843/UC3844/UC3845

**Absolute Maximum Ratings**

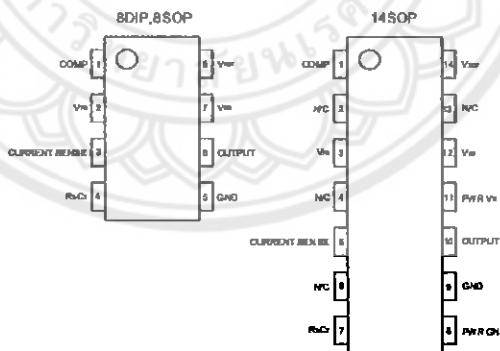
Parameter	Symbol	Value	Unit
Supply Voltage	VCC	30	V
Output Current	IO	$\pm 1$	A
Analog Inputs (Pin 2,3)	V(ANA)	-0.3 to 6.3	V
Error Amp Output Sink Current	ISINK (E.A)	10	mA
Power Dissipation at TA≤25°C (8DIP)	PD(Note1,2)	1200	mW
Power Dissipation at TA≤25°C (8SOP)	PD(Note1,2)	460	mW
Power Dissipation at TA≤25°C (14SOP)	PD(Note1,2)	680	mW
Storage Temperature Range	TSTG	-65 ~ +150	°C
Lead Temperature (Soldering, 10sec)	TLEAD	+300	°C

**Note:**

1. Board Thickness 1.6mm, Board Dimension 76.2mm × 114.3mm, (Reference EIA / JSED51-3, 51-7)
2. Do not exceed PD and SOA (Safe Operation Area)

**Power Dissipation Curve****Thermal Data**

Characteristic	Symbol	8-DIP	8-SOP	14-SOP	Unit
Thermal Resistance Junction-ambient	Rth(j-amb)(MAX)	100	265	180	°C/W

**Pin Array**

### Electrical Characteristics

(V<sub>CC</sub>=15V, R<sub>T</sub>=10kΩ, C<sub>T</sub>=3.3nF, T<sub>A</sub>= 0°C to +70°C, unless otherwise specified)

Parameter	Symbol	Conditions	Min.	Typ.	Max.	Unit
<b>REFERENCE SECTION</b>						
Reference Output Voltage	V <sub>REF</sub>	T <sub>J</sub> = 25°C, I <sub>REF</sub> = 1mA	4.90	5.00	5.10	V
Line Regulation	ΔV <sub>REF</sub>	12V ≤ V <sub>CC</sub> ≤ 25V	-	6	20	mV
Load Regulation	ΔV <sub>REF</sub>	1mA ≤ I <sub>REF</sub> ≤ 20mA	-	6	25	mV
Short Circuit Output Current	I <sub>SC</sub>	T <sub>A</sub> = 25°C	-	-100	-180	mA
<b>OSCILLATOR SECTION</b>						
Oscillation Frequency	f	T <sub>J</sub> = 25°C	47	52	57	KHz
Frequency Change with Voltage	Δf/ΔV <sub>CC</sub>	12V ≤ V <sub>CC</sub> ≤ 25V	-	0.05	1	%
Oscillator Amplitude	V <sub>OSC</sub>	-	-	1.6	-	V <sub>P-P</sub>
<b>ERROR AMPLIFIER SECTION</b>						
Input Bias Current	I <sub>BIAS</sub>	-	-	-0.1	-2	μA
Input Voltage	V <sub>I(E&gt;A)</sub>	V <sub>pin1</sub> = 2.5V	2.42	2.50	2.58	V
Open Loop Voltage Gain	G <sub>VO</sub>	2V ≤ V <sub>O</sub> ≤ 4V (Note 3)	65	90	-	dB
Power Supply Rejection Ratio	PSRR	12V ≤ V <sub>CC</sub> ≤ 25V (Note 3)	60	70	-	dB
Output Sink Current	I <sub>SINK</sub>	V <sub>pin2</sub> = 2.7V, V <sub>pin1</sub> = 1.1V	2	7	-	mA
Output Source Current	I <sub>SOURCE</sub>	V <sub>pin2</sub> = 2.3V, V <sub>pin1</sub> = 5V	-0.6	-1.0	-	mA
High Output Voltage	V <sub>OH</sub>	V <sub>pin2</sub> = 2.3V, R <sub>L</sub> = 15kΩ to GND	5	6	-	V
Low Output Voltage	V <sub>OL</sub>	V <sub>pin2</sub> = 2.7V, R <sub>L</sub> = 15kΩ to Pin 8	-	0.8	1.1	V
<b>CURRENT SENSE SECTION</b>						
Gain	G <sub>V</sub>	(Note 1 & 2)	2.85	3	3.15	V/V
Maximum Input Signal	V <sub>I(MAX)</sub>	V <sub>pin1</sub> = 5V (Note 1)	0.9	1	1.1	V
Power Supply Rejection Ratio	PSRR	12V ≤ V <sub>CC</sub> ≤ 25V (Note 1,3)	-	70	-	dB
Input Bias Current	I <sub>BIAS</sub>	-	-	-3	-10	μA
<b>OUTPUT SECTION</b>						
Low Output Voltage	V <sub>OL</sub>	I <sub>SINK</sub> = 20mA	-	0.08	0.4	V
		I <sub>SINK</sub> = 200mA	-	1.4	2.2	V
High Output Voltage	V <sub>OH</sub>	I <sub>SOURCE</sub> = 20mA	13	13.5	-	V
		I <sub>SOURCE</sub> = 200mA	12	13.0	-	V
Rise Time	t <sub>R</sub>	T <sub>J</sub> = 25°C, C <sub>L</sub> = 1nF (Note 3)	-	45	150	ns
Fall Time	t <sub>F</sub>	T <sub>J</sub> = 25°C, C <sub>L</sub> = 1nF (Note 3)	-	35	150	ns
<b>UNDER-VOLTAGE LOCKOUT SECTION</b>						
Start Threshold	V <sub>TH(ST)</sub>	UC3842/UC3844	14.5	16.0	17.5	V
		UC3843/UC3845	7.8	8.4	9.0	V
Min. Operating Voltage (After Turn On)	V <sub>OPR(MIN)</sub>	UC3842/UC3844	8.5	10.0	11.5	V
		UC3843/UC3844	7.0	7.6	8.2	V

UC3842/UC3843/UC3844/UC3845

**Electrical Characteristics (Continued)**(V<sub>CC</sub>=15V, R<sub>T</sub>=10kΩ, C<sub>T</sub>=3.3nF, TA= 0°C to +70°C, unless otherwise specified)

Parameter	Symbol	Conditions	Min.	Typ.	Max.	Unit
<b>PWM SECTION</b>						
Max. Duty Cycle	D <sub>(Max)</sub>	UC3842/UC3843	95	97	100	%
	D <sub>(Max)</sub>	UC3844/UC3845	47	48	50	%
Min. Duty Cycle	D <sub>(MIN)</sub>	-	-	-	0	%
<b>TOTAL STANDBY CURRENT</b>						
Start-Up Current	I <sub>ST</sub>	-	-	0.45	1	mA
Operating Supply Current	I <sub>CC(OVR)</sub>	V <sub>pin3</sub> =V <sub>pin2</sub> =ON	-	14	17	mA
Zener Voltage	V <sub>Z</sub>	I <sub>CC</sub> = 25mA	30	38	-	V

Adjust V<sub>CC</sub> above the start threshold before setting at 15V**Note:**

1. Parameter measured at trip point of latch

2. Gain defined as:

$$A = \frac{\Delta V_{pin1}}{\Delta V_{pin3}}, 0 \leq V_{pin3} \leq 0.8V$$

3. These parameters, although guaranteed, are not 100% tested in production.

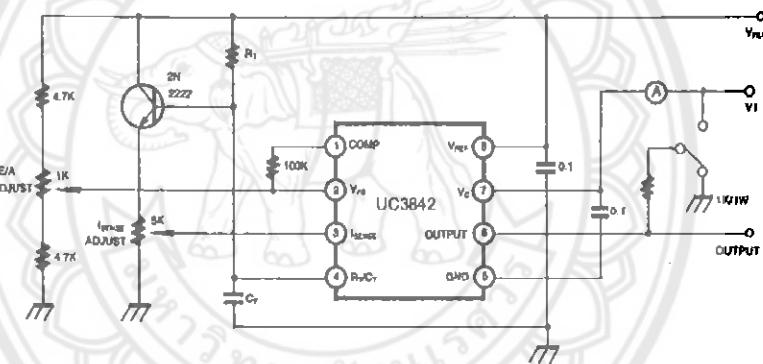


Figure 1. Open Loop Test Circuit

High peak currents associated with capacitive loads necessitate careful grounding techniques. Timing and bypass capacitors should be connected close to pin 5 in a single point ground. The transistor and 5kΩ potentiometer are used to sample the oscillator waveform and apply an adjustable ramp to pin 3.



ภัคพนวก ๔

รายละเอียดของไอซี UC3844 ในวงจรอัดประจุ

FQP7N80C/FQPF7N80C

**FAIRCHILD**  
SEMICONDUCTOR®

**QFET™****FQP7N80C/FQPF7N80C**

800V N-Channel MOSFET

**General Description**

These N-Channel enhancement mode power field effect transistors are produced using Fairchild's proprietary, planar stripe, DMOS technology.

This advanced technology has been especially tailored to minimize on-state resistance, provide superior switching performance, and withstand high energy pulse in the avalanche and commutation mode. These devices are well suited for high efficiency switch mode power supplies.

**Features**

- 6.6A, 800V,  $R_{DS(on)} = 1.9\Omega$  @  $V_{GS} = 10\text{ V}$
- Low gate charge ( typical 27 nC)
- Low Crss ( typical 10 pF)
- Fast switching
- 100% avalanche tested
- Improved dv/dt capability

G D S  
TO-220  
FQP SeriesG D S  
TO-220F  
FQPF Series**Absolute Maximum Ratings**  $T_C = 25^\circ\text{C}$  unless otherwise noted

Symbol	Parameter	FQP7N80C	FQPF7N80C	Units
$V_{DSS}$	Drain-Source Voltage	800		V
$I_D$	Drain Current	8.6	8.6 *	A
	- Continuous ( $T_C = 25^\circ\text{C}$ )			
	- Continuous ( $T_C = 100^\circ\text{C}$ )	4.2	4.2 *	A
$I_{DM}$	Drain Current	26.4	26.4 *	A
$V_{GSS}$	Gate-Source Voltage		$\pm 30$	V
$E_{AS}$	Single Pulsed Avalanche Energy	580		mJ
$I_{AR}$	Avalanche Current	6.8		A
$E_{AR}$	Repetitive Avalanche Energy	16.7		mJ
$dv/dt$	Peak Diode Recovery $dv/dt$	4.5		V/ns
$P_D$	Power Dissipation ( $T_C = 25^\circ\text{C}$ )	167	58	W
	- Derate above $25^\circ\text{C}$	1.33	0.44	W/ $^\circ\text{C}$
$T_J, T_{STG}$	Operating and Storage Temperature Range	-55 to +150		$^\circ\text{C}$
$T_L$	Maximum lead temperature for soldering purposes, 1/8" from case for 5 seconds	300		$^\circ\text{C}$

\* Drain current limited by maximum junction temperature.

**Thermal Characteristics**

Symbol	Parameter	FQP7N80C	FQPF7N80C	Units
$R_{\theta JC}$	Thermal Resistance, Junction-to-Case	0.75	2.25	$^\circ\text{C}/\text{W}$
$R_{\theta JS}$	Thermal Resistance, Case-to-Sink Typ.	0.5	--	$^\circ\text{C}/\text{W}$
$R_{\theta JA}$	Thermal Resistance, Junction-to-Ambient	62.5	62.5	$^\circ\text{C}/\text{W}$

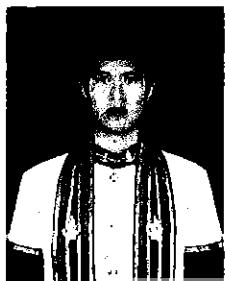
**Electrical Characteristics** $T_C = 25^\circ\text{C}$  unless otherwise noted

Symbol	Parameter	Test Conditions	Min	Typ	Max	Units	
<b>Off Characteristics</b>							
$\text{BV}_{\text{DSS}}$	Drain-Source Breakdown Voltage	$V_{GS} = 0 \text{ V}, I_D = 250 \mu\text{A}$	800	--	--	V	
$\Delta \text{BV}_{\text{DSS}} / \Delta T_J$	Breakdown Voltage Temperature Coefficient	$I_D = 250 \mu\text{A}$ , Referenced to $25^\circ\text{C}$	--	0.93	--	$\text{V}/^\circ\text{C}$	
$I_{\text{DSS}}$	Zero Gate Voltage Drain Current	$V_{DS} = 800 \text{ V}, V_{GS} = 0 \text{ V}$	--	--	10	$\mu\text{A}$	
		$V_{DS} = 840 \text{ V}, T_C = 125^\circ\text{C}$	--	--	100	$\mu\text{A}$	
$I_{\text{GSSF}}$	Gate-Body Leakage Current, Forward	$V_{GS} = 30 \text{ V}, V_{DS} = 0 \text{ V}$	--	--	100	nA	
$I_{\text{GSSR}}$	Gate-Body Leakage Current, Reverse	$V_{GS} = -30 \text{ V}, V_{DS} = 0 \text{ V}$	--	--	-100	nA	
<b>On Characteristics</b>							
$V_{GS(\text{th})}$	Gate Threshold Voltage	$V_{DS} = V_{GS}, I_D = 250 \mu\text{A}$	3.0	--	5.0	V	
$R_{DS(\text{on})}$	Static Drain-Source On-Resistance	$V_{GS} = 10 \text{ V}, I_D = 3.3 \text{ A}$	--	1.57	1.9	$\Omega$	
$g_{FS}$	Forward Transconductance	$V_{DS} = 50 \text{ V}, I_D = 3.3 \text{ A}$ (Note 4)	--	5.6	--	S	
<b>Dynamic Characteristics</b>							
$C_{iss}$	Input Capacitance	$V_{DS} = 25 \text{ V}, V_{GS} = 0 \text{ V}, f = 1.0 \text{ MHz}$	--	1290	1680	pF	
$C_{oss}$	Output Capacitance		--	120	165	pF	
$C_{rss}$	Reverse Transfer Capacitance		--	10	13	pF	
<b>Switching Characteristics</b>							
$t_{d(on)}$	Turn-On Delay Time	$V_{DD} = 400 \text{ V}, I_D = 6.6 \text{ A}, R_G = 25 \Omega$	--	35	80	ns	
$t_r$	Turn-On Rise Time		--	100	210	ns	
$t_{d(off)}$	Turn-Off Delay Time		--	50	110	ns	
$t_f$	Turn-Off Fall Time		--	60	130	ns	
$Q_g$	Total Gate Charge	$V_{DS} = 640 \text{ V}, I_D = 6.6 \text{ A}, V_{GS} = 10 \text{ V}$	--	27	35	nC	
$Q_{gs}$	Gate-Source Charge		--	8.2	--	nC	
$Q_{gd}$	Gate-Drain Charge		(Note 4, 5)	--	11	--	nC
<b>Drain-Source Diode Characteristics and Maximum Ratings</b>							
$I_S$	Maximum Continuous Drain-Source Diode Forward Current		--	--	6.6	A	
$I_{SM}$	Maximum Pulsed Drain-Source Diode Forward Current		--	--	26.4	A	
$V_{SD}$	Drain-Source Diode Forward Voltage	$V_{GS} = 0 \text{ V}, I_S = 6.6 \text{ A}$	--	--	1.4	V	
$t_{rr}$	Reverse Recovery Time	$V_{GS} = 0 \text{ V}, I_S = 6.6 \text{ A}, dI_F/dt = 100 \text{ A}/\mu\text{s}$	--	850	--	ns	
$Q_{rr}$	Reverse Recovery Charge		(Note 4)	--	7.0	$\mu\text{C}$	

**Notes:**

1. Repetitive Rating : Pulse width limited by maximum junction temperature
2.  $L = 25\text{mH}, I_{AS} = 6.6\text{A}, V_{DD} = 50\text{V}, R_G = 25 \Omega$ , Starting  $T_J = 25^\circ\text{C}$
3.  $I_{SD} \leq 8\text{A}, dI/dt \leq 200\text{A}/\mu\text{s}, V_{DD} \leq 8V_{DSS}$ , Starting  $T_J = 25^\circ\text{C}$
4. Pulse Test: Pulse width  $\leq 300\mu\text{s}$ , Duty cycle  $\leq 2\%$
5. Essentially independent of operating temperature

## ประวัติผู้ดำเนินโครงการ



ชื่อ นายปรัมินทร์ ตีอคำ<sup>๕</sup>  
ภูมิลำเนา 125 หมู่ 8 ต.ลำปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลำปาง  
ประวัติการศึกษา

- จบระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนมัธยมวิทยา
- ปัจจุบันกำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4  
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยนเรศวร

E-mail: Poramin\_prise@hotmail.com



ชื่อ นายอนุรักษ์ เมืองวงศ์<sup>๖</sup>  
ภูมิลำเนา 189 หมู่ 9 ต.บ้านต้า อ.เมือง จ.พะเยา  
ประวัติการศึกษา

- จบระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนพะเยาประสาณวิทย์
- ปัจจุบันกำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4  
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยนเรศวร

E-mail: anurak.eexv@hotmail.com